

Corso di Percezione Robotica (PRo)

Modulo C. Percezione Attiva

Il tatto in robotica

Cecilia Laschi
ARTS Lab, Scuola Superiore Sant'Anna
cecilia@arts.sssup.it
050-883486



Sommario della lezione

- Principali tecnologie per la realizzazione di sensori tattili artificiali:
 - principi di funzionamento e relazioni matematiche
 - esempi di realizzazione di sensori tattili
- Esempio di progettazione biomeccatronica di un sensore tattile per una mano robotica
- Esplorazione tattile

Riferimenti bibliografici:

Russel, "Robot Tactile Sensing", Prentice Hall

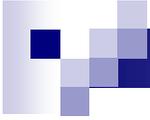


Sommario della lezione

- **Principali tecnologie per la realizzazione di sensori tattili artificiali:**
 - principi di funzionamento e relazioni matematiche
 - esempi di realizzazione di sensori tattili
- Esempio di progettazione biomeccatronica di un sensore tattile per una mano robotica
- Esplorazione tattile

Riferimenti bibliografici:

Russel, "Robot Tactile Sensing", Prentice Hall



Sensori di contatto e sensori tattili

- Sensori di contatto:
forniscono informazione binaria sul contatto rilevato sulla superficie del sensore
- Sensori tattili:
forniscono informazione sulla forza applicata sulla superficie del sensore
 - solo intensità, lungo direzione normale
 - intensità e direzione (2 o 3 componenti del vettore forza)
- Entrambi i tipi possono essere organizzati in array (o matrici) per fornire immagini del contatto o immagini tattili

Proprietà fondamentali di un sensore artificiale



- FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
- CALIBRAZIONE (TARATURA)
- LINEARITÀ
- ISTERESI
- ACCURATEZZA
- RIPETIBILITÀ
- RISOLUZIONE
- SENSIBILITÀ
- SENSIBILITÀ AL RUMORE
- VITA UTILE
- STABILITÀ

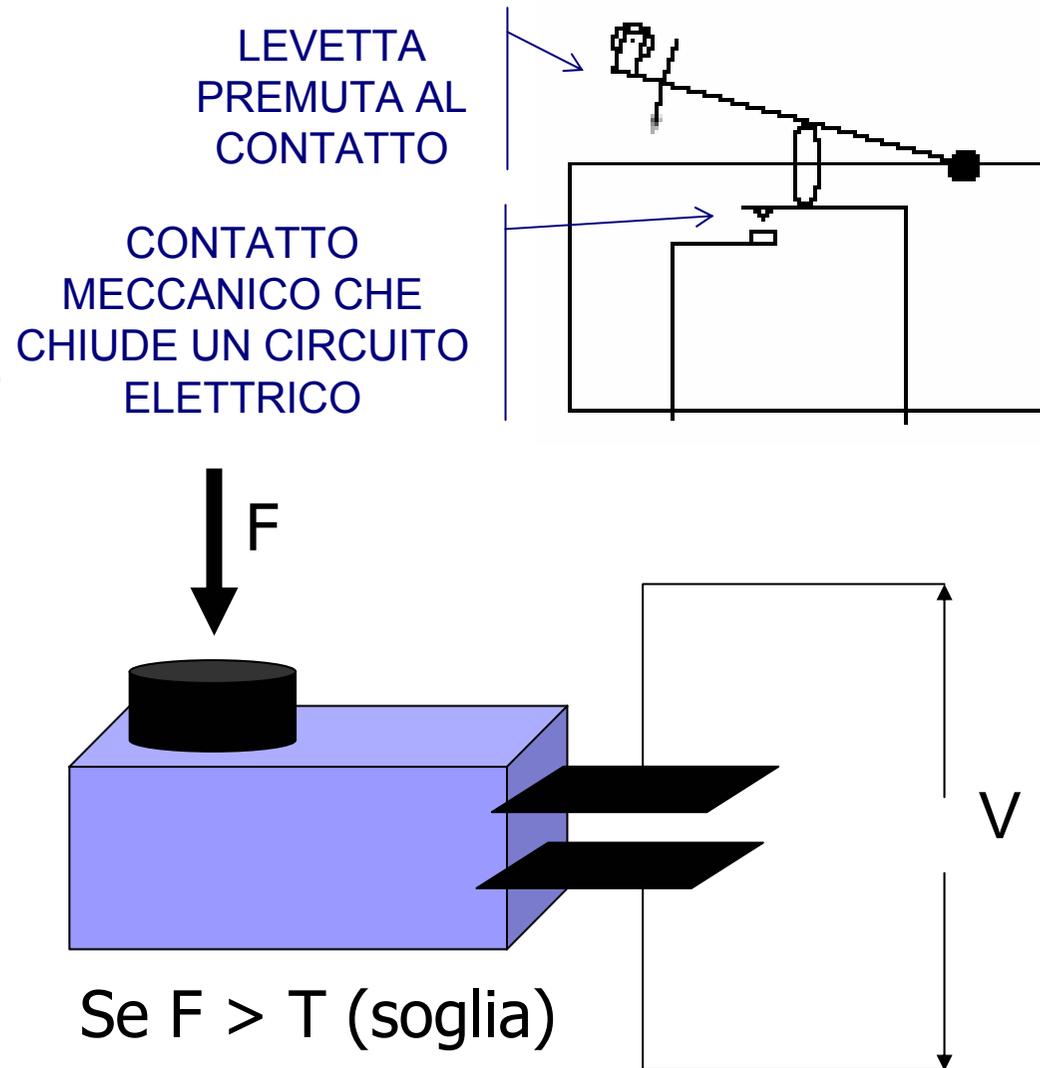


Principali tecnologie

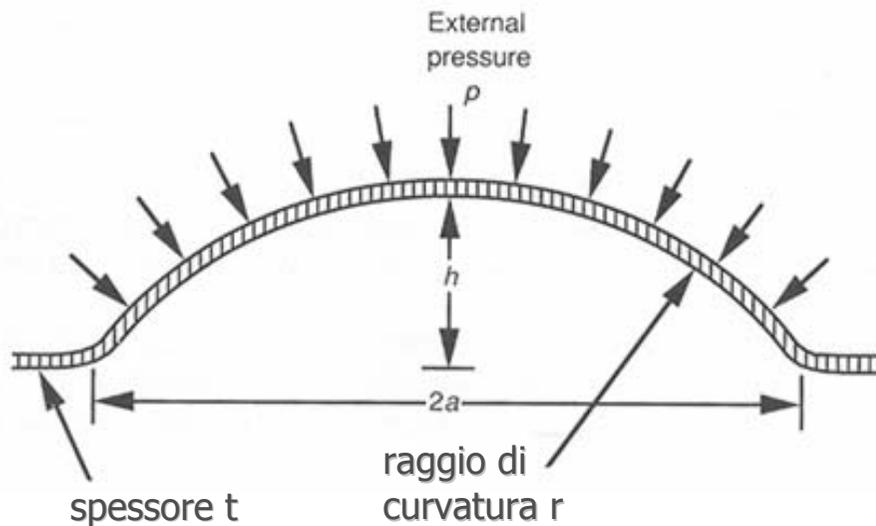
- Sensori meccanici: switch come sensori tattili
- Sensori piezoresistivi
- Sensori ottici
- Sensori magnetici
- Sensori capacitivi
- Sensori FSR
- Sensori QTC

Switch meccanici

- Sensori di contatto più semplici
- Forniscono un solo dato binario: contatto / non contatto
- Applicazioni come sensori tattili:
 - sensori di impatto su robot mobili
 - whisker
 - sensori di fine corsa per i giunti di un manipolatore



Switch a deflessione



Sfolla metallica
 Deformazione elastica, che causa la chiusura di un circuito elettrico
 Risposta binaria alla pressione applicata

Dalla teoria delle deflessioni elastiche:
 Parametro geometrico λ

$$\lambda^2 = \frac{a^2}{t \cdot r} \sqrt{12(1-\nu^2)}$$

Parametro di carico R

$$R = \frac{p}{E} \left(\frac{a}{t} \right)^4 (1-\nu^2)$$

con

p = pressione applicata

E = modulo di Young del materiale metallico

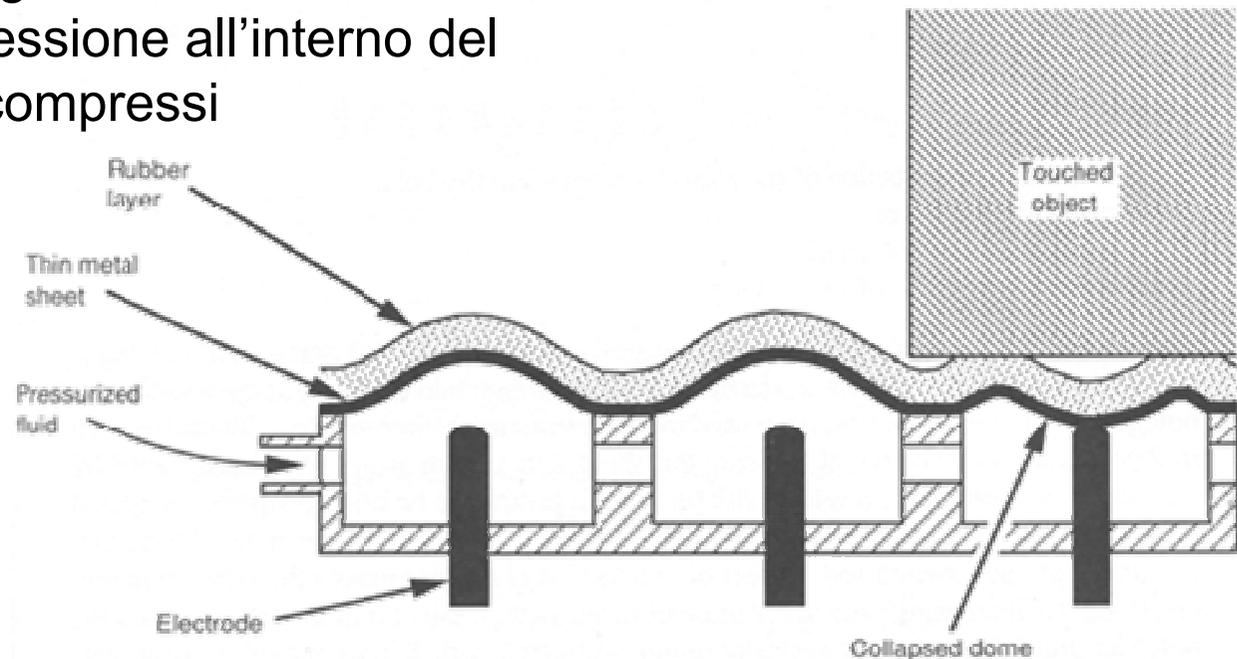
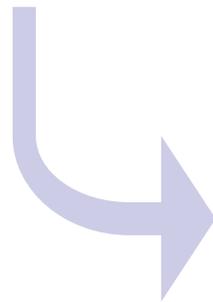
ν = rapporto di Poisson del materiale metallico

Relazione tra il parametro geometrico λ e il corrispondente parametrico di carico critico R_{cr} , oltre il quale si ha la deflessione

λ	2,08	3	3,5	4	5	6
R_{cr}	2,46	4,1	8	14	33	77

Sensore di contatto pneumatico

- 100 unità disposte a matrice
- Spaziatura: 2,54 mm
- Variazione della soglia di contatto attraverso l'applicazione di pressione all'interno del sensore con fluidi compressi



Alcuni svantaggi:

- bassa risoluzione spaziale
- eventuali forze trasversali non vengono rilevate come tali e inoltre possono ridurre la deflessione
- sfoglie di metallo soggette a rottura
- output binario

Sensore tattile digitale

Un array con una densità elevata di switch con soglie di contatto diverse potrebbe misurare la pressione applicata.

La profondità massima che può raggiungere una sfoglia metallica sottoposta a pressione all'interno di un foro circolare è data da:

$$\delta \propto \frac{pa}{E}$$

con:

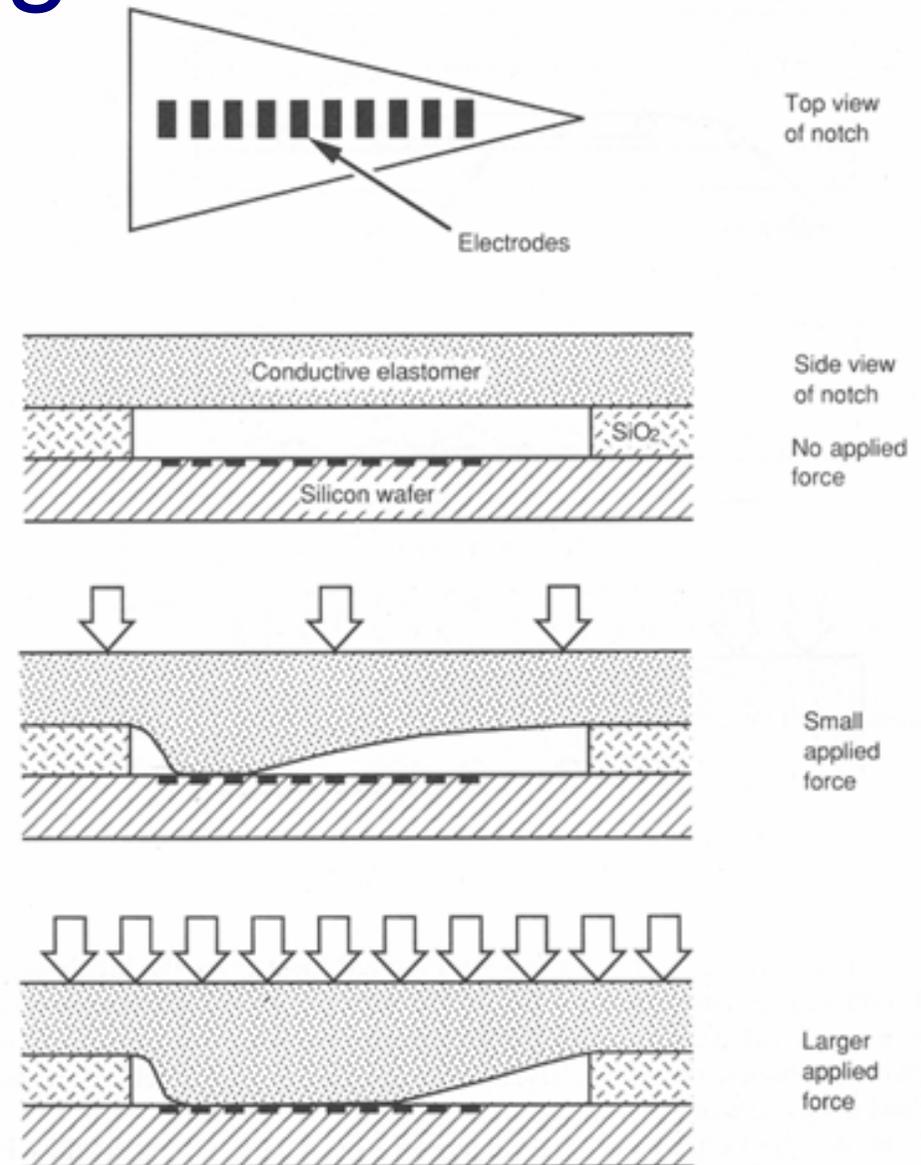
δ = massima deflessione

p = pressione applicata

a = raggio del foro

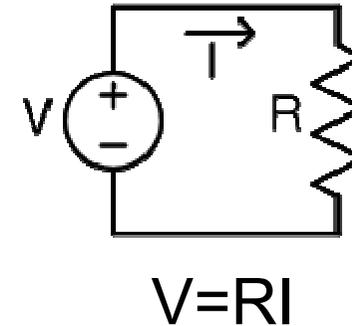
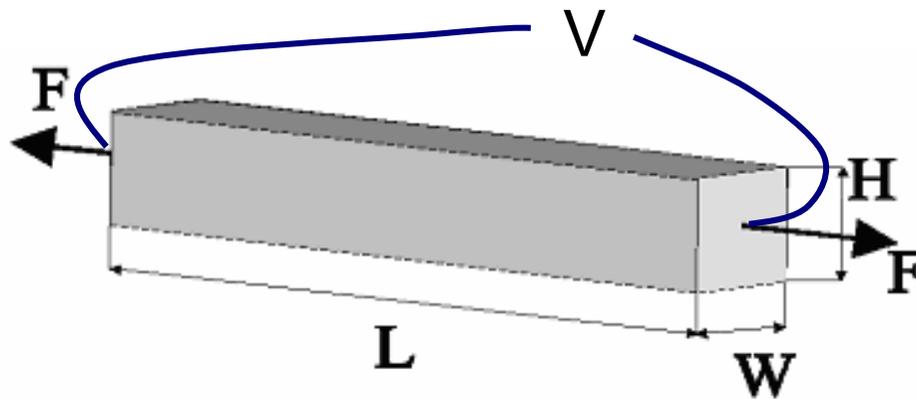
E = modulo di Young

- 48 unità
- area di ogni unità: 0,3 x 0,6 mm
- 15 elettrodi per ottenere 16 livelli di pressione
- variando la forma del foro si possono ottenere risposte lineari, logaritmiche o esponenziali



Effetto piezoresistivo

Ogni materiale varia la propria resistenza elettrica in funzione della **deformazione**



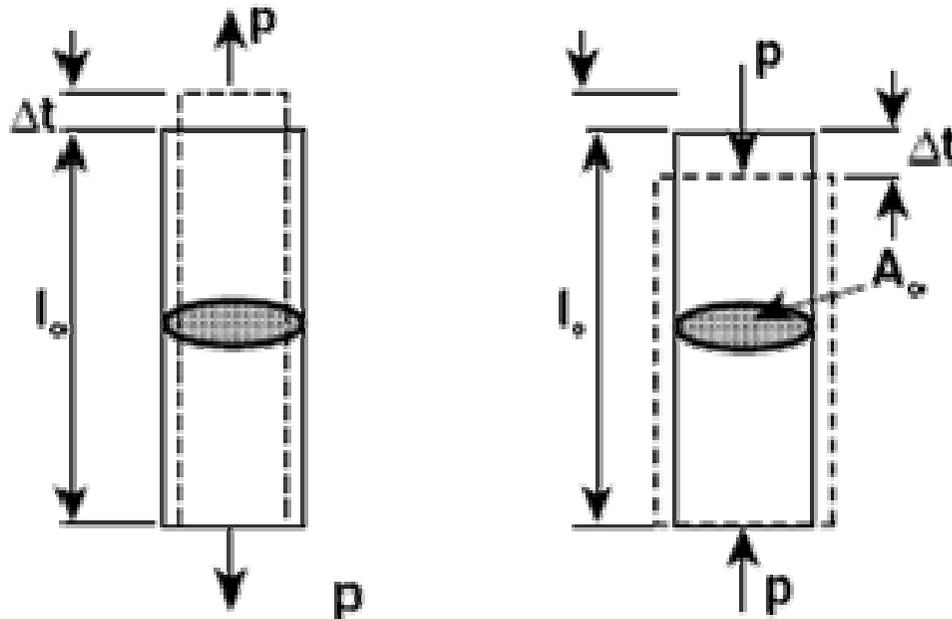
In un parallelepipedo metallico: $R = \rho \frac{L}{WH}$
con ρ = resistività del materiale,
 L, W, H = dimensioni del parallelepipedo

$$\frac{\Delta R}{R} = \varepsilon + 2\nu\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$

ν = rapporto di Poisson del materiale

Richiami di comportamento meccanico dei materiali

Un materiale sottoposto a uno sforzo si deforma con comportamento elastico fino a una soglia dello sforzo (limite elastico), oltre la quale si deforma plasticamente



sforzo

$$\sigma = P / A_0$$

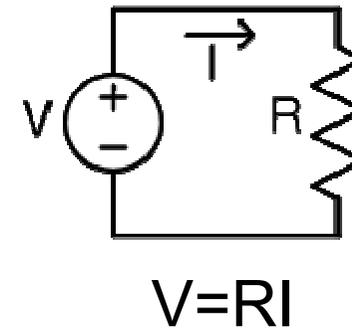
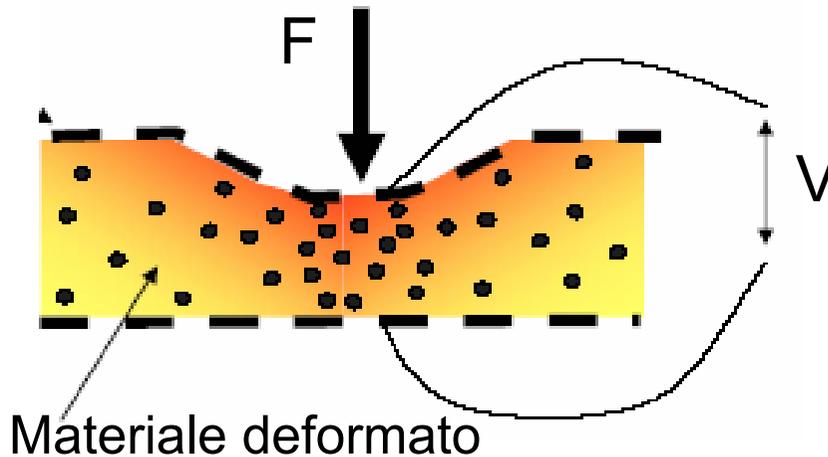
deformazione

$$\varepsilon = \Delta l / l_0$$

Rapporto di Poisson: $\nu = -\frac{\delta A / A_0}{\varepsilon}$ Modulo di elasticità: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

Effetto piezoresistivo

Ogni materiale varia la propria resistenza elettrica in funzione della **deformazione**

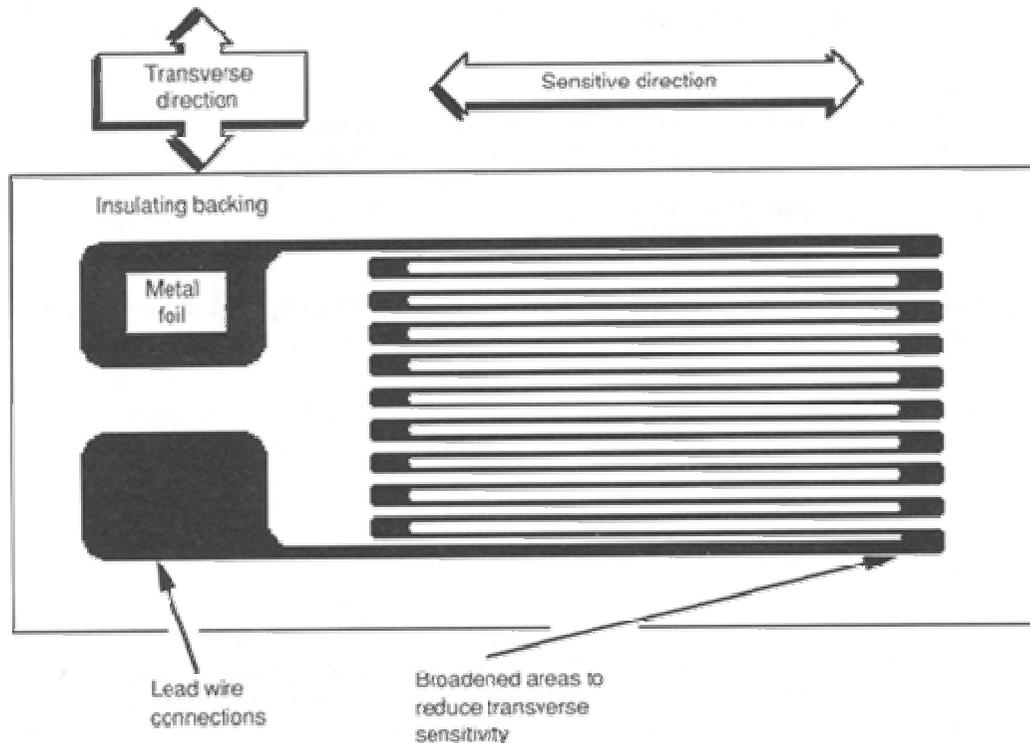


In un parallelepipedo metallico: $R = \rho \frac{l}{wt}$
con ρ = resistività del materiale,
 l , w , t = dimensioni del parallelepipedo

$$\frac{\Delta R}{R} = \varepsilon + 2\nu\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$

ν = rapporto di Poisson del materiale

Strain gauge

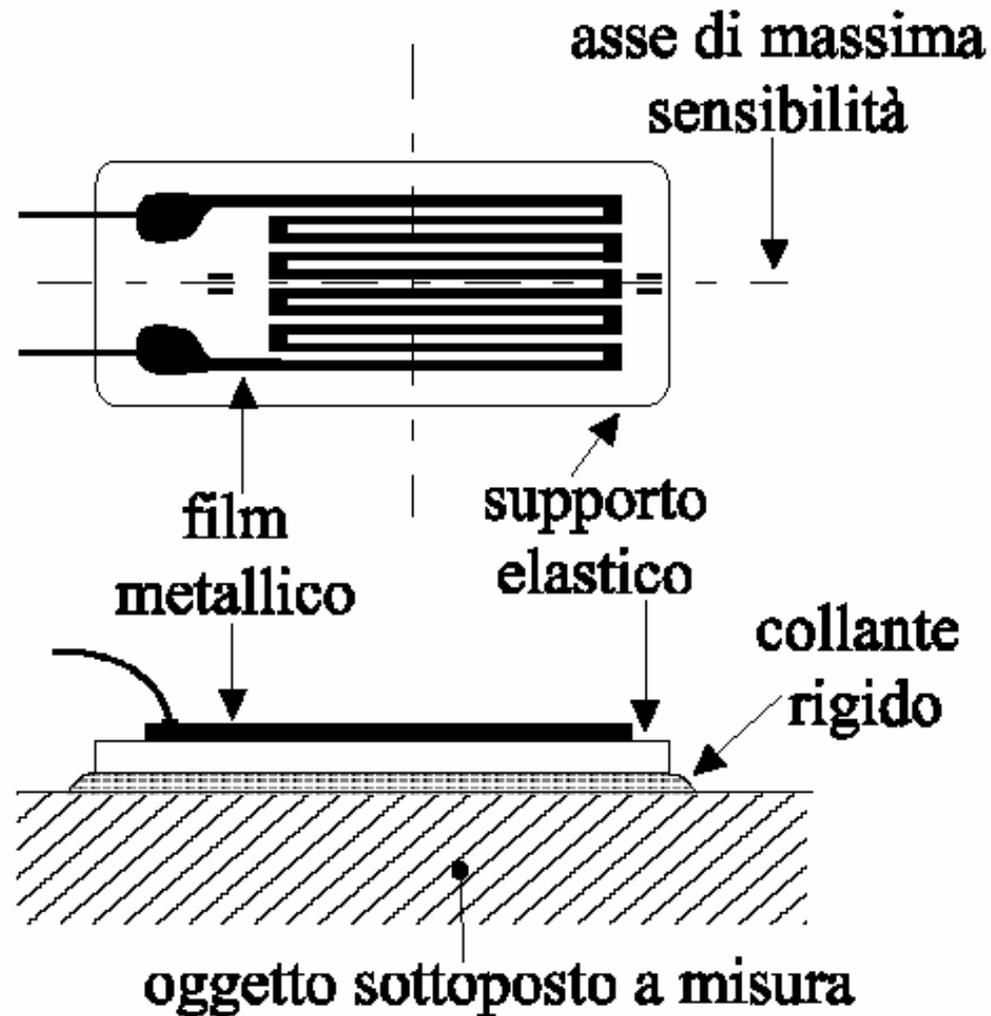


La forma del sensore serve a renderlo più sensibile in una direzione che nell'altra

Fattore di Gauge:
$$G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = 1 + 2\nu + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

ν = rapporto di Poisson del materiale

Strain gauge



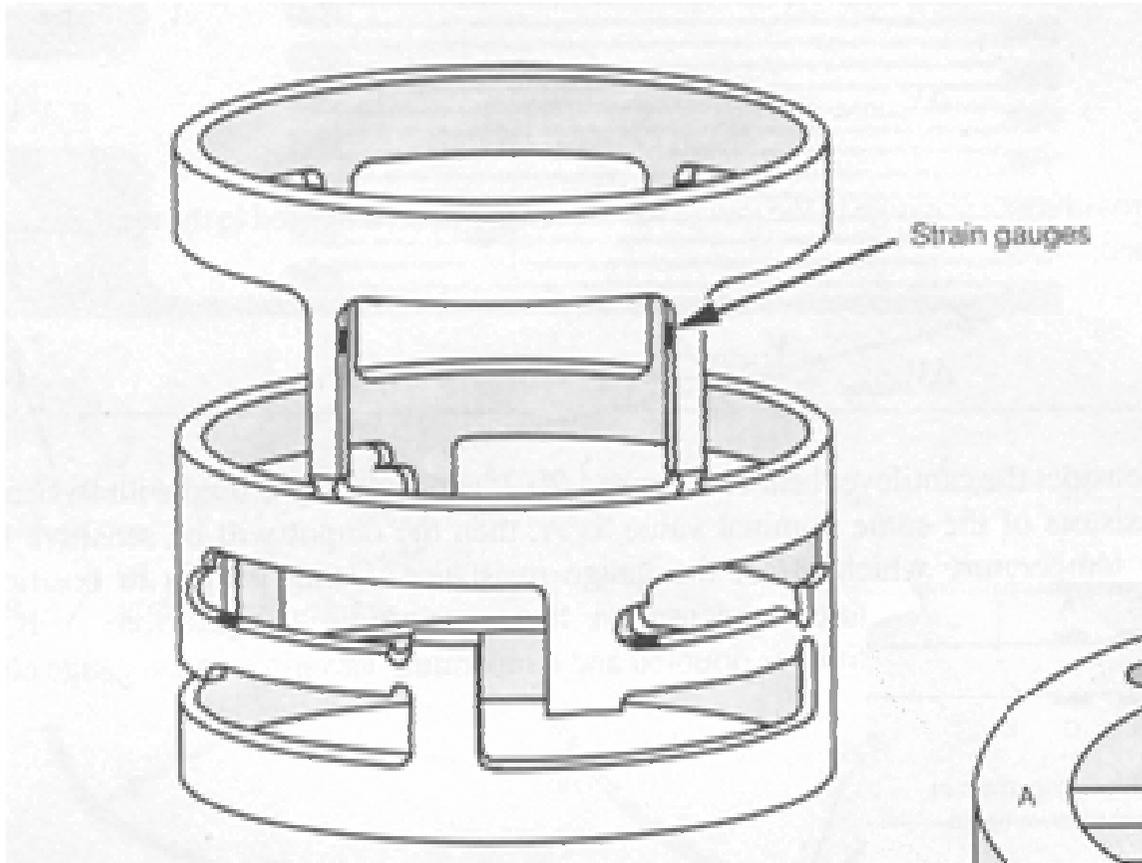
La forma del dispositivo serve a renderlo più sensibile in una direzione che nell'altra

Fattore di Gauge:

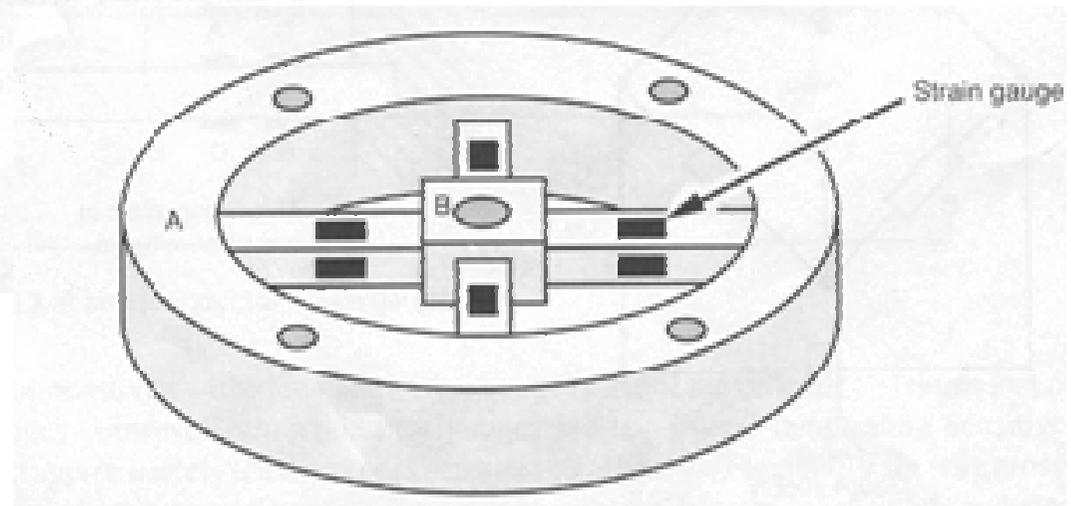
$$G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = 1 + 2\nu + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

ν = rapporto di Poisson del materiale

Sensori di forza/coppia a 3 componenti



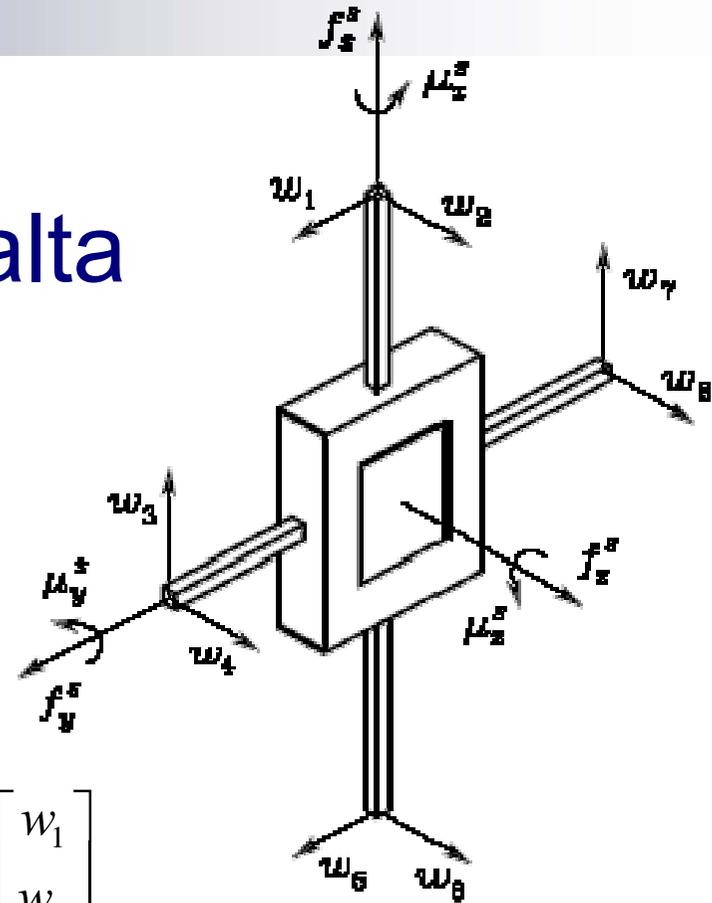
- Strutture meccaniche con direzioni di deformazione preferenziali, date da indebolimenti, su 3 assi
- Strain gauge disposti sugli indebolimenti



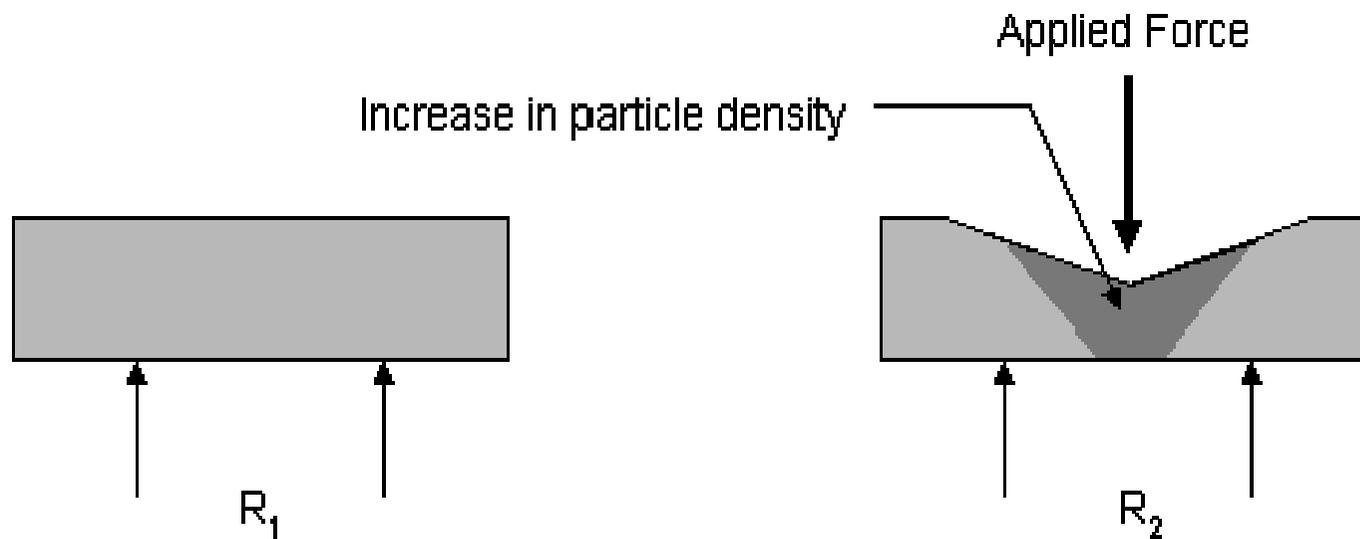
Sensore triassiale di forza/coppia a croce di Malta

- Le forze e le coppie vengono misurate a partire dalle misure delle variazioni di resistenza degli strain gauge, moltiplicandole per una matrice di coefficienti tipica del sensore
- La matrice dei coefficienti si costruisce con una procedura di calibrazione in cui si applicano forze note

$$\begin{bmatrix} f_x^s \\ f_y^s \\ f_z^s \\ \mu_x^s \\ \mu_y^s \\ \mu_z^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{13} & 0 & 0 & 0 & c_{17} & 0 \\ c_{21} & 0 & 0 & 0 & c_{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{32} & 0 & c_{34} & 0 & c_{36} & 0 & c_{38} \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 & c_{48} \\ 0 & c_{52} & 0 & 0 & 0 & c_{56} & 0 & 0 \\ c_{61} & 0 & c_{63} & 0 & c_{65} & 0 & c_{67} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \\ w_6 \\ w_7 \\ w_8 \end{bmatrix}$$

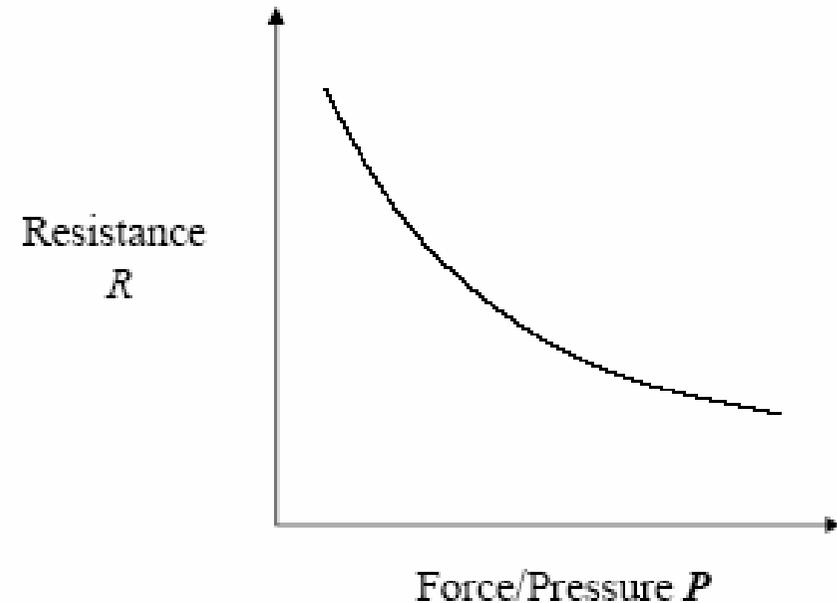
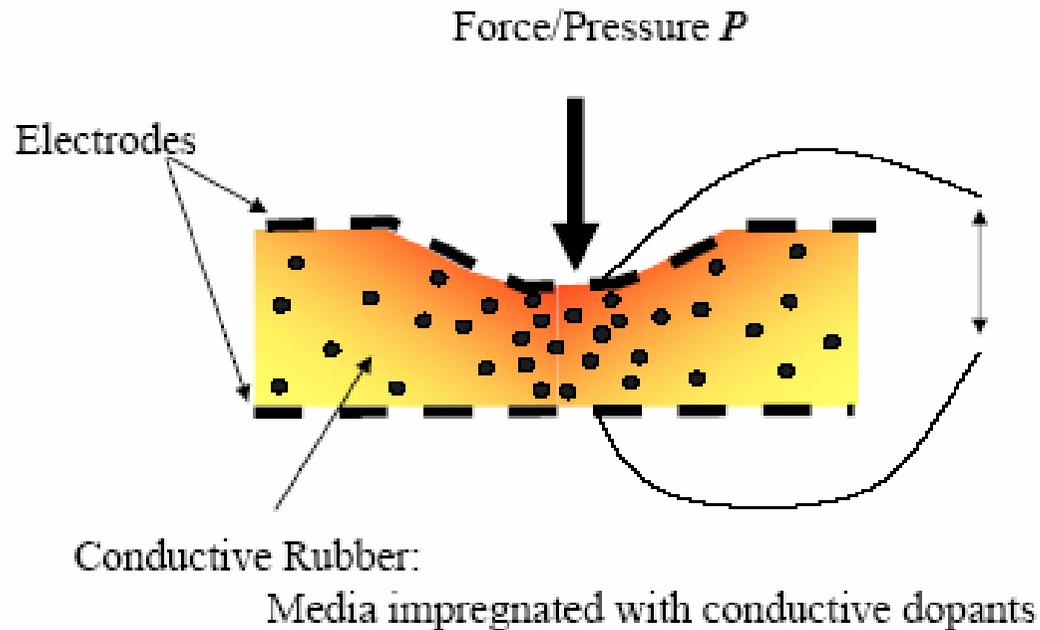


Sensori resistivi



Material cedevole con una caratteristica forza-resistenza nota
Il principio di funzionamento si basa sulla misurazione della resistenza tra due punti

Sensori resistivi



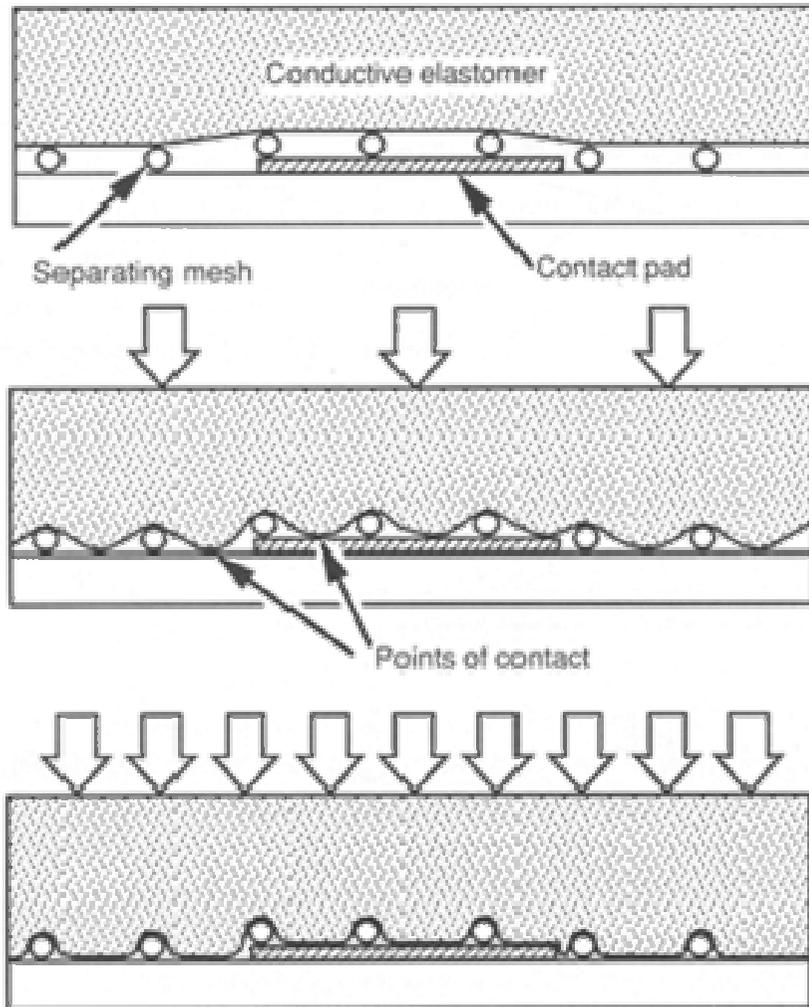
$$R = \rho \frac{l}{wt}$$

con

ρ = resistività del materiale

l, w, t = lunghezza, larghezza e spessore del materiale

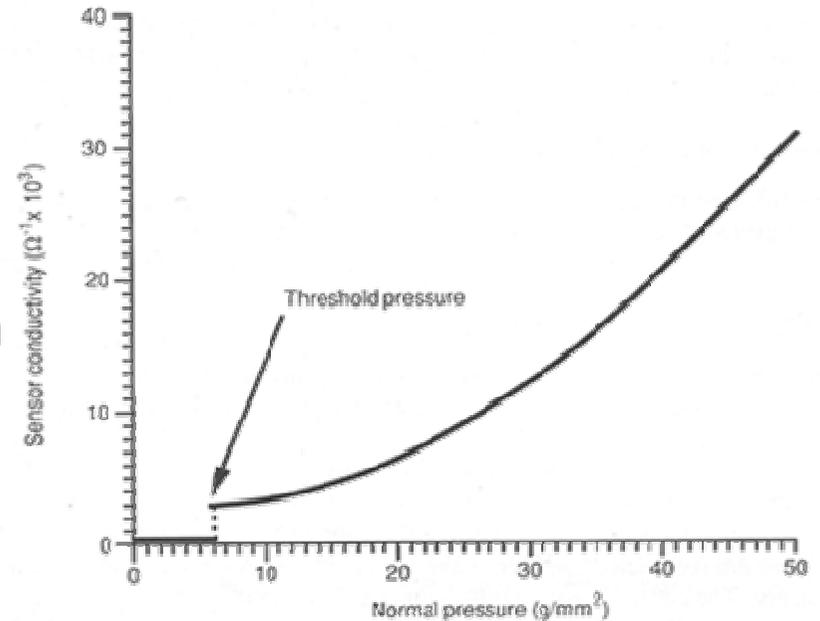
Sensore resistivo di Hillis



No applied force

Threshold force

Increased force



Variazione della resistenza in funzione della forza normale applicata: comportamento non lineare

256 unità

Area: 1 cm²

Sensibilità: 1-100 g

Sensori ottici

Indice di rifrazione di un materiale:

$$n=c/v$$

con

c =velocità della luce nel vuoto

v =velocità della luce nel materiale

Angolo critico θ_c :

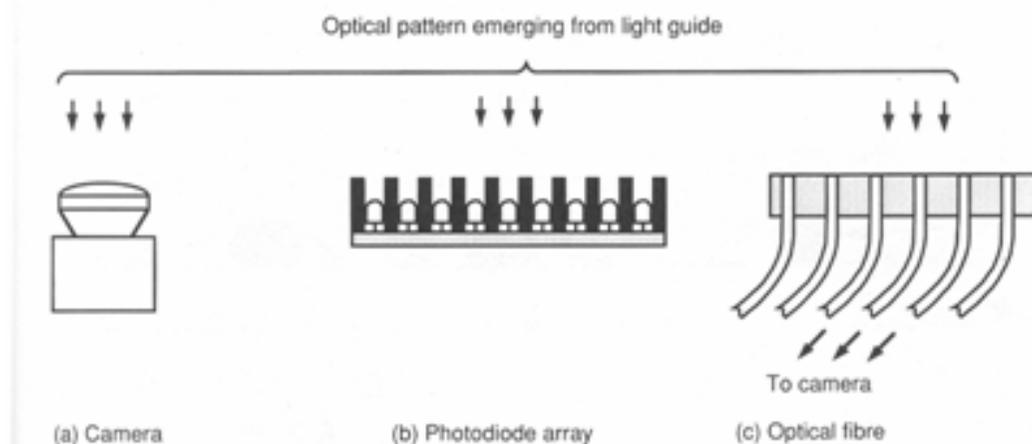
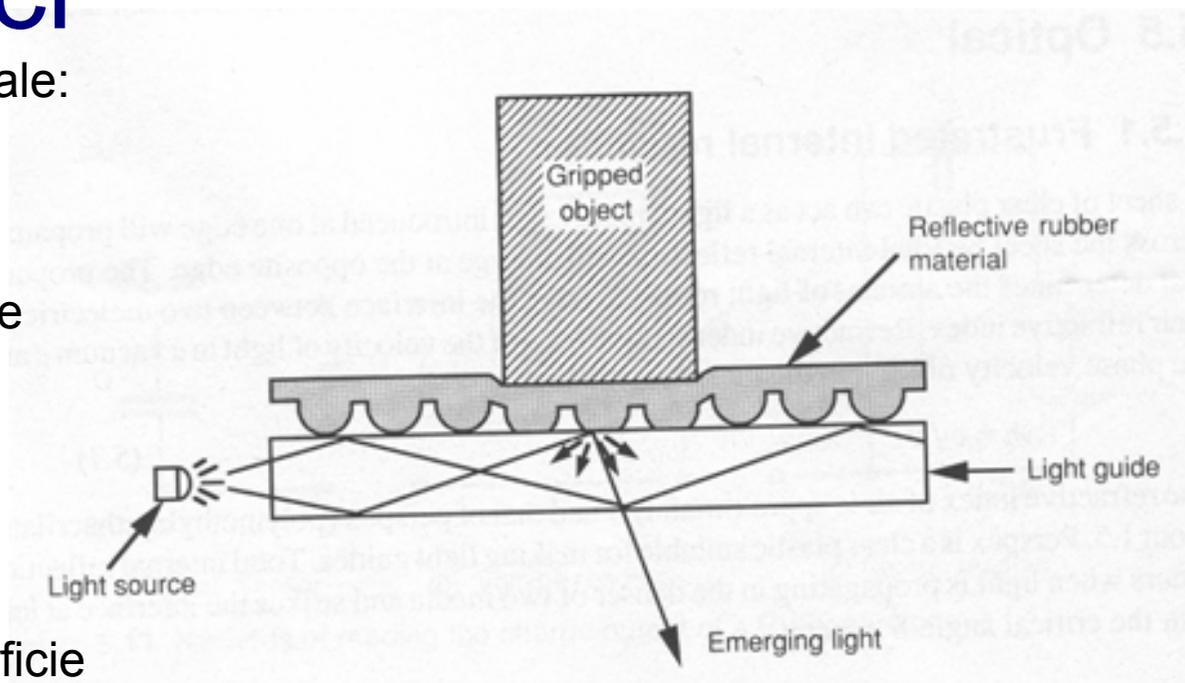
$$\sin \theta_c = n_2/n_1 \quad \text{con } n_1 > n_2$$

Riflessione interna totale:

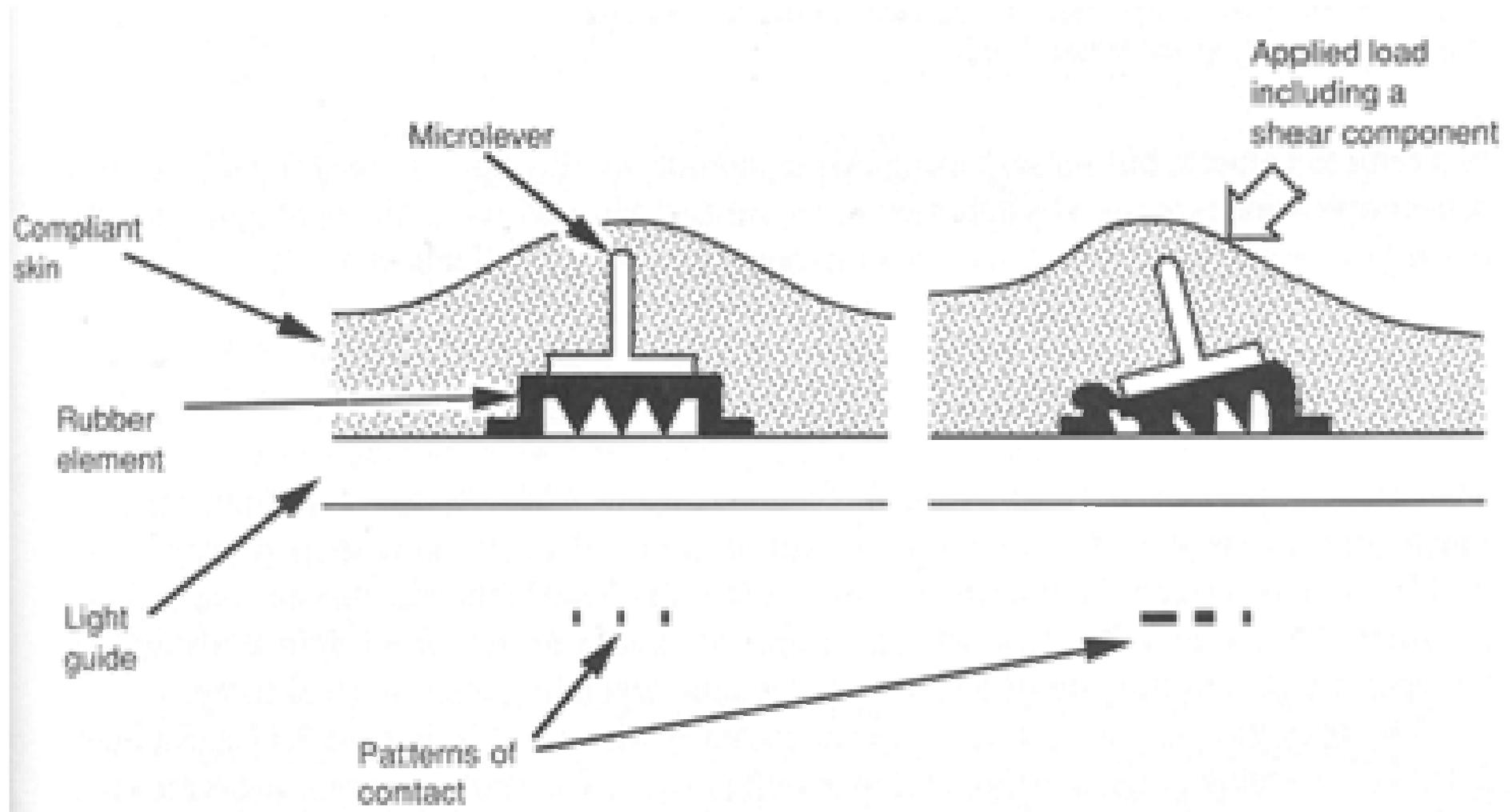
quando la luce incide sulla superficie dell'interfaccia tra due materiali con un angolo di incidenza superiore a θ_c (angolo misurato dalla normale alla superficie)

All'interno di una guida ottica la luce si propaga se incide sulla superficie dell'interfaccia tra la guida ottica e l'aria con un angolo superiore a θ_c

Il contatto di un oggetto esterno sulla superficie della guida ottica impedisce la riflessione interna totale e la luce emerge dal lato opposto della guida



Sensori ottici

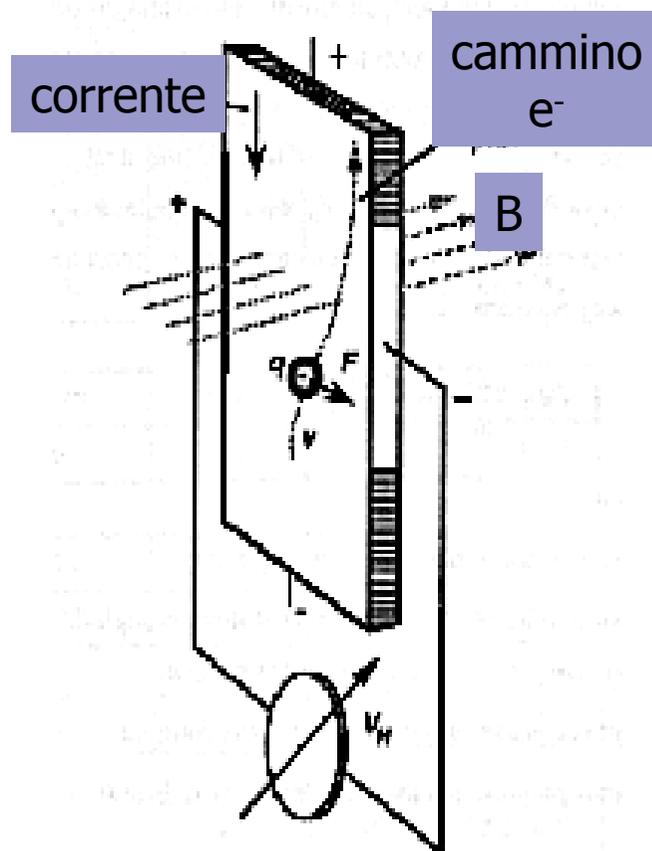


Variando la forma dell'oggetto a contatto con la guida ottica si può ottenere una risposta proporzionale alla forza applicata e anche alle forze tangenziali

Sensori magnetici

Effetto Hall

In un conduttore a forma di lamina percorso da corrente i e soggetto ad un campo magnetico di intensità B , si origina una differenza di potenziale V in una direzione perpendicolare sia alla corrente che al campo magnetico.



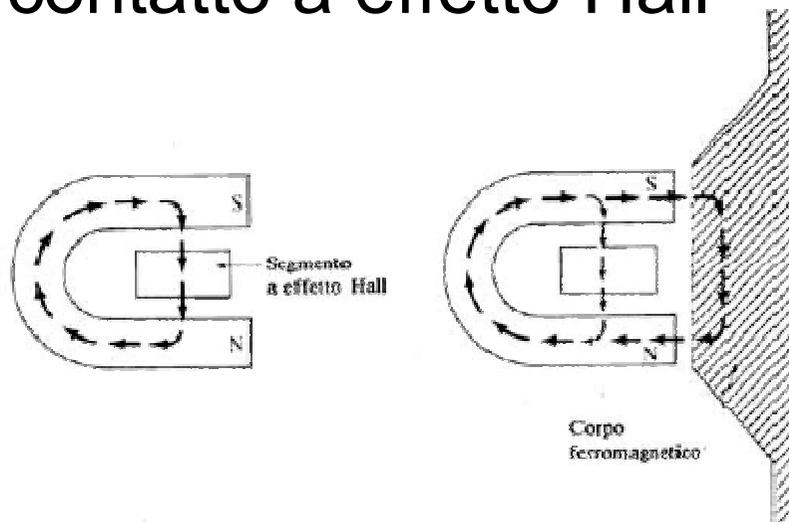
Il valore di tale differenza di potenziale e' è proporzionale all'intensità di corrente i e all'intensità del campo magnetico B , mentre e' è inversamente proporzionale allo spessore della lamina d :

$$V = R i B / d$$

dove R = costante o coefficiente di Hall.

Sensori magnetici a effetto Hall

Sensore di prossimità e di contatto a effetto Hall

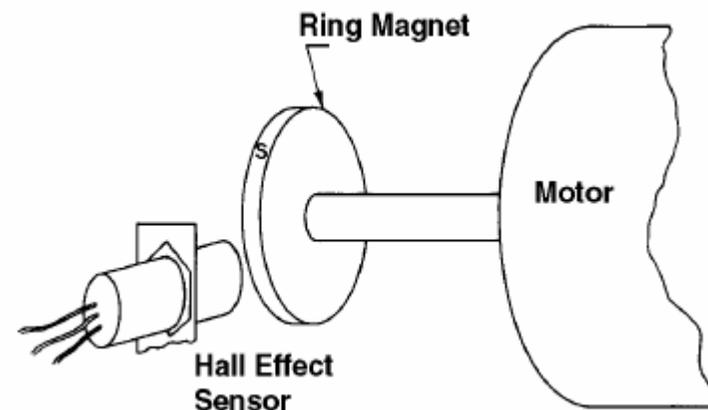


Un magnete permanente genera il campo magnetico.

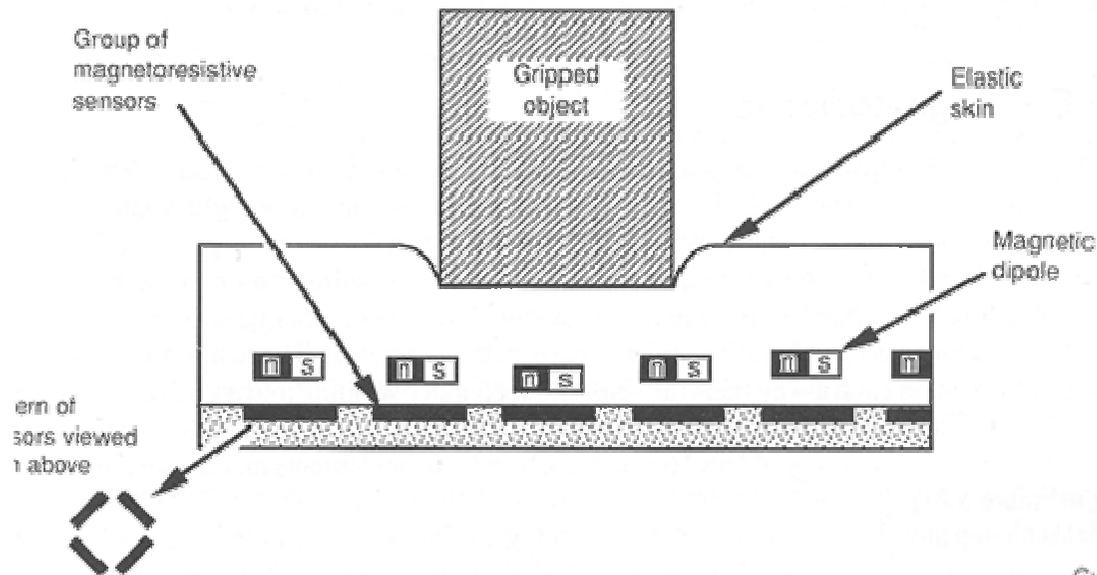
Il contatto con un oggetto ferromagnetico modifica il campo magnetico.

L'effetto Hall permette di misurare questa variazione come variazione della differenza di potenziale

Sensore di posizione a effetto Hall



Sensori magnetici

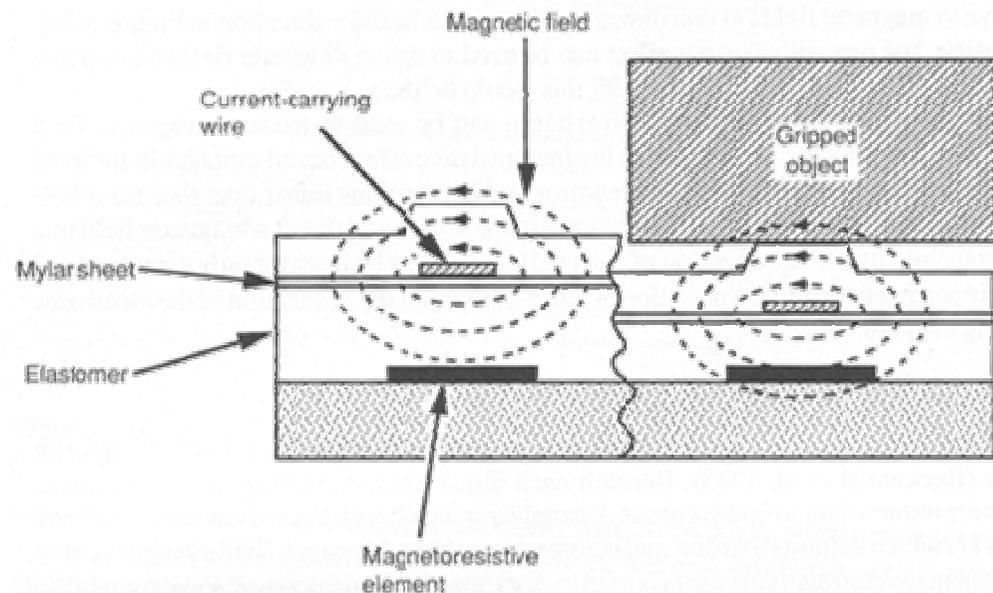


Fili elettrici in cui passa della corrente generano dei campi magnetici. Forze applicate dall'esterno provocano variazioni della posizione dei fili elettrici e dei corrispondenti campi magnetici, che vengono misurate da elementi magnetoresistivi.

distanza minima tra 2 unità: 2,5 mm

Dipoli magnetici all'interno della pelle elastica generano dei campi magnetici. Forze normali, tangenziali e di torsione applicate sulla pelle elastica provocano variazioni della posizione e dell'orientazione dei dipoli magnetici. La corrispondente variazione dei campi magnetici viene misurata da 4 sensori magnetoresistivi, per ogni dipolo.

distanza minima tra 2 unità: 1,6 mm



Sensori capacitivi

Capacità tra due piastre conduttive parallele:

A = area delle piastre

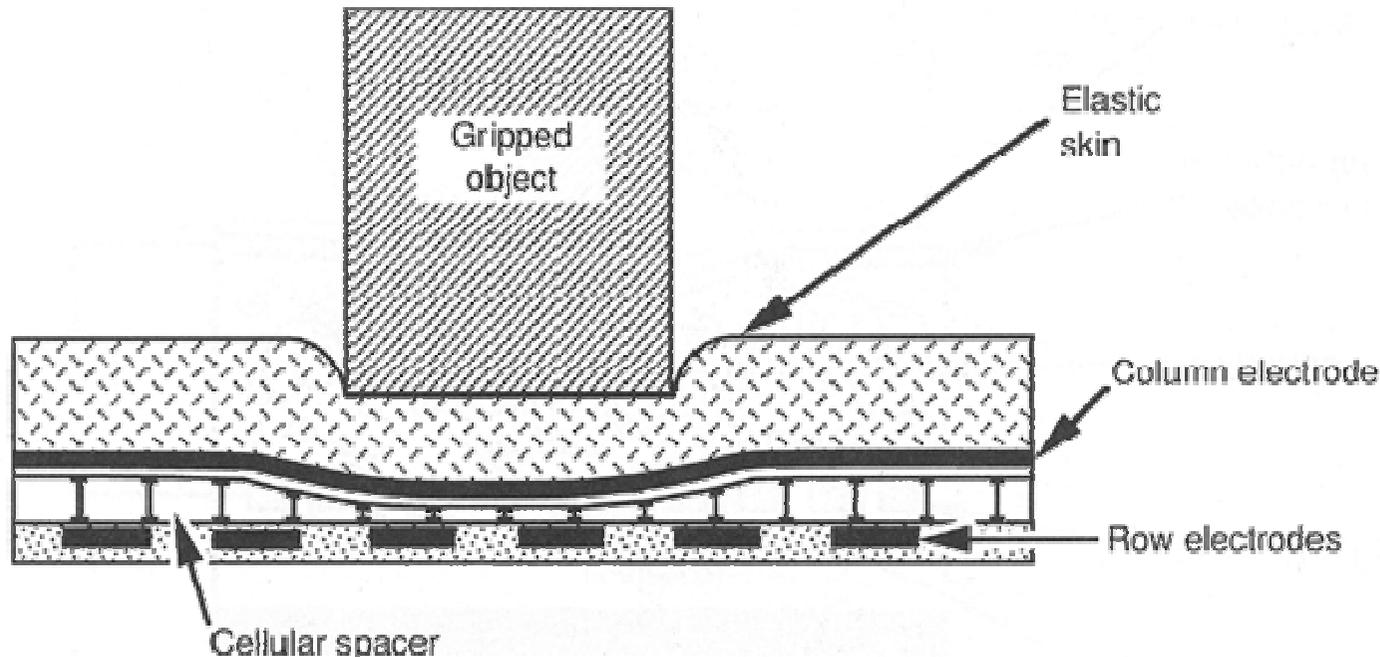
d = distanza tra le piastre

ϵ = caratteristica del materiale tra le due piastre

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

Forze tangenziali
possono far
variare l'area di
sovrapposizione

Forze normali
possono far
variare la distanza



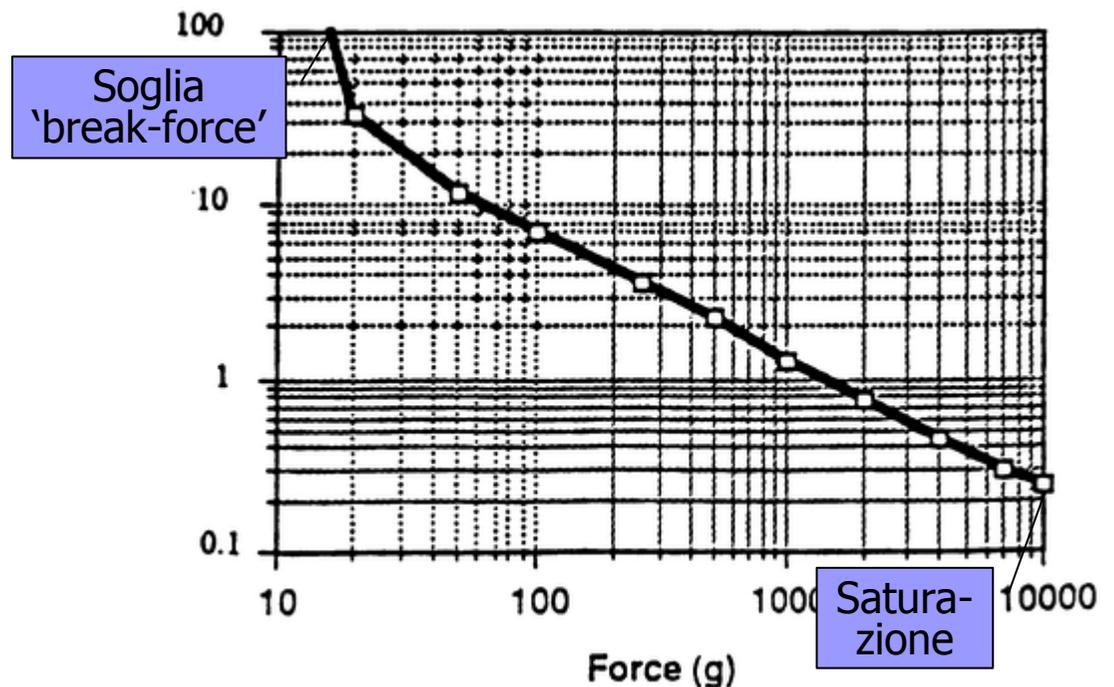
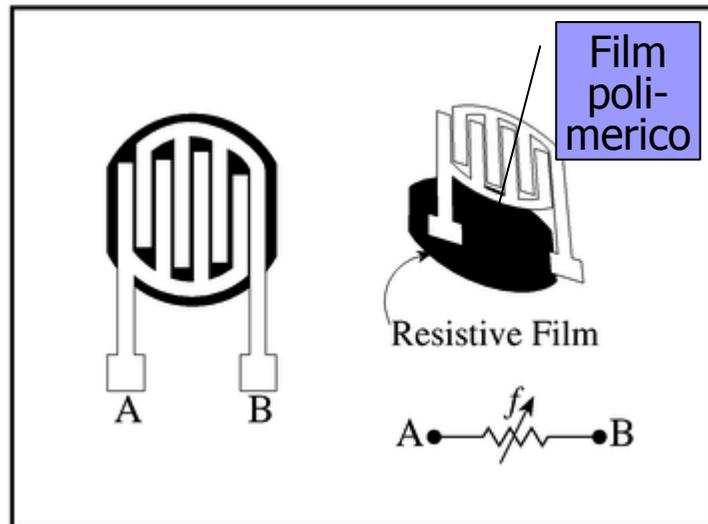
8 x 8 unità

1,9 mm di distanza

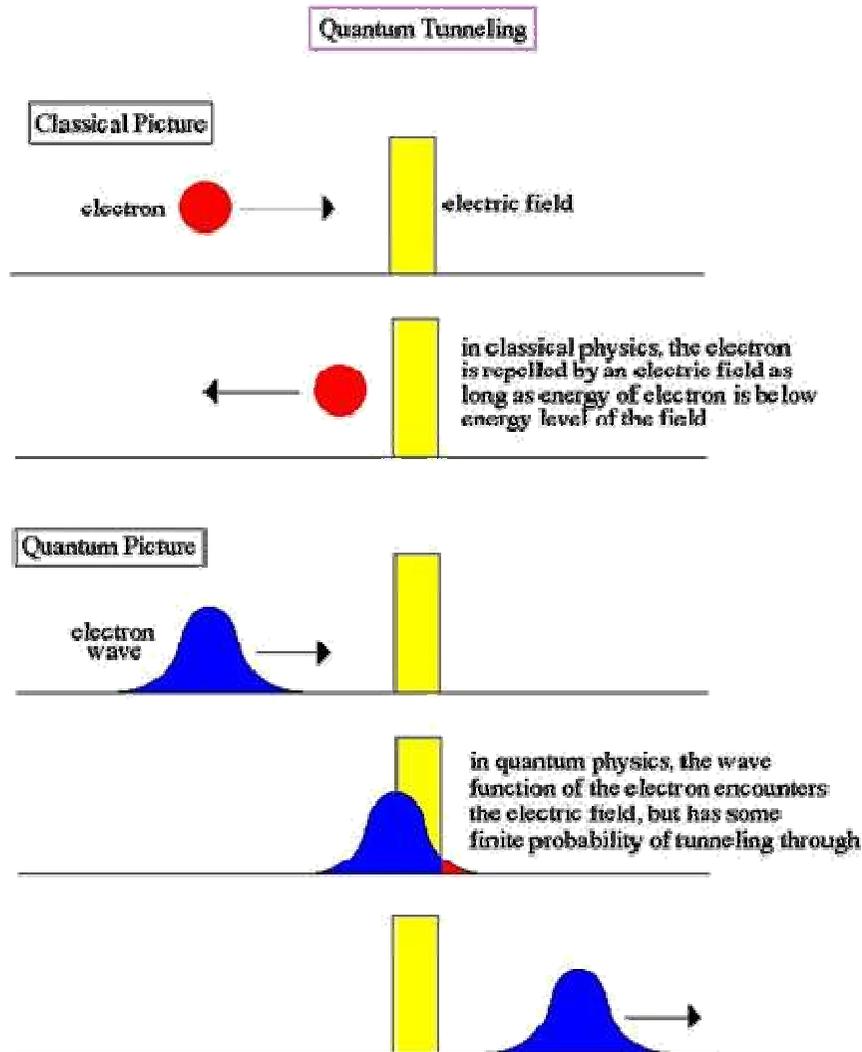
FSR – Force Sensing Resistors



- Dispositivo a film polimerico
- Resistenza decrescente per forze applicate crescenti



Sensori QTC (Quantum Tunnelling Composites)



- I QTC possono trasformarsi da perfetti isolanti a conduttori simili ai metalli quando deformati
- La deformazione può risultare da compressione, taglio o stiramento
- La risposta dei QTC può essere modulata sullo spettro delle forze applicate
- La transizione da isolante a conduttore segue una curva ripetibile, con la resistenza che decresce esponenzialmente

Sensori QTC

Dimensioni

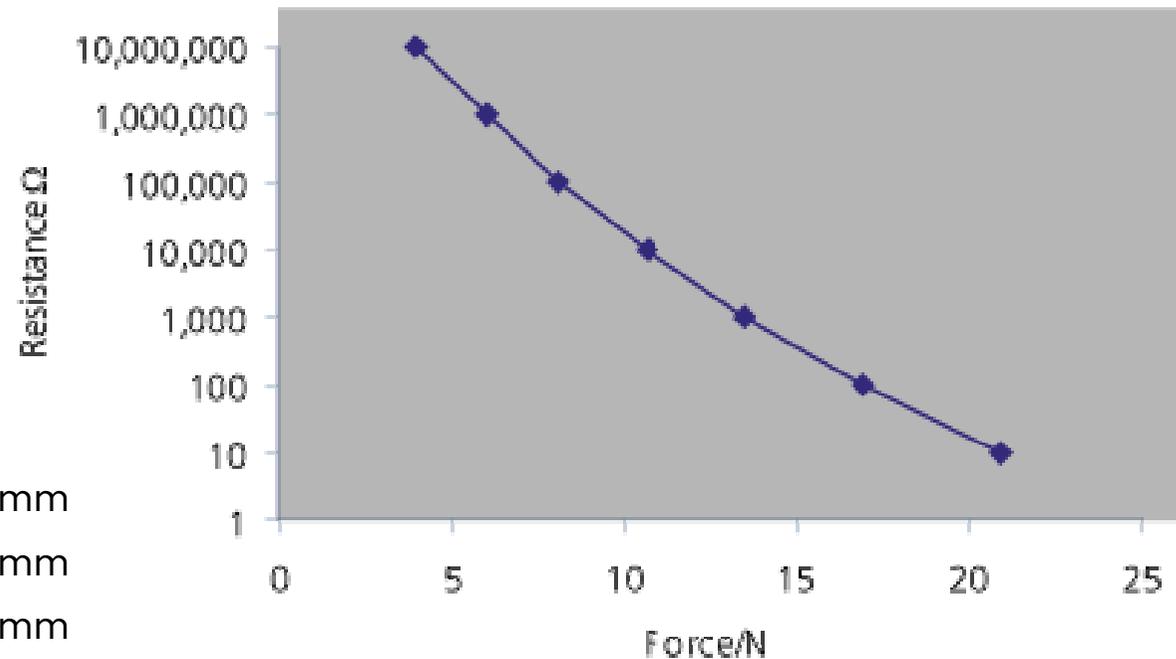
Larghezza	3.6 mm
Lunghezza	3.6 mm
Spessore	1.0 mm

Caratteristiche meccaniche

Peso	0.04g
Densità	4.0 g/cm ³
Range di forza	0 - 100 N
Vita utile	>1,000,000 compressions

Caratteristiche elettriche

Resistività a riposo	> 7 x 10 ¹² Ohm cm
Range di resistenza tipico	> 10 ¹² Ohms to < 1 Ohm
Potenziale operativo	0 to 40 V
Corrente massima	10 A



Silicon-based tactile sensors

Device	Descriptions	Fabrication Technology	N. of Axes	Size (mm)	Sensitivity	Force Range	Characterization method
Mei et al. 1999	Array of 4 x 8 individual sensing elements, piezoresistive principle	CMOS process, silicon bulk micromachining, epoxy assembling	3	4 x 4 x 1.5	13mV/N in Z 2.3mV/N in X and Y	50N in Z 10N in X and Y	3 components load cell
Jin and Mote 1997	Planar cross shape structure, without force concentrating structure, piezoresistive principle	Silicon bulk micromachining, Si-Au eutectic bonding	6	4.5 x 4.5 x 1.2	18.8mV/N in Z ^a 2.41mV/N in X ^a 2.01mV/N in Y ^a	n. a.	Purposely developed 3 components test bench [17]
Dao et al. 2002	Planar structure, piezoresistive principle	Silicon micromachining by DRIE	6	3 x 3 x 4	1.15V/N in Z 0.11V/N in X and Y	n. a.	Mono-axial load cell
Wang and Beebe 1999	SU8 square mesa, piezoresistive principle	Silicon bulk micromachining, soft lithography	3	Diaphragm: 1.9 x 1.9 x 0.05 Mesa: H 0.6	1.57N ⁻¹ in Z ^b Shear sensitivity varies with loading conditions	3N	Mono-axial load cell
Hsieh et al. 2001	Sensitive to shear forces (SiO ₂ flange), piezoresistive principle	Silicon bulk micromachining	2	3 x 3 x 0.3	0.13mV/(mA•MPa) in X and Y	1.44N	Mono-axial load cell
Kane et al. 2000	Array of 64 x 64 individual sensing elements with planar structure, piezoresistive principle	CMOS process, silicon bulk micromachining	3	Array: 19.2 x 19.2	1.59mV/kPa in Z 0.32mV/kPa in X and Y	35kPa in Z 60kPa in X and Y	Purposely developed setup, with a mono-axial load cell and a differential pressure sensor



Tactile skins: materials

Smart materials are being developed in order to develop a sensitive skin

Different approaches

■ 1- Sensing textiles:

- Traditional **fabrics** are coated with smart materials (piezoresistive, piezoelectric and piezocapacitive polymer)
- Elastic fabrics covered with an epitaxial layer of **conducting polymer** (polypyrrole, PPy) or with **carbon filled rubber (CFR)** show piezoresistive properties and they can be used to realize sensorized garments capable of reconstructing and monitoring body shape posture and gesture

■ 2- New semiconductor materials: amorphous silicon

- depositing polycrystalline CdSe (1.75 eV), CdS (2.4 eV), PbS

V. Lumelsky, M. S. Shur, S. Wagner, Sensitive Skin, IEEE Sensors journal, Vol. 1, 1, June 2001, 41-51

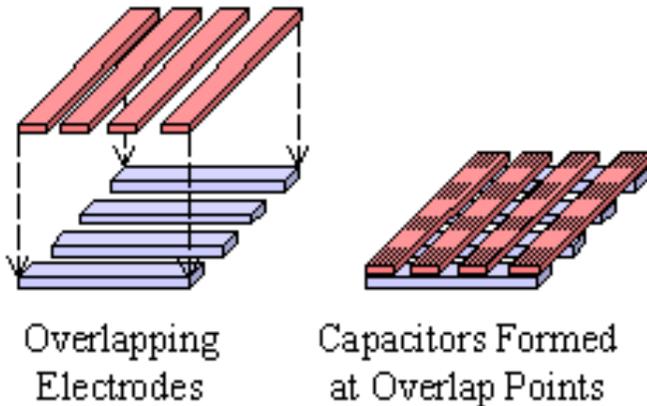
J. Sinius, R. Gaska, M. S. Shur, Flexible semiconductor films for sensitive skin, in *Proc. of the 2000 IEEE/RSJ Int. Conf. On Intelligent Robots and Systems*, 1511-1515

temperature

Commercial skins

■ Pressure Profile Systems Inc., CA, U.S.A.

TactArray:



Capacitive principle for TactArray of Pressure Profile Systems

- The sensor system is capacitive-based and consists of a thin, continuous sheet containing two-dimensional array of pressure sensing elements.
- It uses electrodes made from conductive cloth and separated by a compliant layer which compresses under pressure to allow the air gap to change.
- Overlapping strips of conductive cloth form an array of sensing elements

Tactile skins

2000, Shinoda: Variable capacitance

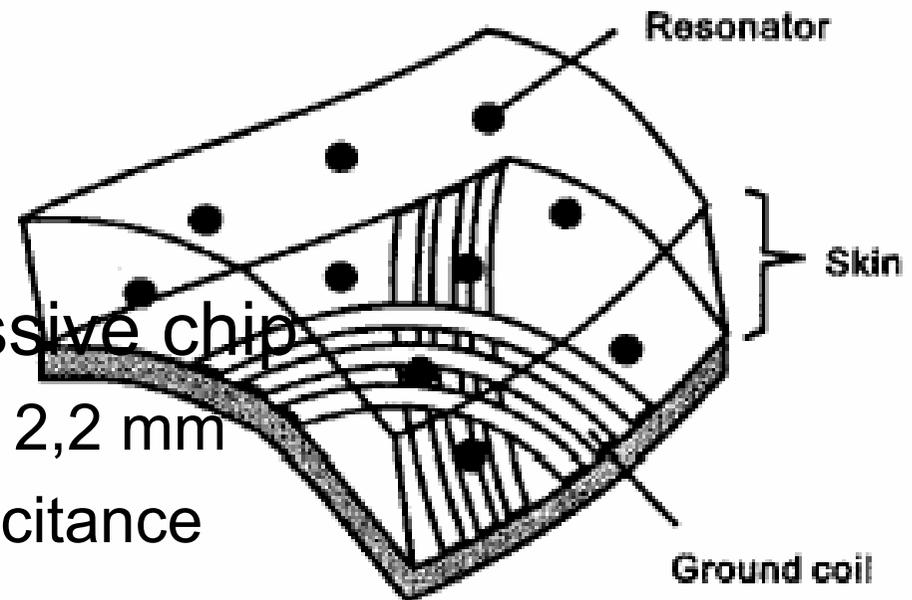
- Sensing elements: passive chip

- Chip dimensions: 2,2 X 2,2 mm
- Principle: variable capacitance
- Resolution: 5 bit
- SNR 10 dB
- Bandwidth: 40KHz

- Wireless technology, via ground coil

- 100 sensors require a bandwidth of 10 Mhz
- Q of the ceramic resonator, to separate the sensors frequencies

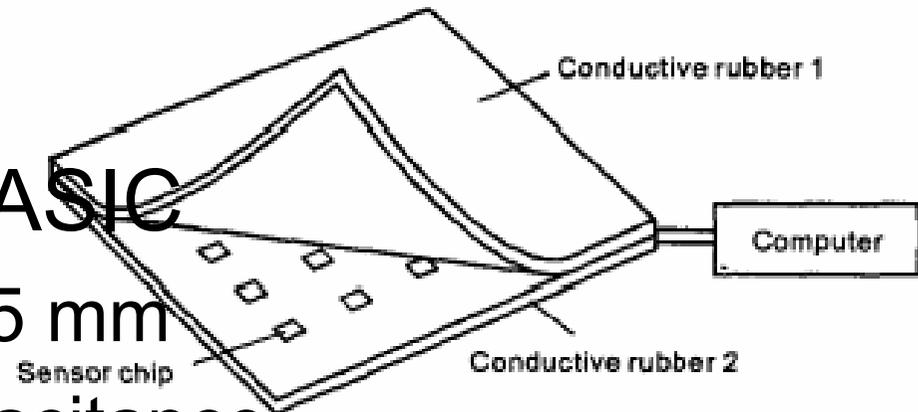
- Problems



Tactile skins

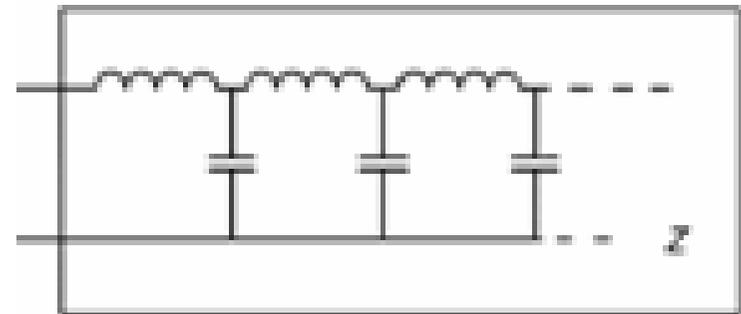
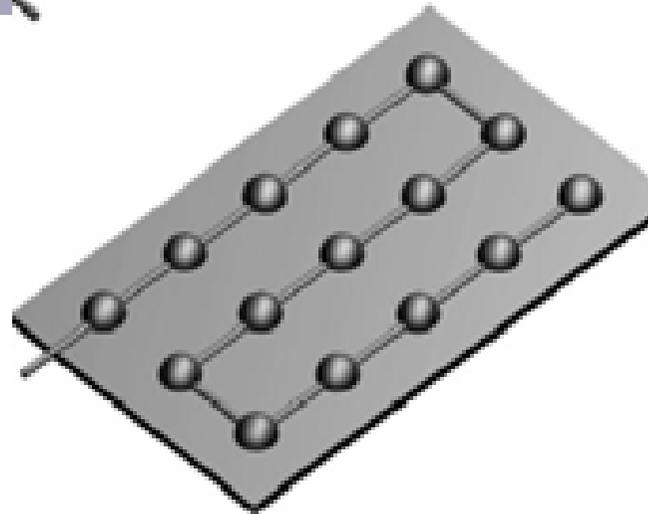
2002, Hakozaiki and Shinoda

- Element: sensor with ASIC
 - Chip dimensions: 5 X 5 mm
 - Principle: variable capacitance
 - Resolution: 10 bit
 - Readout time: 1 ms
 - Host clock: 10Mhz
 - Sensitivity: 1um skin indentation (range: 1um - 1 mm)
- Bus technology, via 2 conductive rubber layers



Tactile skins

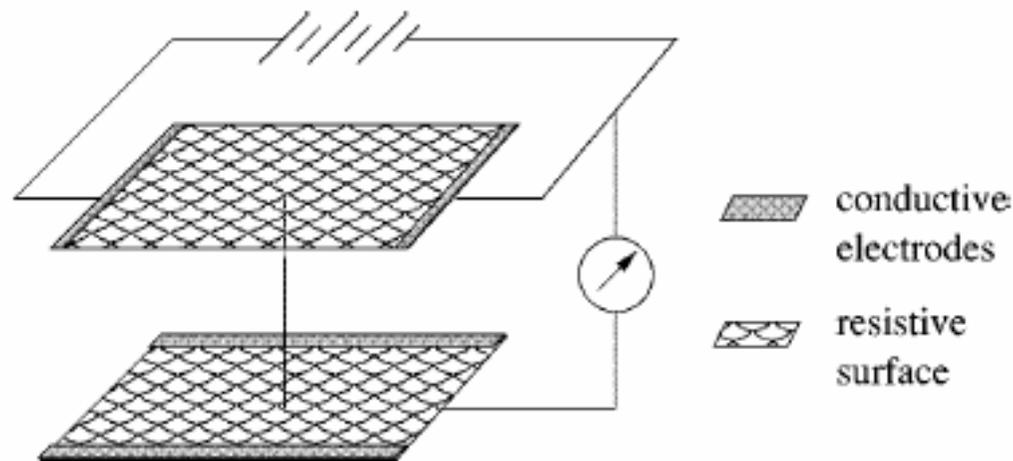
2000, Nilsson: filter bank



- Element: LC analog circuit
 - Readout time: 1 us
- Filter bank, 1 wire. Output=filter bank pulse response
 - Upper element limit: 50 elements
- Problems:

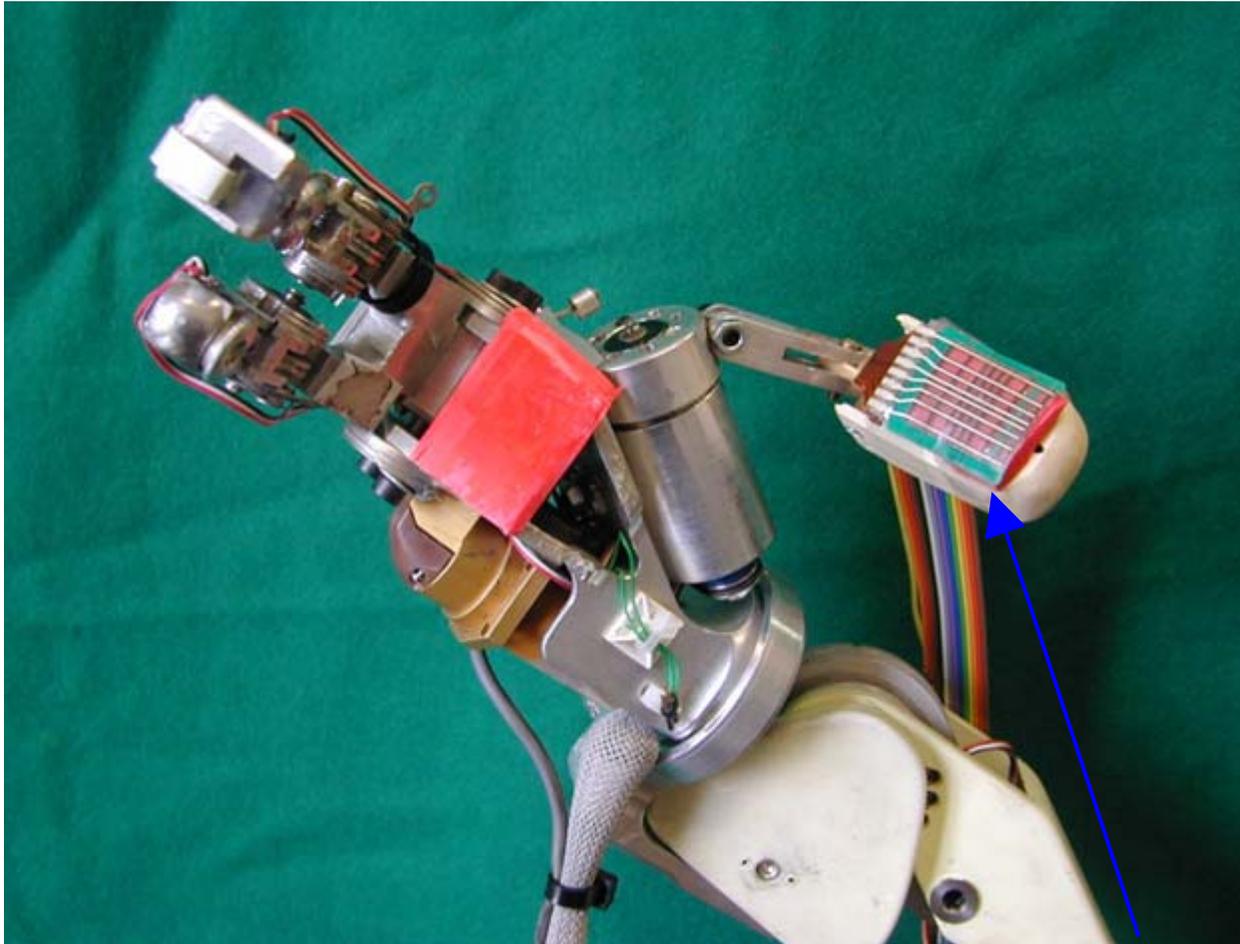
Tactile skins

Zhang 2002: "Hybrid Resistive Tactile Sensing",
IEEE TR on SYSTEMS,MAN,
AND CYBERNETICS, PART B



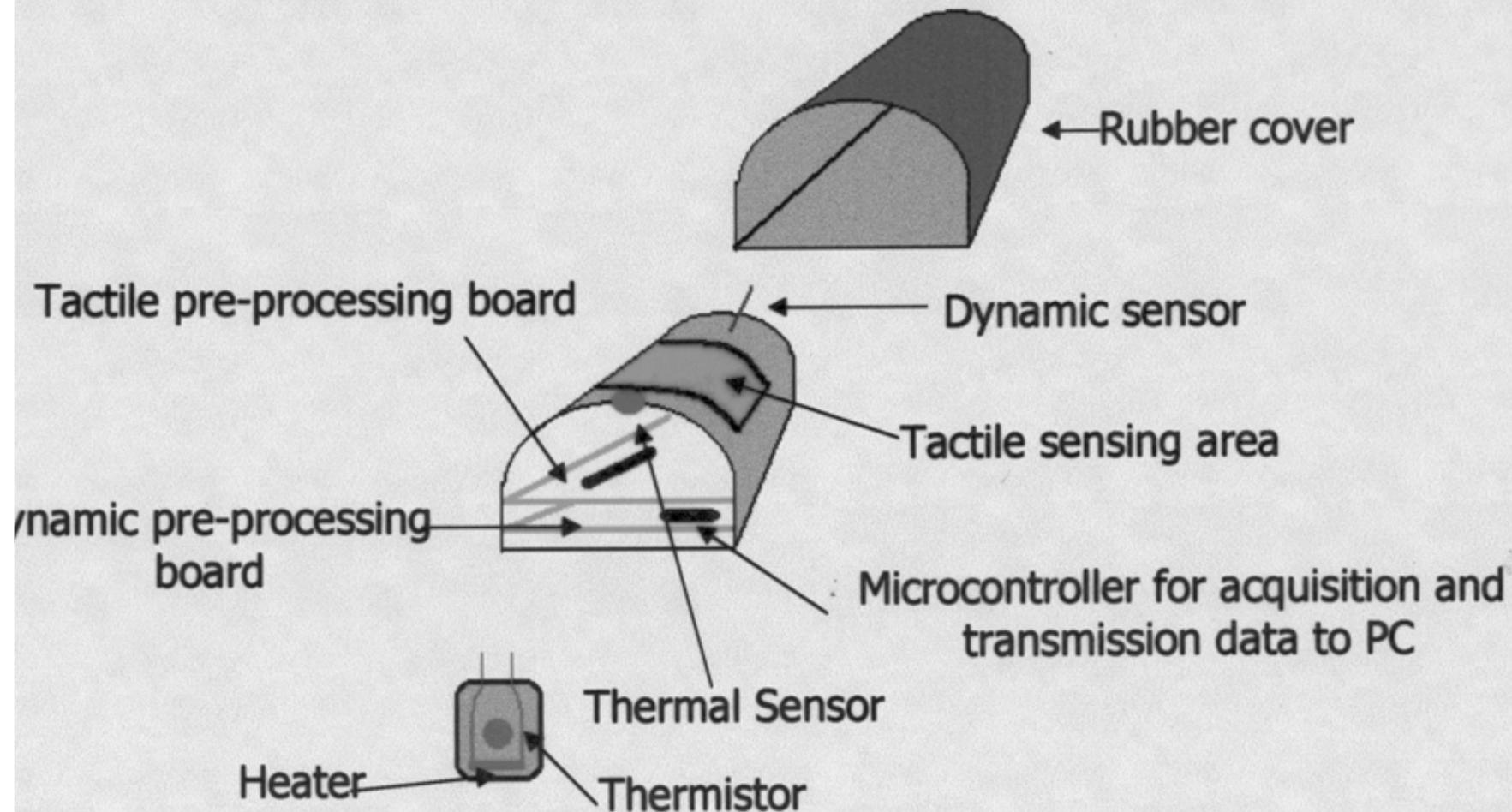
- Element: resistive strips
 - Hybrid: analog on one side, digital on the other
- Filter bank, 1 wire. Output=filter bank pulse response
 - Upper element limit: 50 elements
- Problems:
 - Sensitivity to noise (quantization errors)

Sensori Tattili: ARTS Tactile Sensor

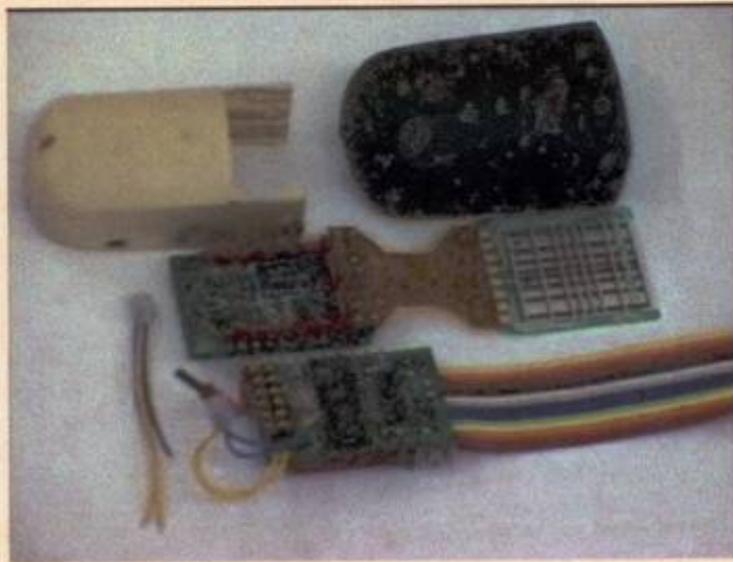


ARTS Tactile Sensor

Scheme of the ARTS integrated fingertip

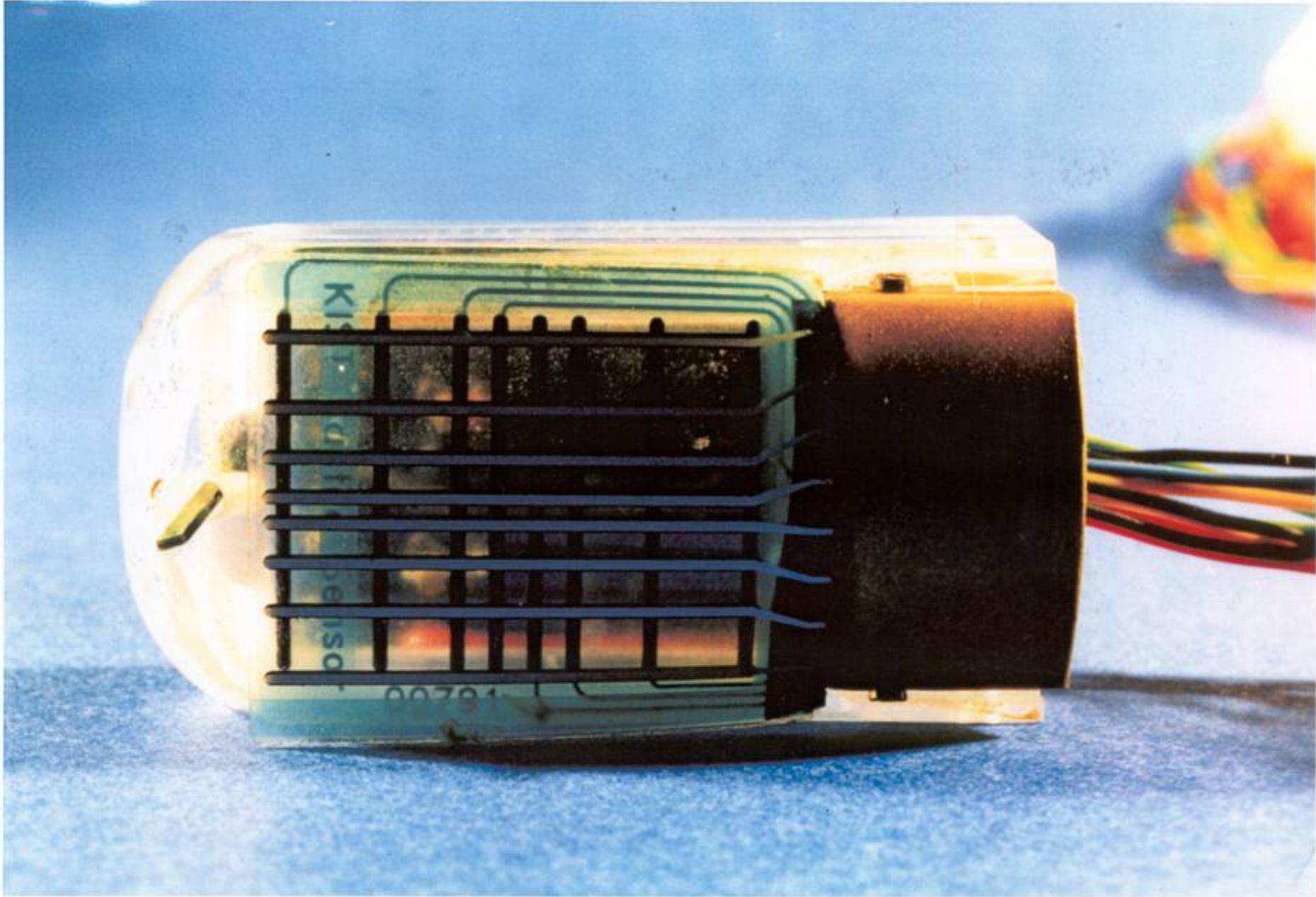


The ARTS integrated fingertip



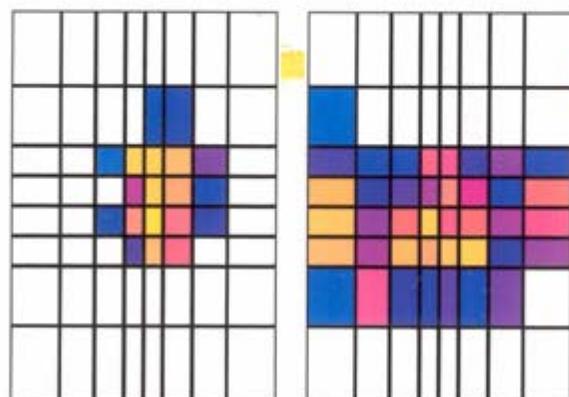
Tactile Sensor Performance	
Force resolution	0.1 N (approx.)
Linearity & Hysteresis	$\pm 12\%$ Fs
Uniformity	$\pm 15\%$ Fs @ 3N

Tactile Array Sensor Physical Characteristics	
External Dimensions	24.36mm x 34.9 mm.
Overall Area	850 mm ²
Sensitive Area	432 mm ²
Number of sensitive sites	64
Maximum resolution (in the centre)	1 mm.
Minimum resolution (at the periphery)	5 mm.
Number of wires	16
Signal Pad Area	2.25 mm ² (each)



Polpastrello sensorizzato

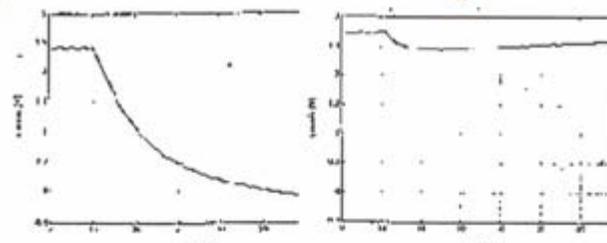
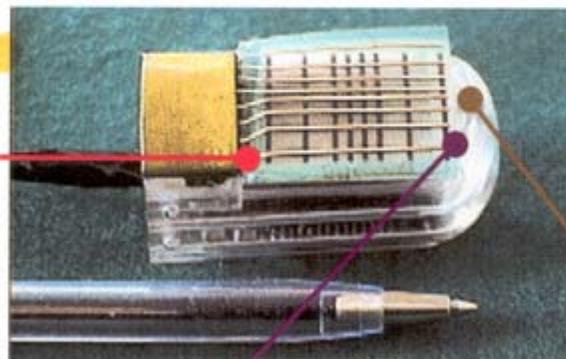
ARTS Lab, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa



(a)

(b)

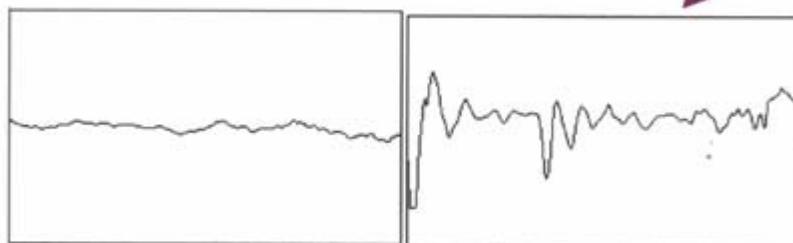
Immagine tattile acquisita durante la presa di oggetti (a) sferici e (b) cilindrici



(a)

(b)

Risposta del sensore termico per un oggetto (a) metallico e (b) plastico



(a)

(b)

Segnale del sensore dinamico durante l'esplorazione di una superficie (a) liscia e (b) rugosa



Sommario della lezione

- Principali tecnologie per la realizzazione di sensori tattili artificiali:
 - principi di funzionamento e relazioni matematiche
 - esempi di realizzazione di sensori tattili
- **Esempio di progettazione biomeccatronica di un sensore tattile per una mano robotica**
- Esplorazione tattile

- *Riferimenti bibliografici:*
Russel, “Robot Tactile Sensing”, Prentice Hall

The “SSSA-PALOMA Hand” at a glance

Hand mechanical specifications

10 d.o.f.s; 6 underactuated, 4 motor actuated

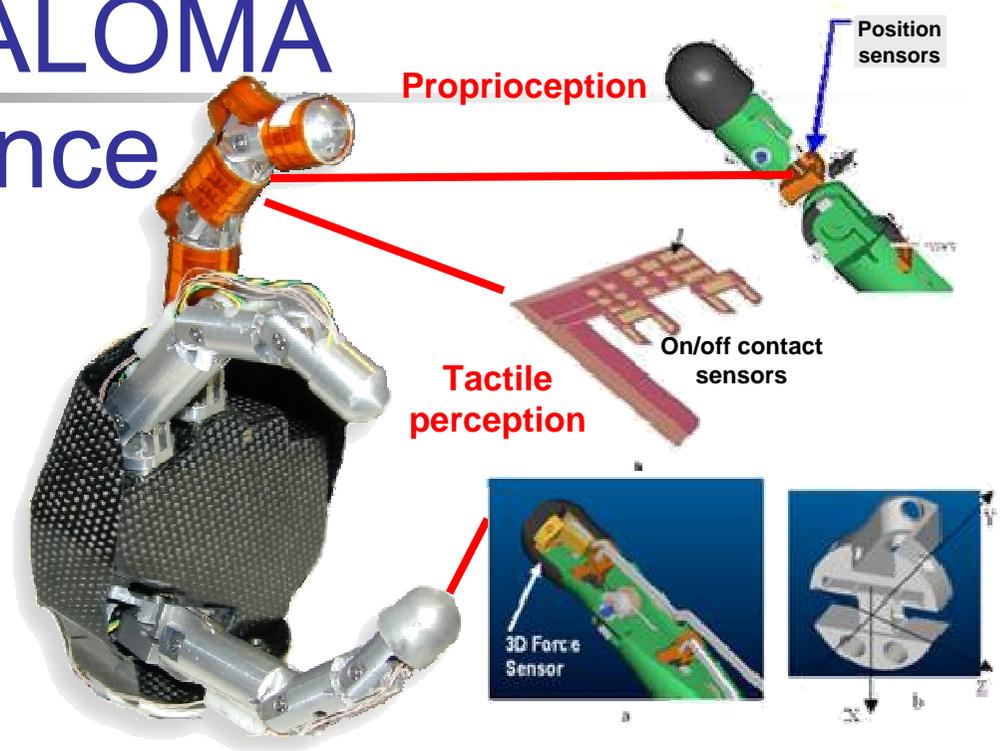
- three identical underactuated 3 dof fingers with cylindrical phalanges, driven by a single cable allowing flexion/extension
- a 2 DoFs trapezo-metacarpal joint at the base of the palm allowing thumb opposition movement (adduction/abduction) towards the other 2 fingers

Weight: about 400gr

Dimension: similar to the human hand

Performance

- trapezo-metacarpal thumb joint abduction/adduction range: 0° - 120°
- finger joints flexion range: 0 - 90°
- load weight: 450 gr
- grasping force: 40 N
- tip to tip force: 15 N
- closing time: 2 sec.



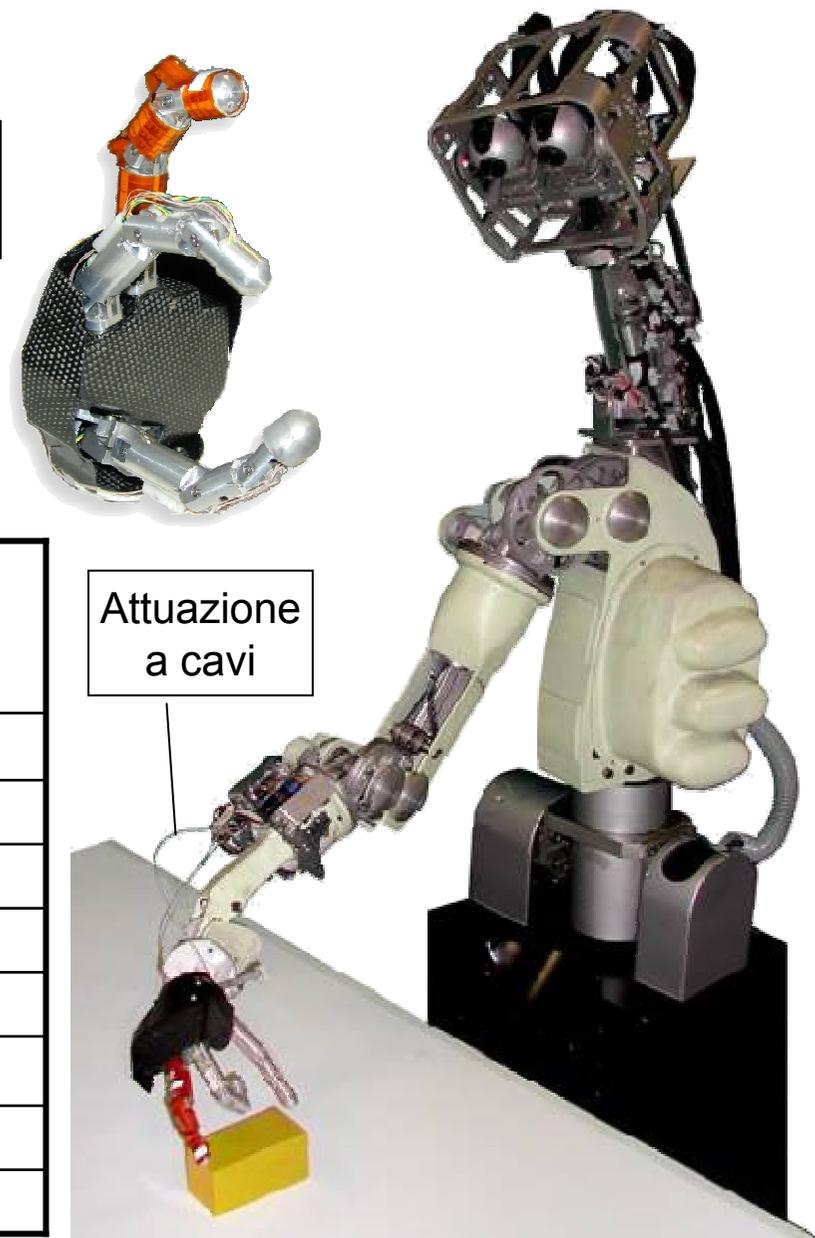
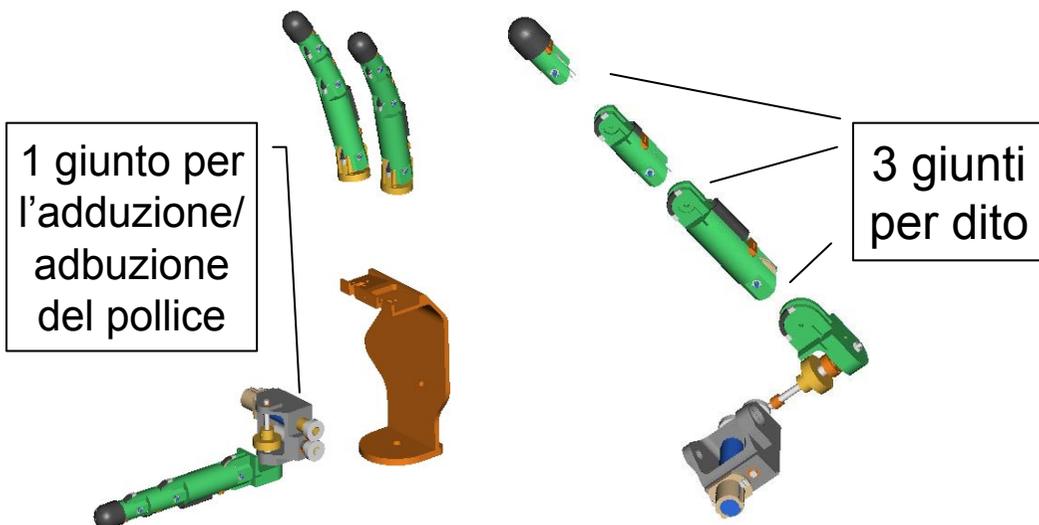
Proprioceptive System

- 3 position Hall-effect sensors, one per phalanx, for each finger
- 4 motor encoders
- 3 force tension sensors providing the tension of the actuation cable

Tactile System

- a 3D force sensor for each finger embedded in the fingertip providing the three force components of the contact
- 3 ON/OFF contact sensors for each finger:
 - 1 on the distal phalange
 - 1 on the intermediate phalanx
 - 1 on the proximal phalanx

Polpastrello tattile per una mano robotica



Gradi di libertà	10, di cui: 4 attuati, 6 sottoattuati
Ampiezza adduzione/abduzione pollice	0°-120°
Ampiezza flessione giunti delle dita	0°-90°
Carico massimo	450 gr
Forza di presa	40N
Forza tip-to-tip	15N
Tempo di chiusura	2 s
Peso	400 gr
Dimensioni	Antropomorfe

Developing a bio-inspired artificial tactile system

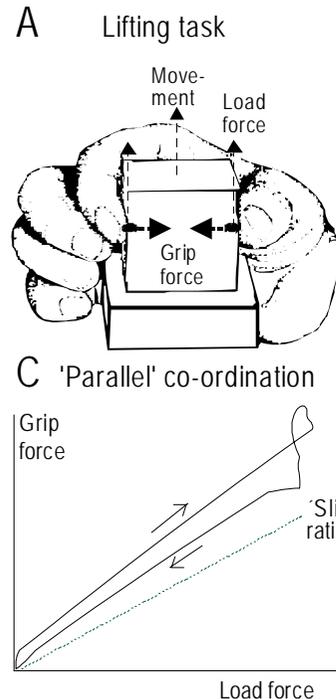
- To mimic the biomechanical features and the sensory apparatus of the human hand

APPROACH

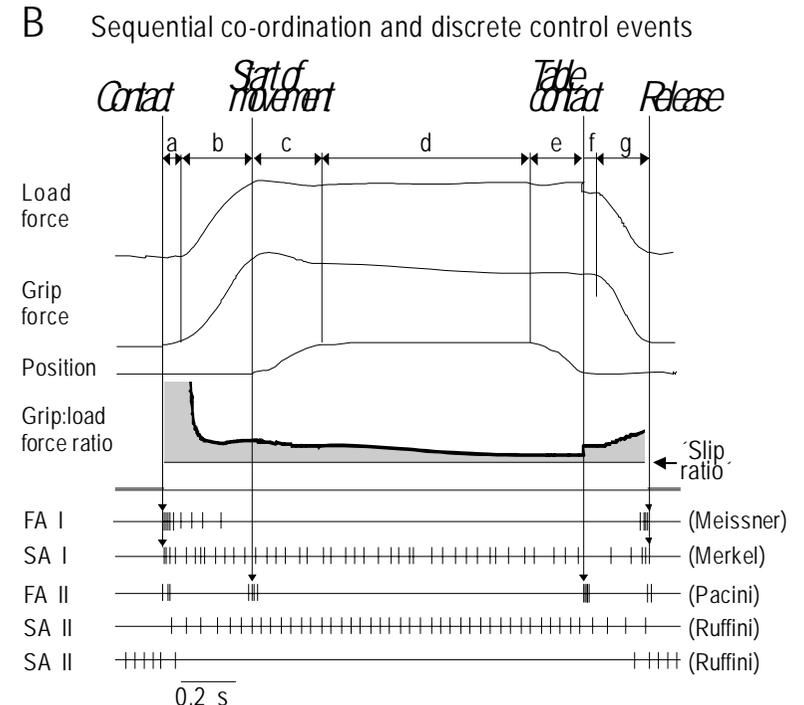
- To have a COMPLETE SYSTEM for tactile sensing
- To focus on sensory signals that belong to basic human grasping and manipulation



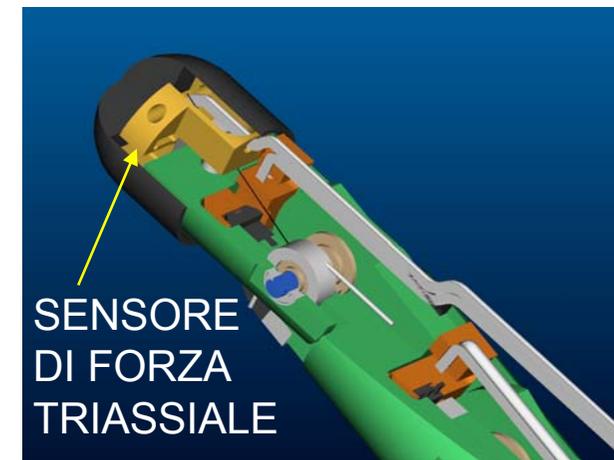
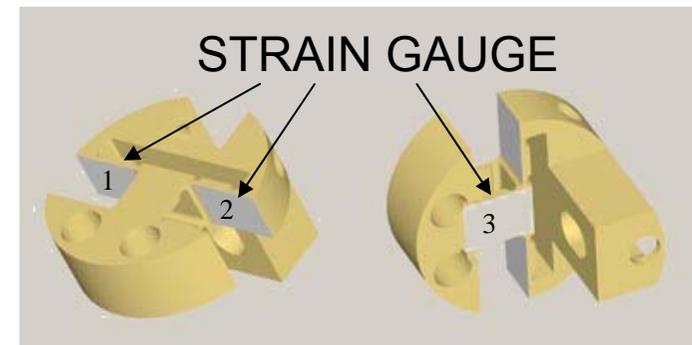
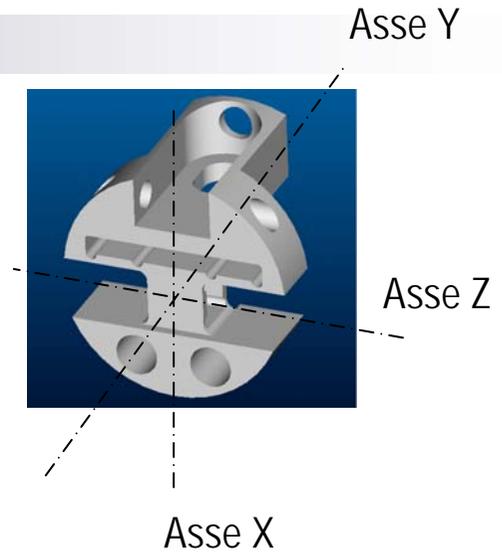
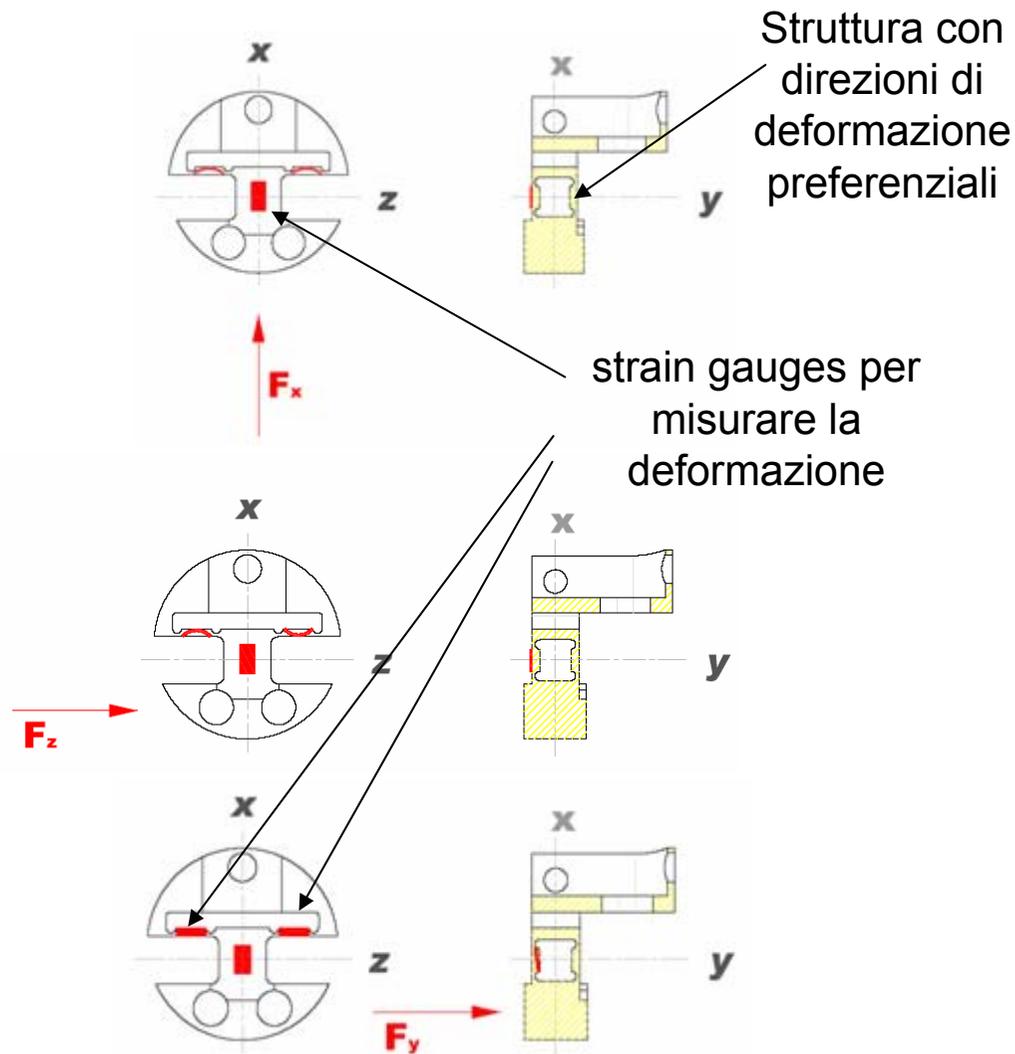
Prototypical task:
grasping, lifting and replacing an object

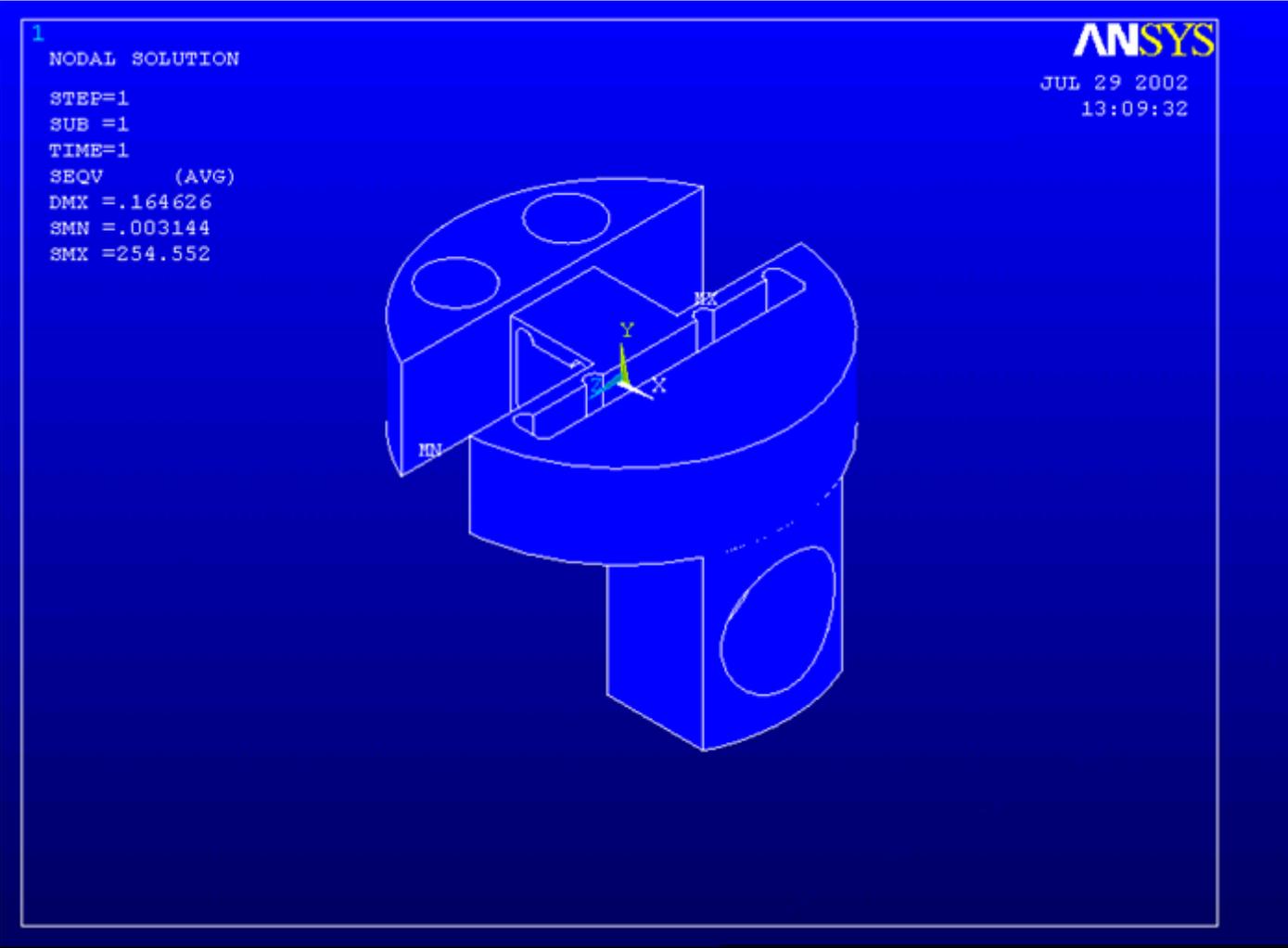
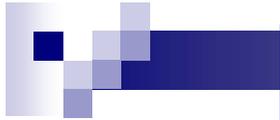


Biomimetic sensors are considered not as precision devices but as a SYSTEM able to extract qualitative or semi-quantitative information



Sensore di forza triassiale nel polpastrello





Sensibilità: Asse X : ~1 mV/N
Asse Y : ~1 mV/N
Asse Z : ~1 mV/N

Risoluzione: Fx: ~4,5 mN
Fy: ~6 mN
Fz: ~4,5 mN

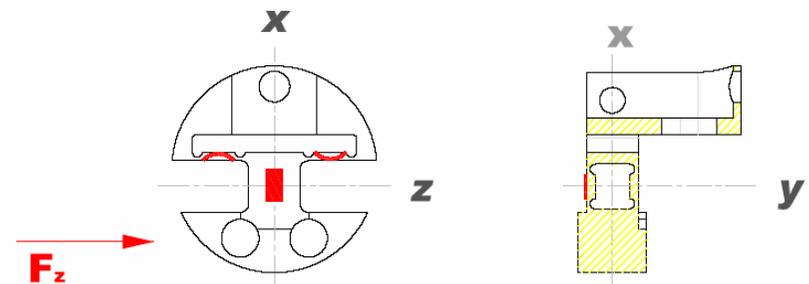
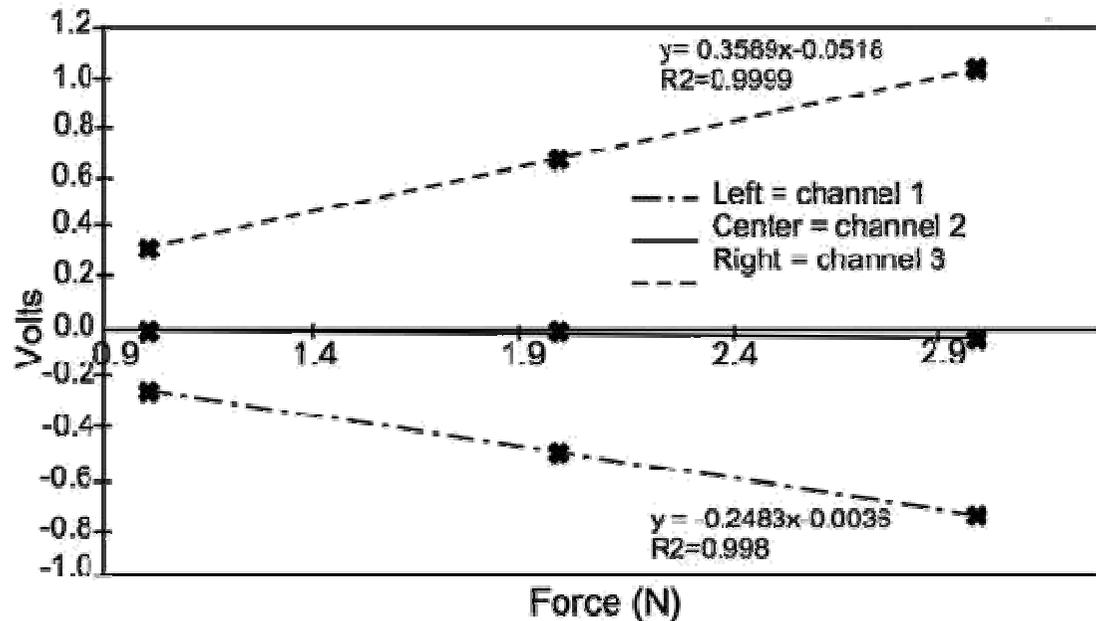
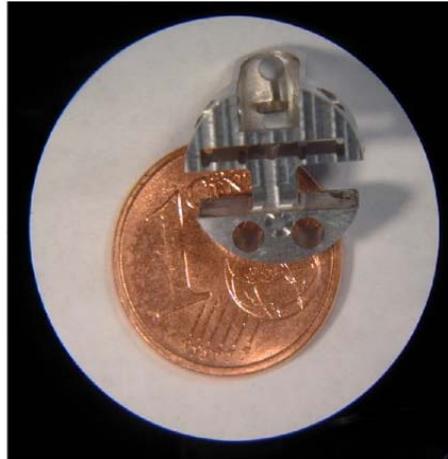
Carico massimo: Fx : ~ 4.5 N
Fy : ~ 6 N
Fz : ~ 4.5 N

Sensore di forza triassiale nel polpastrello

materiale: alluminio

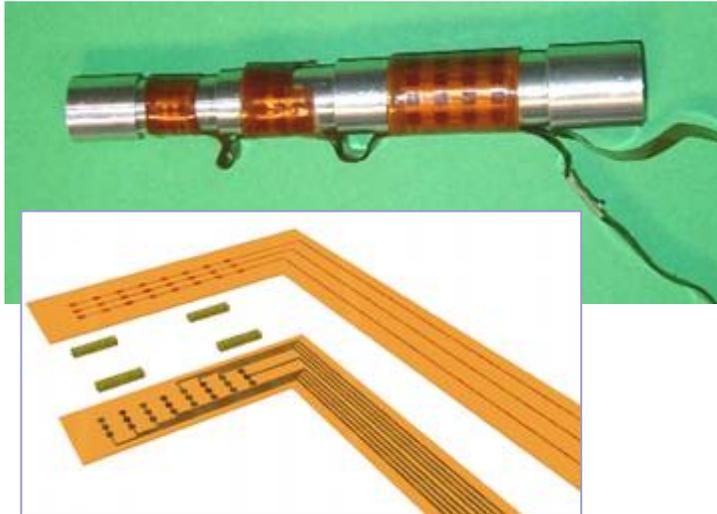
dimensioni: $\phi=12$ mm

$h=9,5$ mm



Contact making and breaking between object and fingertips

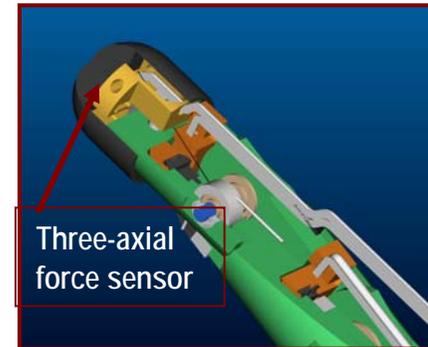
New On/Off Contact Sensors



Distribution on anthropomorphic hand (Total of 80 taxels)

- Matrix 8 x 3 for fingertip
 - Matrix 8 x 3 for middle phalange
 - Matrix 8 x 4 for proximal phalange
 - **Threshold value: 20 mN**
 - Spatial resolution = 2mm
- The on-off contact sensors can duplicate the static response of the SA-I, during contact with an object
- From preliminary experiments the measured minimal threshold is of 20 mN close to the approximately 5 mN contact threshold observed in humans

Three-Axial Force Sensor



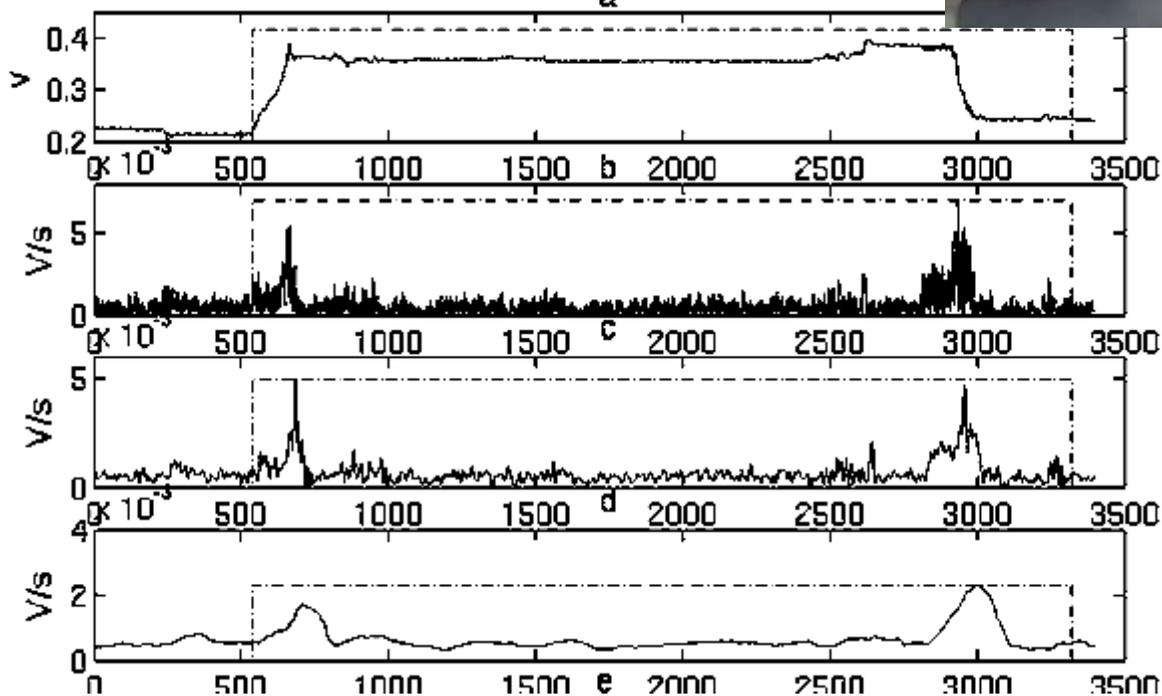
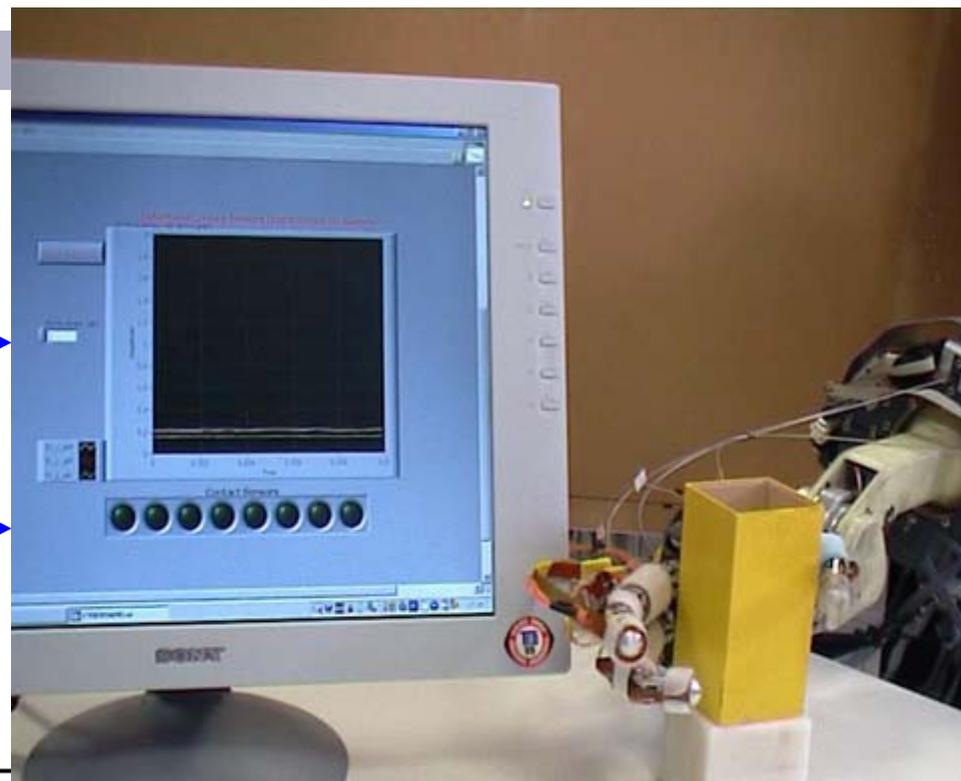
- The three-axial sensor can trigger the necessary signals during the object lift-off and replacement emulating the response of the FA-II mechanoreceptors
- One of the sensor outputs is sufficient to detect the sequential phases of the lifting task

Mimicking the human hand for lifting tasks

Three axial force sensor signals →

Contact sensors signals →

Change of signal of the Force sensor corresponds to the different phases of the pick and lift task

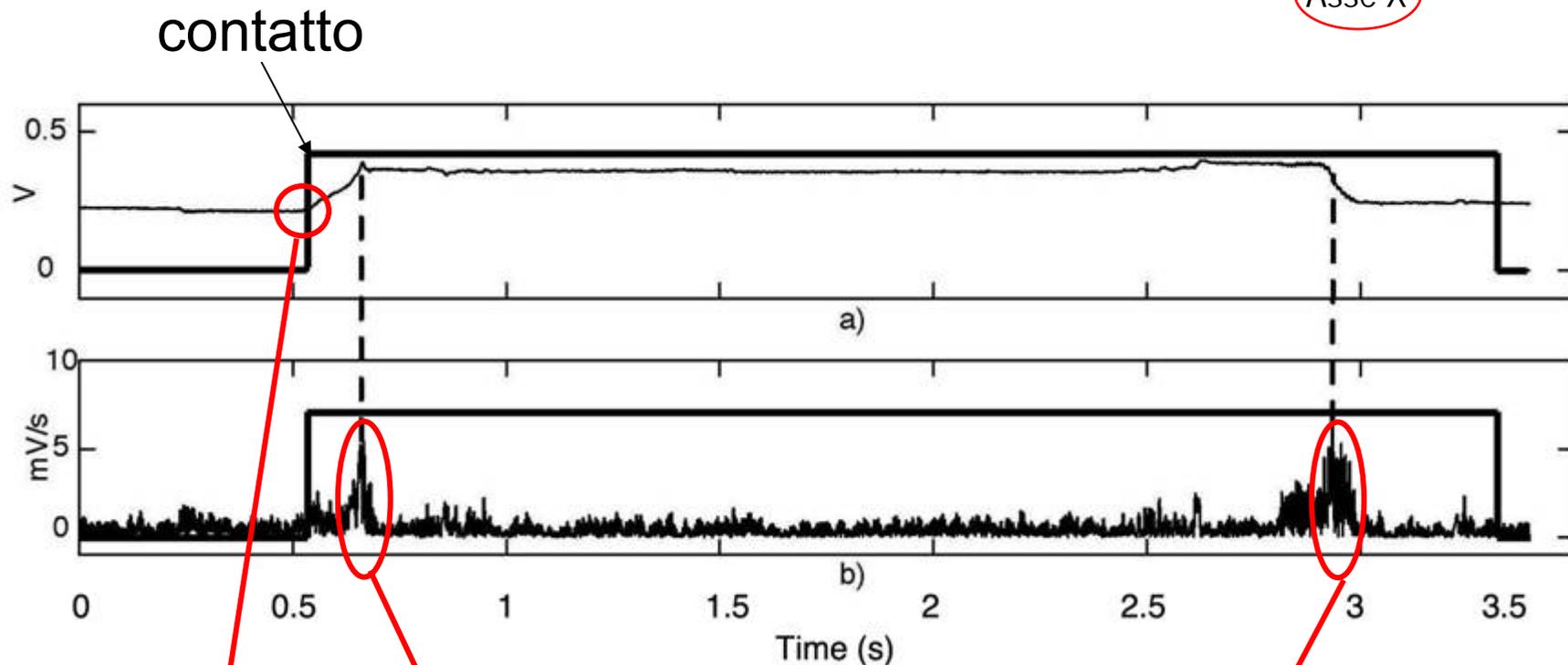
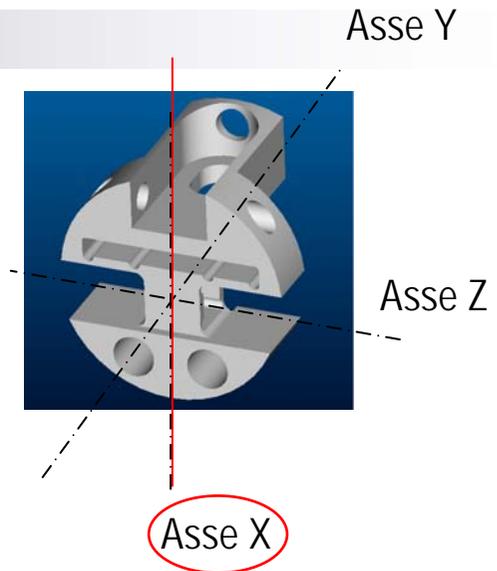


Signal of the First Derivative

Filtered signal of the First Derivative

Smoothed filtered signal of the First Derivative

Comportamento del polpastrello tattile nel compito di presa prototipale

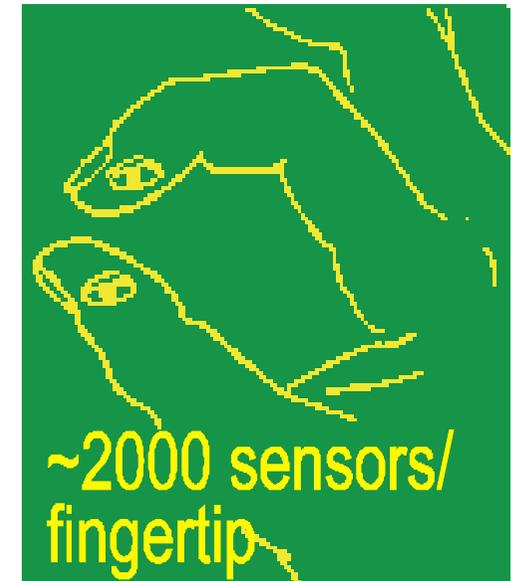


contatto sollevamento

appoggio

Funzionalità del sensore di forza triassiale rispetto al polpastrello

- Forza sul polpastrello:
 - intensità
 - direzione
- Forma locale del contatto (curvatura della superficie dell'oggetto)
- Eventi di controllo tattile:
 - scivolamenti
 - inizio e fine del contatto
 - inizio e fine del contatto dell'oggetto afferrato con altri oggetti (es. piano di appoggio)



Flat



Curved
($r = 10 \text{ mm}$)



Curved
($r = 5 \text{ mm}$)

Funzionalità del sensore di forza triassiale rispetto al polpastrello

■ Forza sul polpastrello:

- intensità
- direzione

■ Forma locale del contatto (curvatura della superficie dell'oggetto)

■ Eventi di controllo tattile:

- scivolamenti
- inizio e fine del contatto
- inizio e fine del contatto dell'oggetto afferrato con altri oggetti (es. piano di appoggio)



Flat

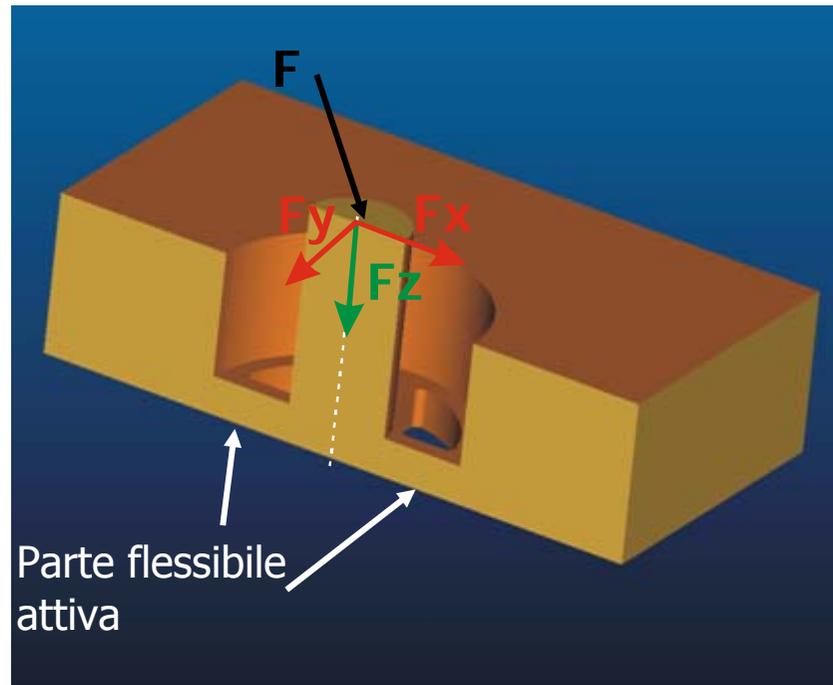


Curved
($r = 10 \text{ mm}$)



Curved
($r = 5 \text{ mm}$)

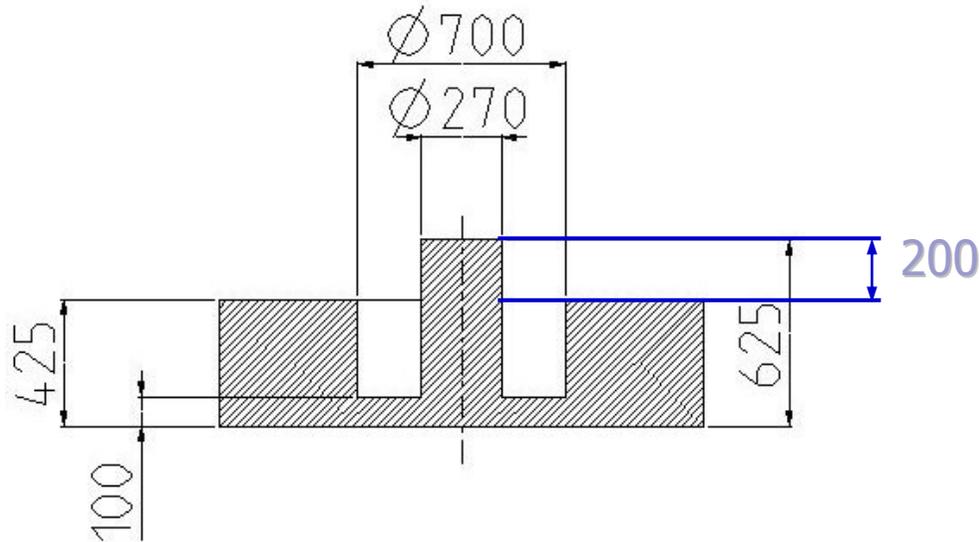
Microsensore di forza triassiale



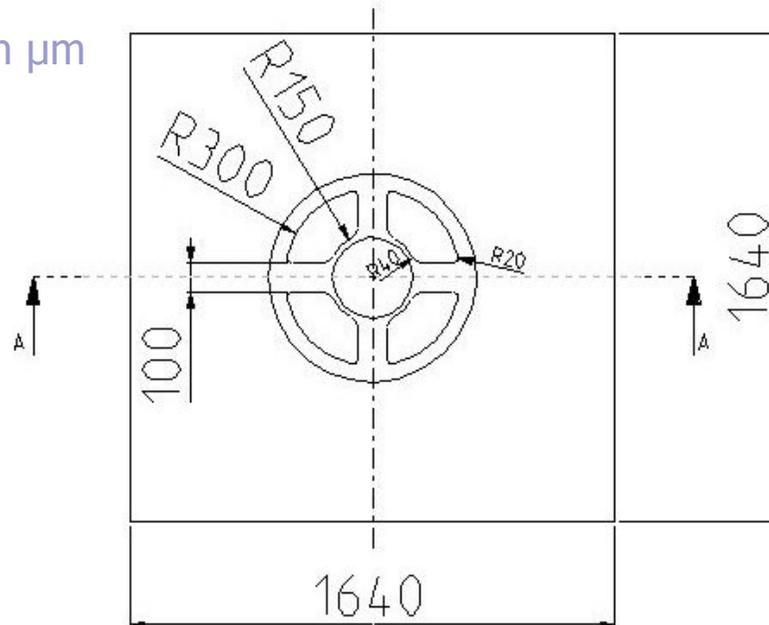
Sezione del modello 3D del sensore

Il sensore è basato sulla trasduzione piezoresistiva ottenuta impiantando dei piezoresistori nelle braccia della struttura flessibile

Dimensioni del sensore



Dimensioni in μm



- Forma a croce, quattro braccia perpendicolari - alta sensibilità alle forze tangenziali
- Cilindro centrale per trasferire il carico alle braccia - blocco di silicio cilindrico integrato totalmente col resto della struttura

Calcolo dei carichi

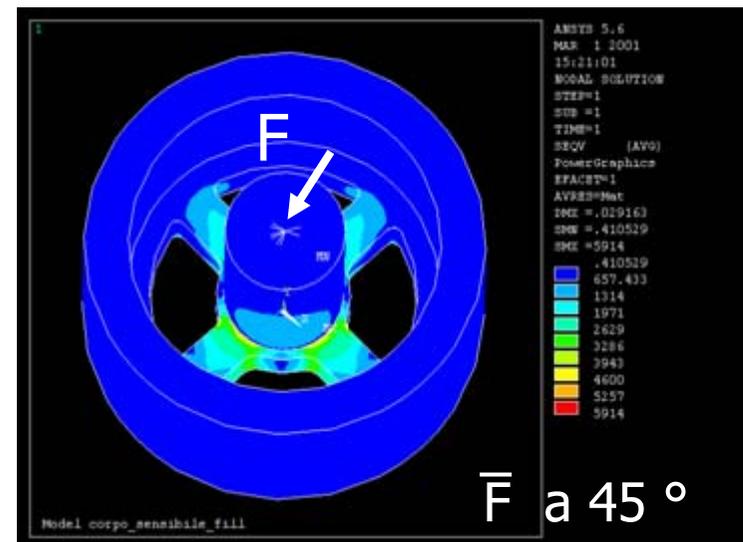
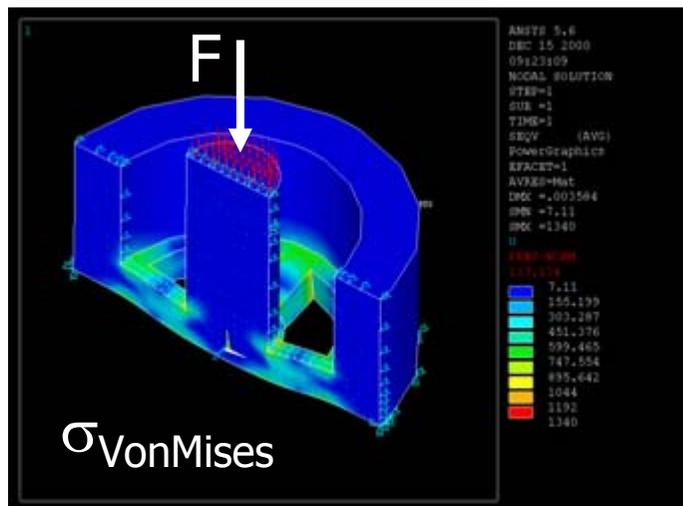
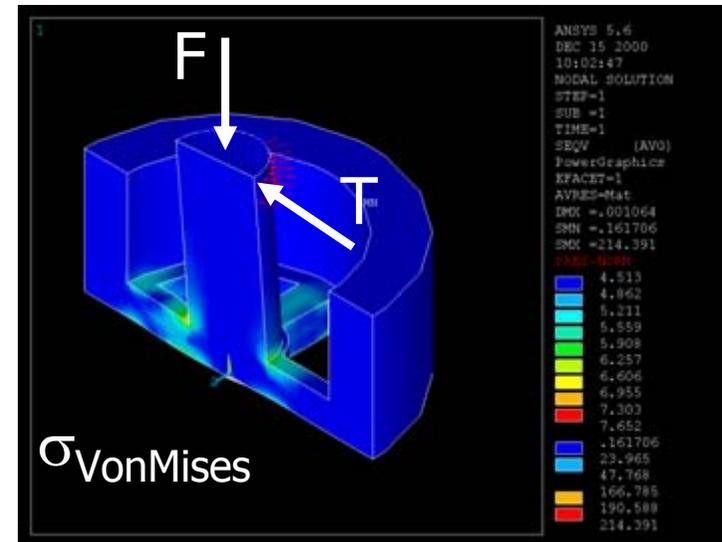
Carichi di lavoro normale e tangenziale

$$F=0.26 \text{ N}$$

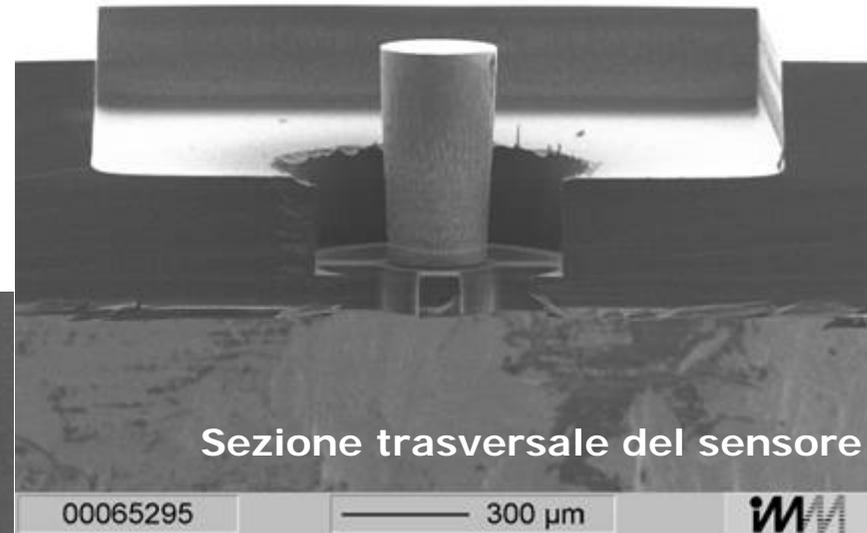
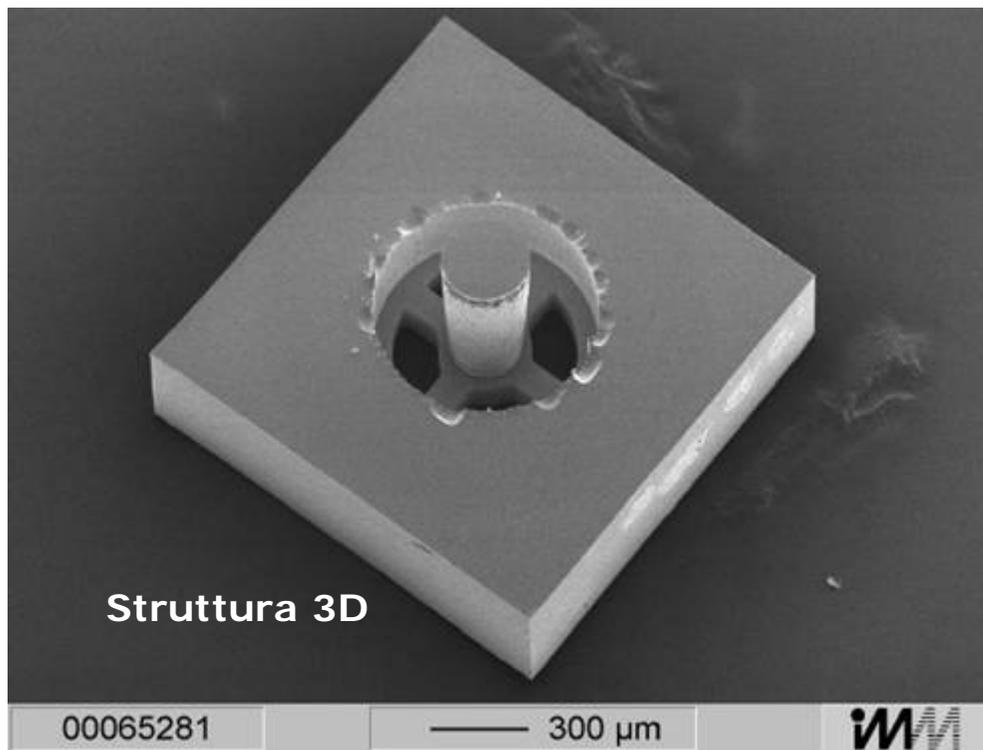
$$T=0.21 \text{ N}$$

Carico massimo

$$F=7.85 \text{ N}$$



Struttura del sensore



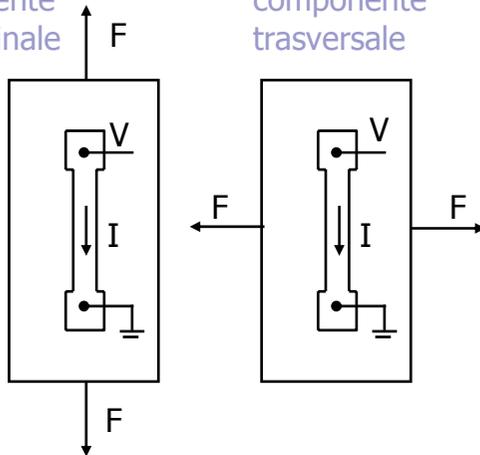
Piezoresistori

$$G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = 1 + 2\nu + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi_l \sigma_l + \pi_t \sigma_t$$

componente
longitudinale

componente
trasversale



Nei semiconduttori $1+2\nu$ trascurabile

	π_{11}	π_{12}	π_{44}
silicio p (7.8 Ω cm)	6.6	-1.1	138.1 (10^{-12} N/m ²)

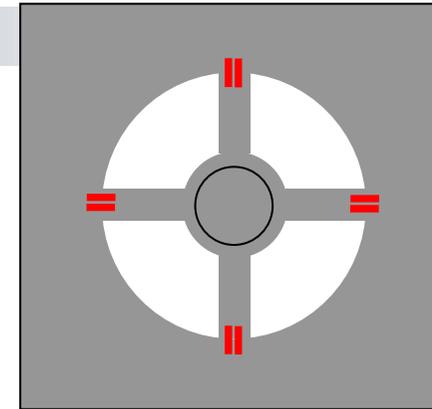
Nella direzione $\langle 110 \rangle$

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\pi_{44}}{2} (\sigma_l - \sigma_t)$$

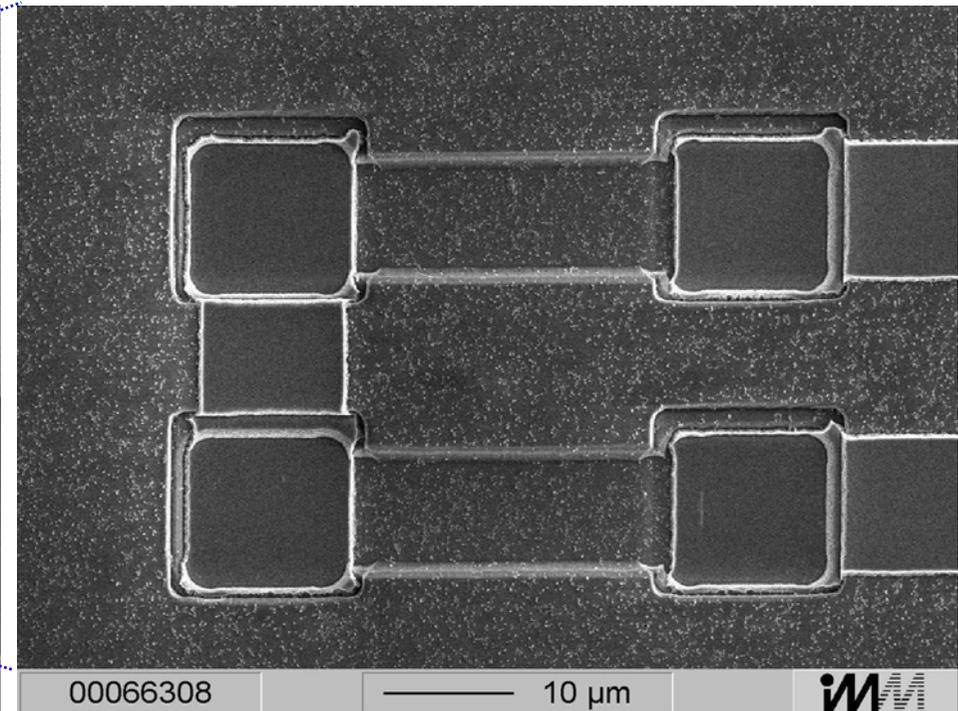
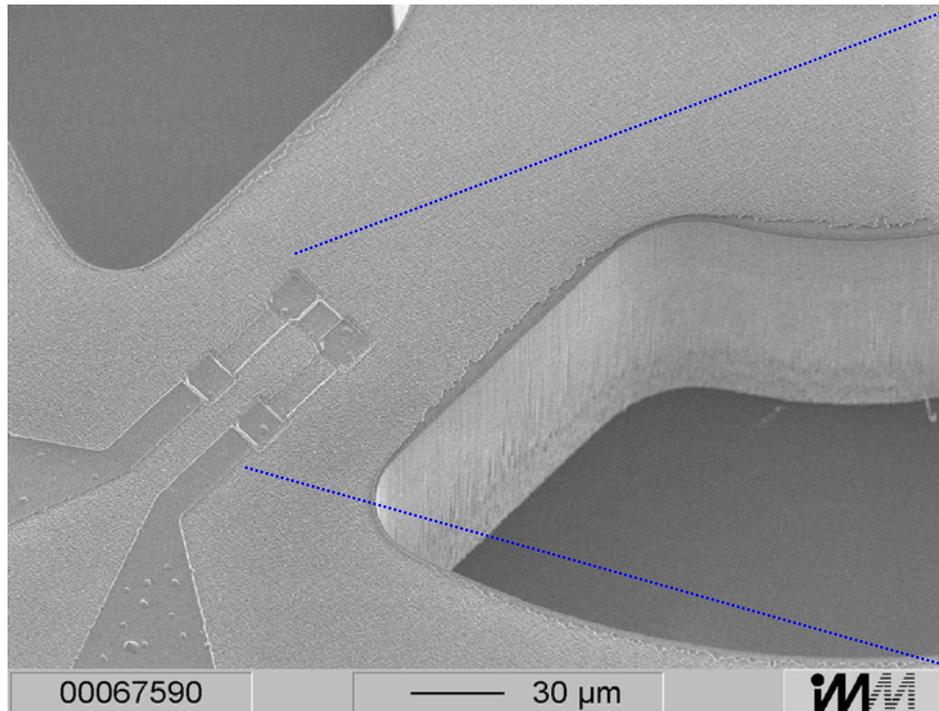
Se $\sigma_t \ll \sigma_l \Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \pi_l \sigma_l \approx \frac{\pi_{44}}{2} \sigma_l$

Piezoresistori

$$G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = \cancel{1+2\nu} + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$
$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta\rho}{\rho} \approx \frac{\pi}{2} \sigma_l$$



Nei semiconduttori $1+2\nu$ trascurabile



◆ $\Delta R/R$: the matrix of sensor piezoresistors fractional change in resistance

◆ F : matrix of sensor loads, in Newton

◆ K : linear transformation determined using the Moore-Penrose least-squares error solution

◆ S_E : *sensitivity matrix*, Moore-Penrose pseudoinverse of matrix K

$$F = K \frac{\Delta R}{R}$$

$$K = \begin{pmatrix} -1.71 & 15.65 & -8.57 & -16.70 \\ -16.75 & 2.83 & 11.75 & 14.97 \\ 3.18 & 5.86 & 20.78 & 33.81 \end{pmatrix} N$$

$$S_E = \begin{pmatrix} 0.0006 & -0.0540 & 0.0260 \\ 0.0540 & -0.0011 & 0.0260 \\ -0.0007 & 0.0077 & 0.0091 \\ -0.0090 & 0.0005 & 0.0170 \end{pmatrix} N^{-1}$$

◆ Applied load sets are :

◆ increasing loads from 0.5 N to 2.5 N in normal direction;

◆ increasing loads from 0.1 N to 0.4 N in two shear directions that are parallel to the tethers axes and perpendicular to each other.

◆ The maximum errors of the sensor due to nonlinearity when the least-squares transformation K is applied are 7mN or 0.28% for the normal component of the force in the calibrated range and 10mN or 2.5% for the two shear components.

$$S_z = \max_{i=1..4} \left(\left| \frac{(\Delta R / R)_i}{F_z} \right|_{F_x=F_y=0} \right) = 0.026 N^{-1}$$

$$S_x = \max_{i=1..4} \left(\left| \frac{(\Delta R / R)_i}{F_x} \right|_{F_y=F_z=0} \right) = S_y = \max_{i=1..4} \left(\left| \frac{(\Delta R / R)_i}{F_y} \right|_{F_x=F_z=0} \right) = 0.054 N^{-1}$$

Piezoresistori

Alta sensibilità se:

- ❑ posizionamento al centro delle braccia nell'area a cavallo della variazione di sezione
- ❑ sottili
- ❑ orientazione <110>

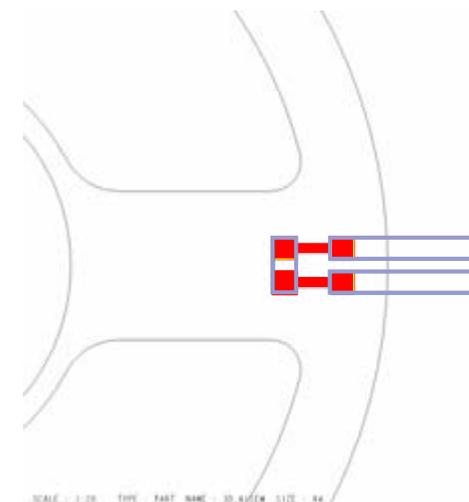
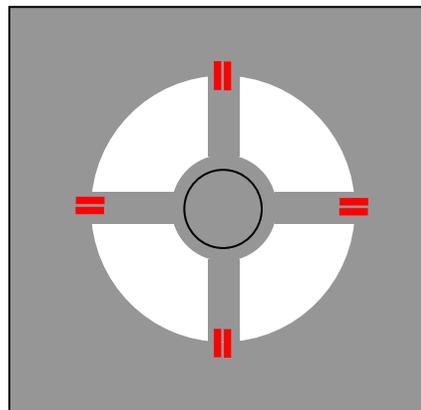
Dimensionamento: compromesso tra tecnologia, sensibilità e potenza dissipata

$R = \frac{V_{IN}}{2I}$	$V_{IN} = 3.3 \text{ V}$	$l/w = 5$
$R = \rho_{\square} \frac{l}{w}$	$I = 3.3 \text{ mA}$	$\rho_{\square} = 100 \ \Omega$
	$P = 5 \text{ mW}$	$R = 500 \ \Omega$

più il piezoresistore è piccolo, più è sensibile e più è critico l'allineamento

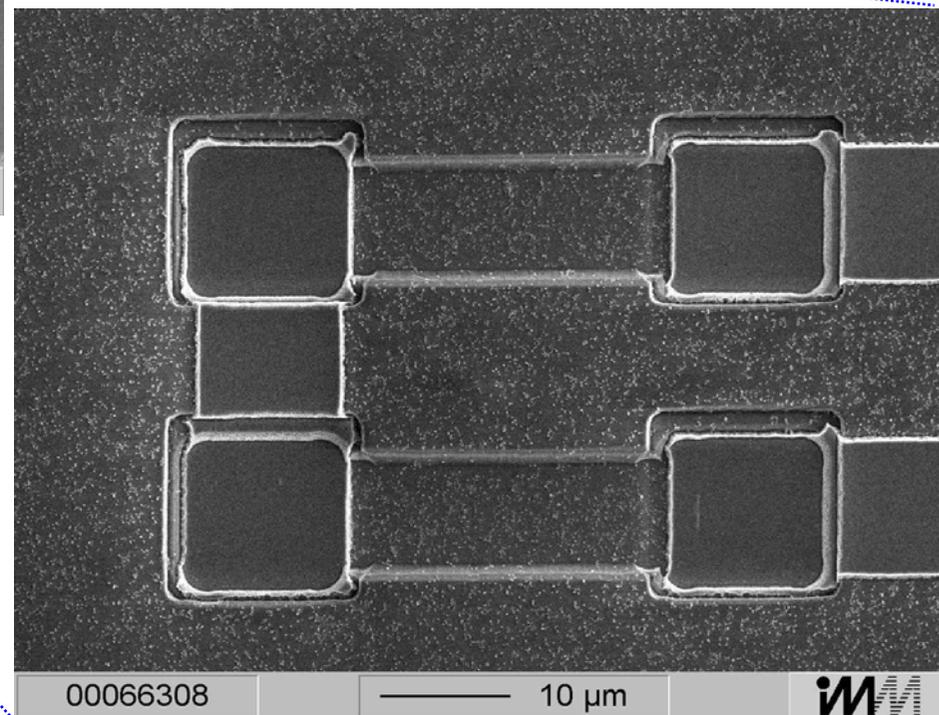
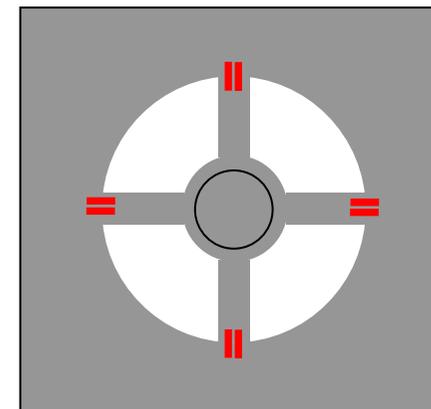
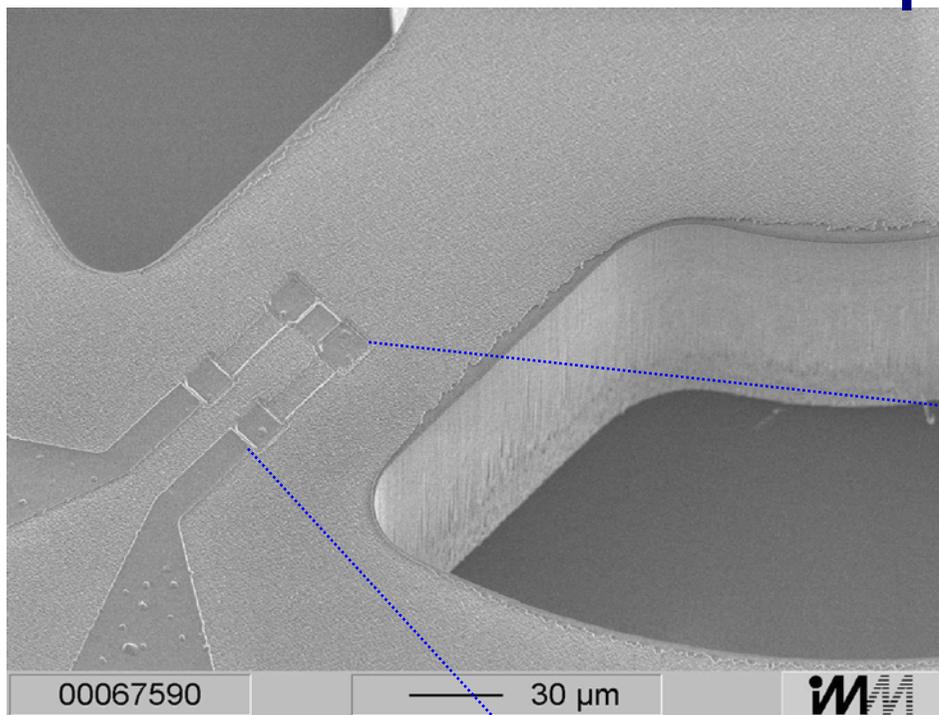
Dimensioni desiderate

	w	l	w	l
Doppia barra			6 μm	15 μm
Doppia barra			8 μm	20 μm
Doppia barra			10 μm	25 μm
Singola barra			6 μm	30 μm

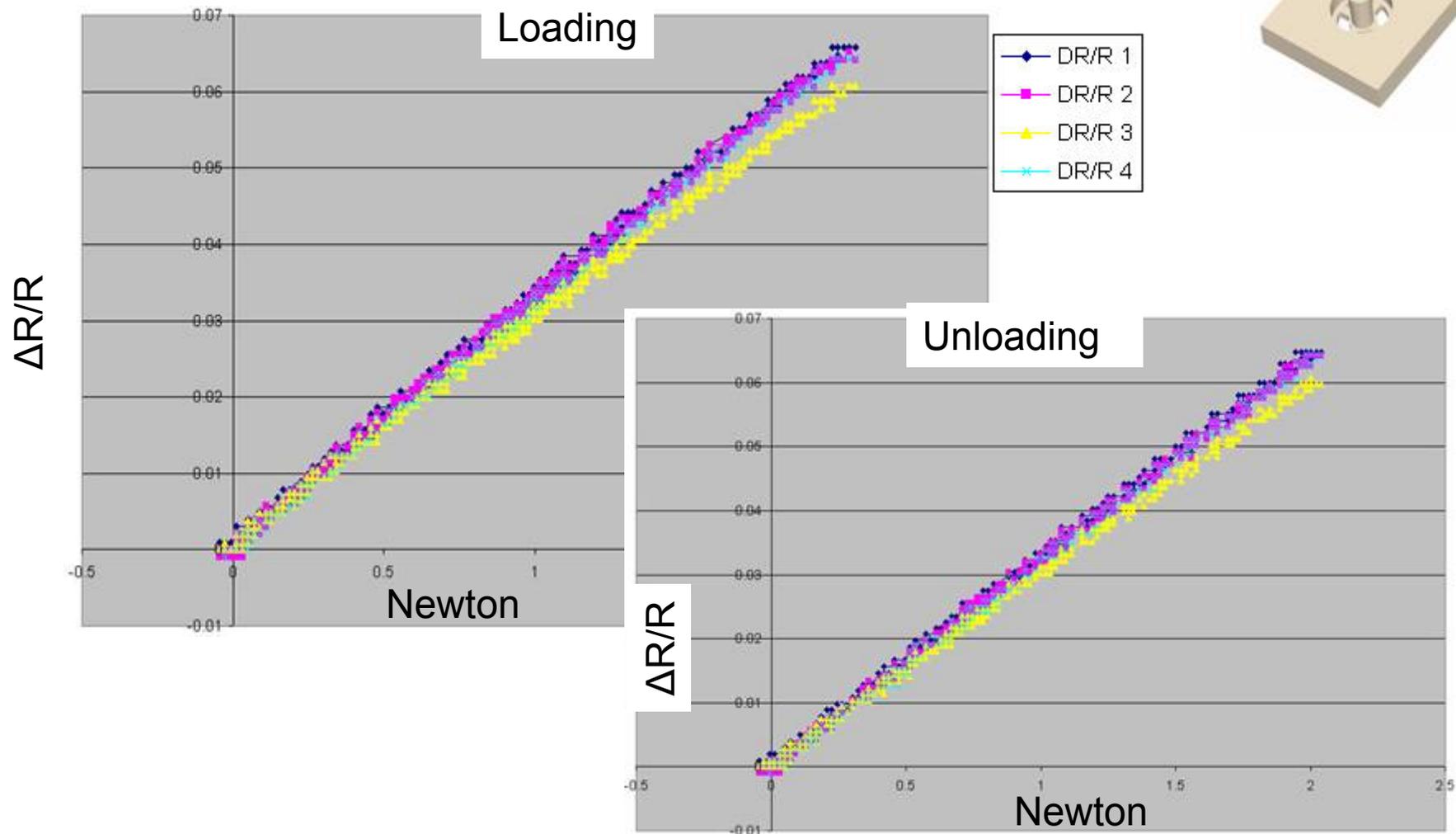


Spessore desiderato: 500 nm

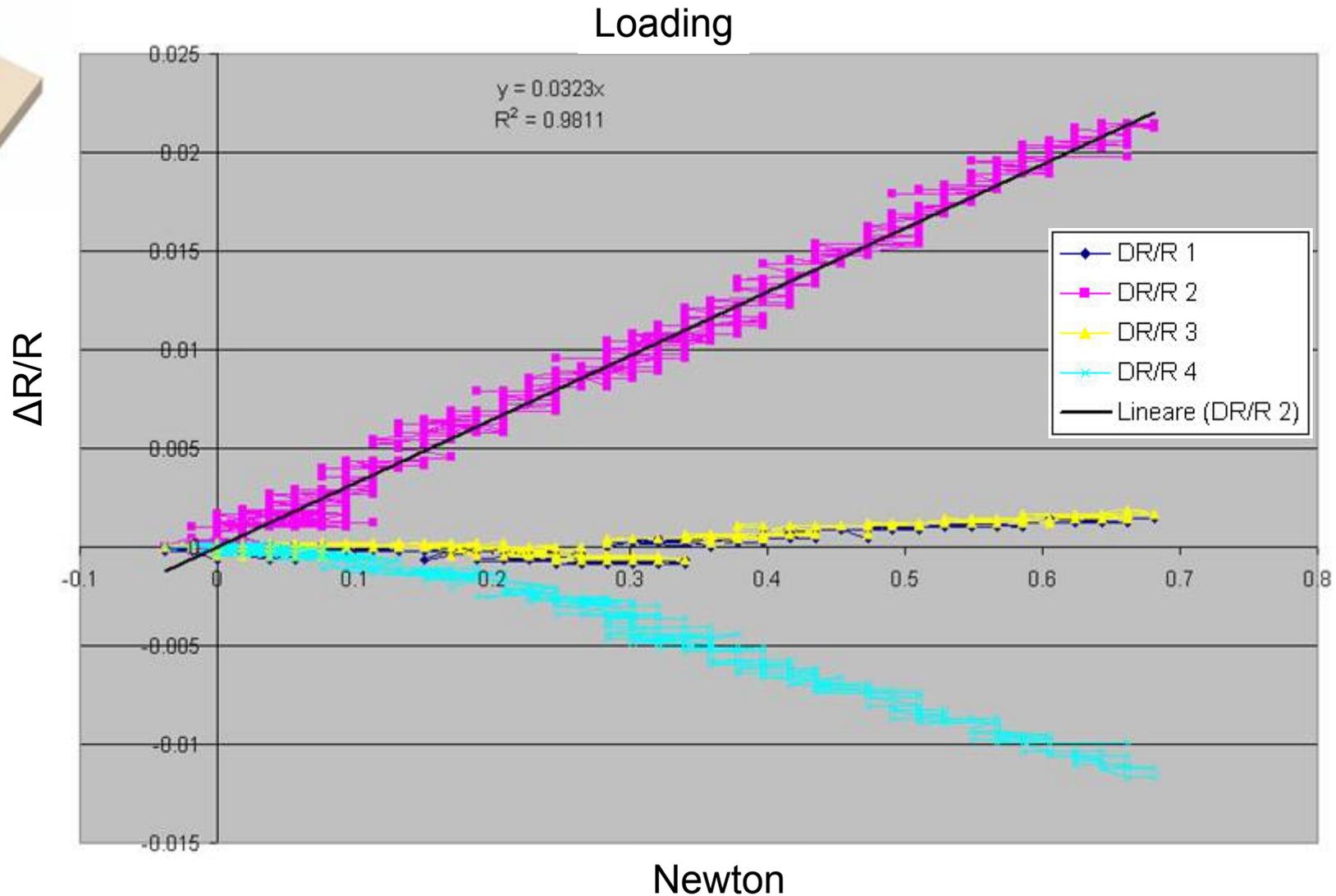
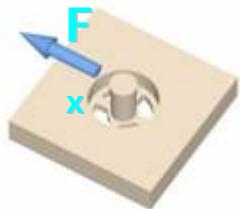
Piezoresistori impiantati



Risposta $\Delta R/R$ dei 4 piezoresistori rispetto a una forza normale

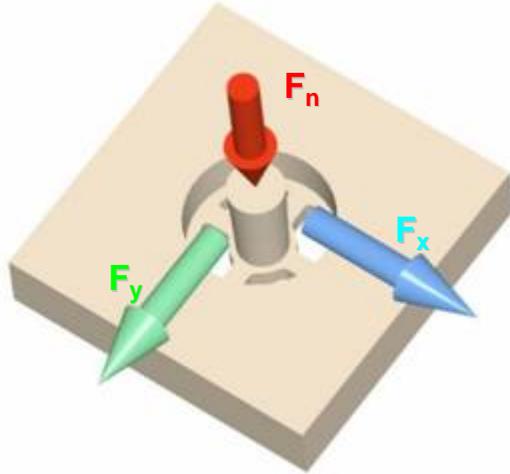


Risposta $\Delta R/R$ dei 4 piezoresistori rispetto a una forza tangenziale



Misura della forza

$$F = K \frac{\Delta R}{R}$$



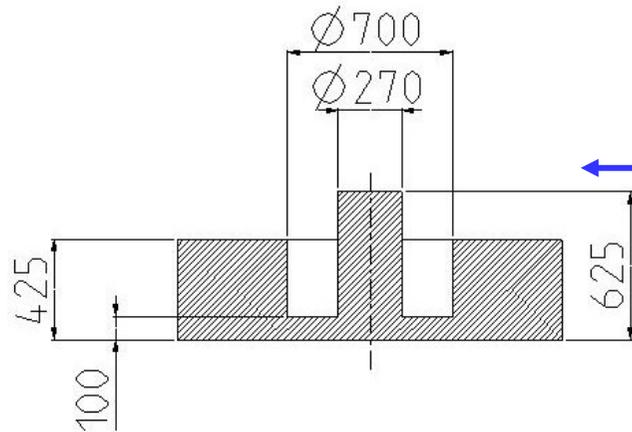
F_n forza normale
 F_x e F_y componenti tangenziali

Procedura di calibrazione:

- forze crescenti da 0.5 N a 2.5 N nella direzione normale;
- forze crescenti da 0.1 N to 0.4 N in due direzioni tangenziali, perpendicolari tra di loro.

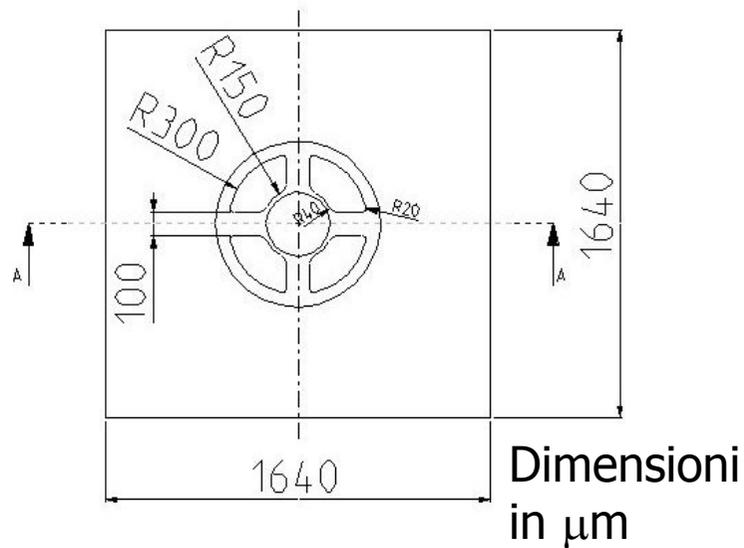
$$K = \begin{pmatrix} -1.71 & 15.65 & -8.57 & -16.70 \\ -16.75 & 2.83 & 11.75 & 14.97 \\ 3.18 & 5.86 & 20.78 & 33.81 \end{pmatrix} N$$

Dimensioni finali

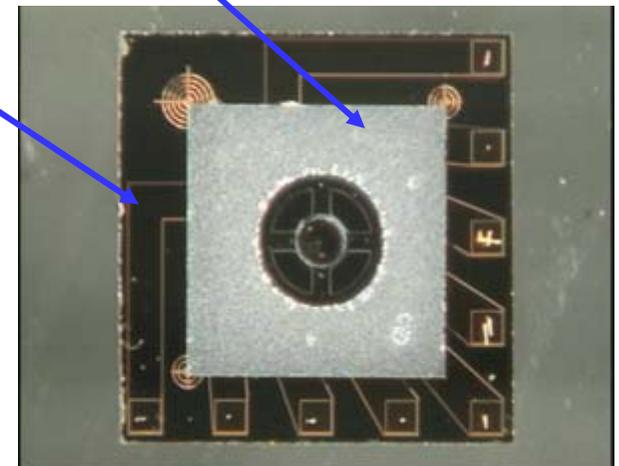


← Chip A (Sensor Chip):
1,5 x 1,5 mm

Chip B (Carrier Chip):
2,3 x 2,3 mm

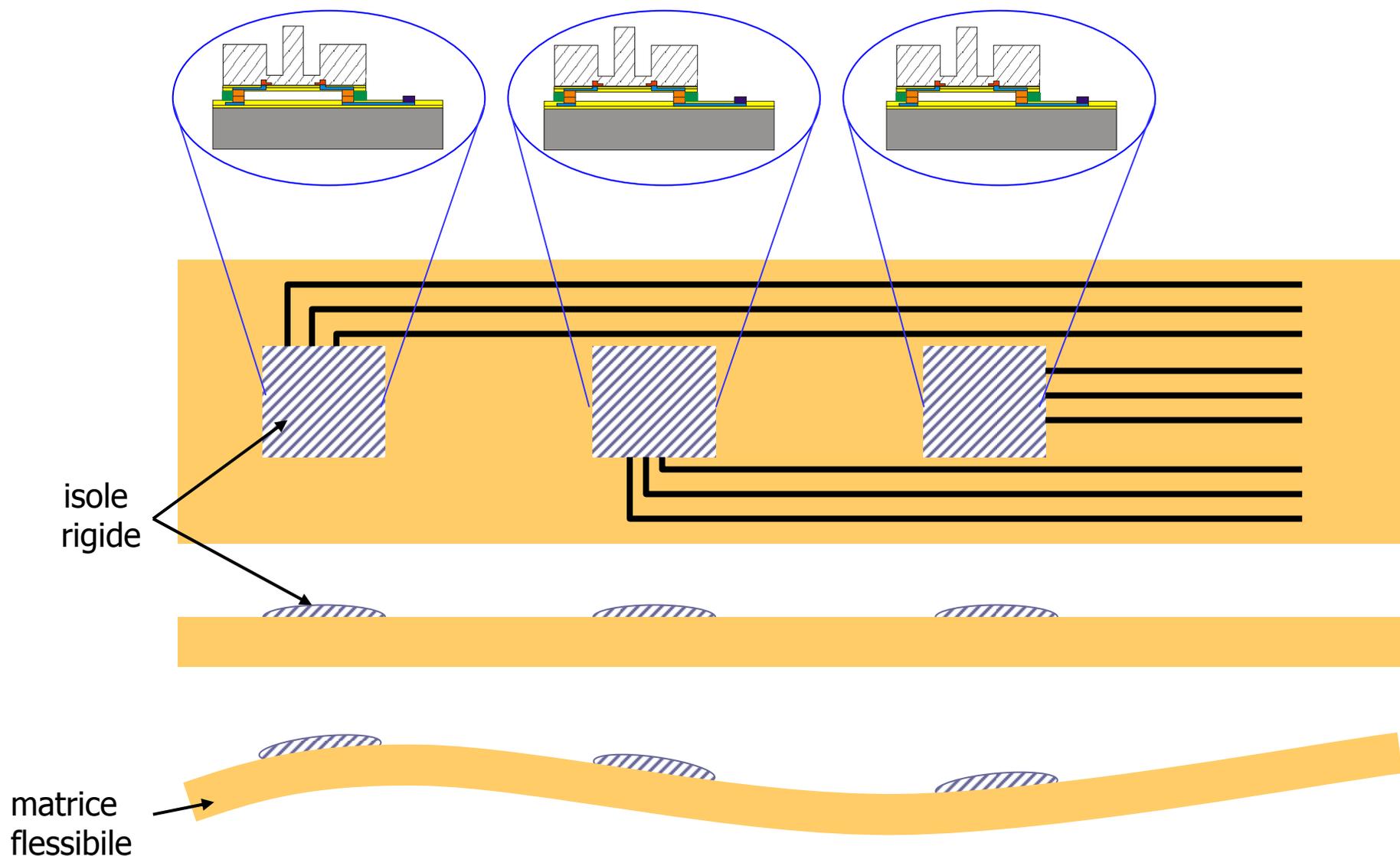


Dimensioni
in μm

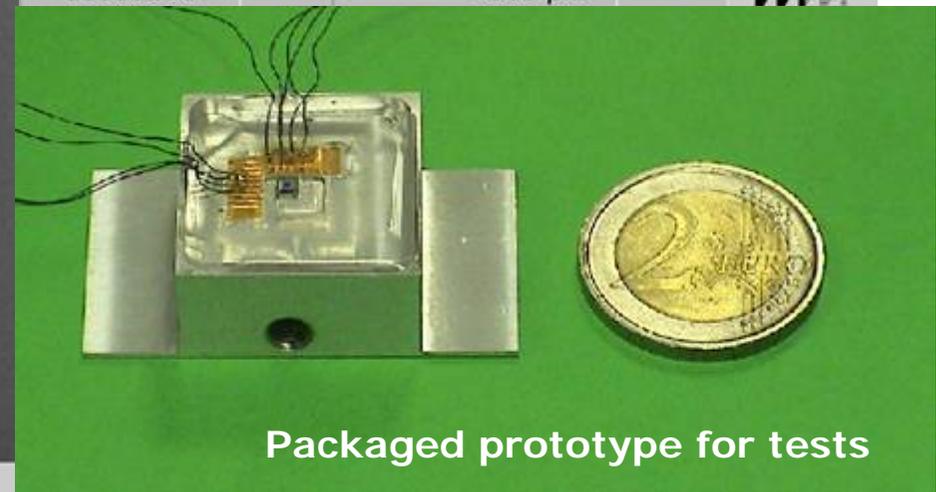
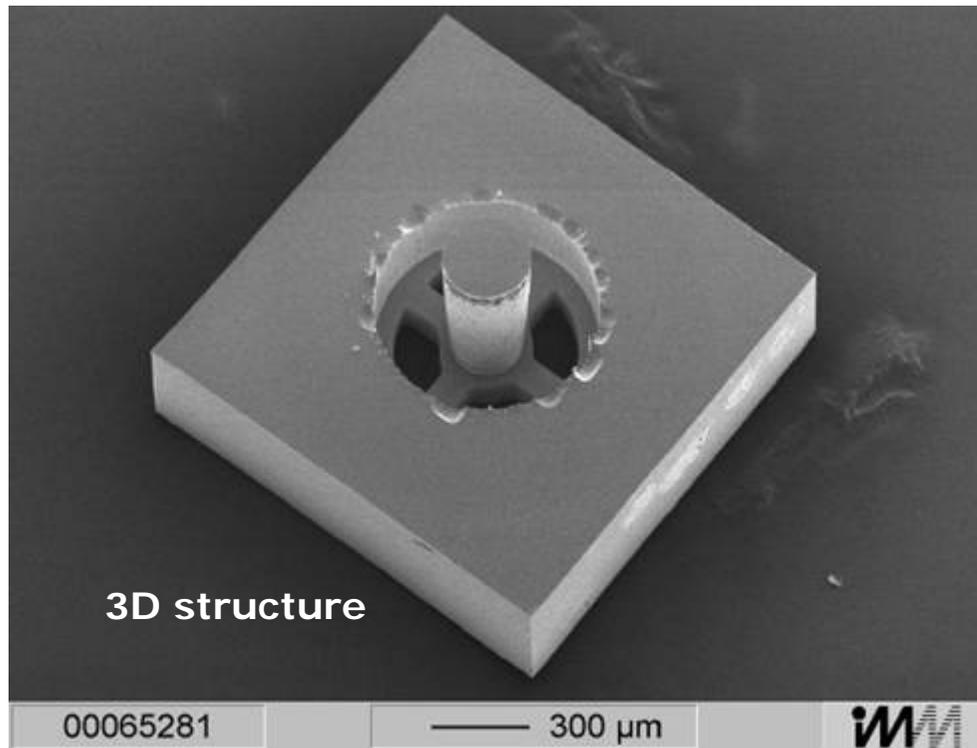
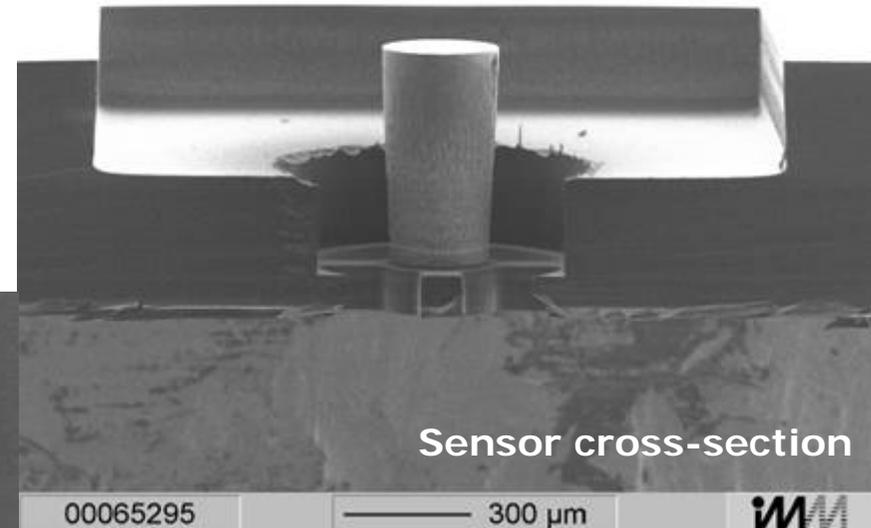
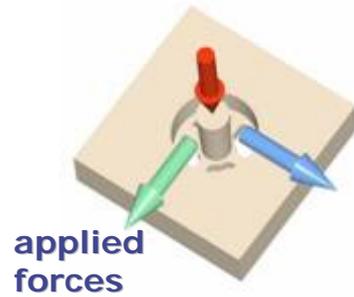


Dimensioni finali del sensore:
2300 μm x 2300 μm x 1300 μm

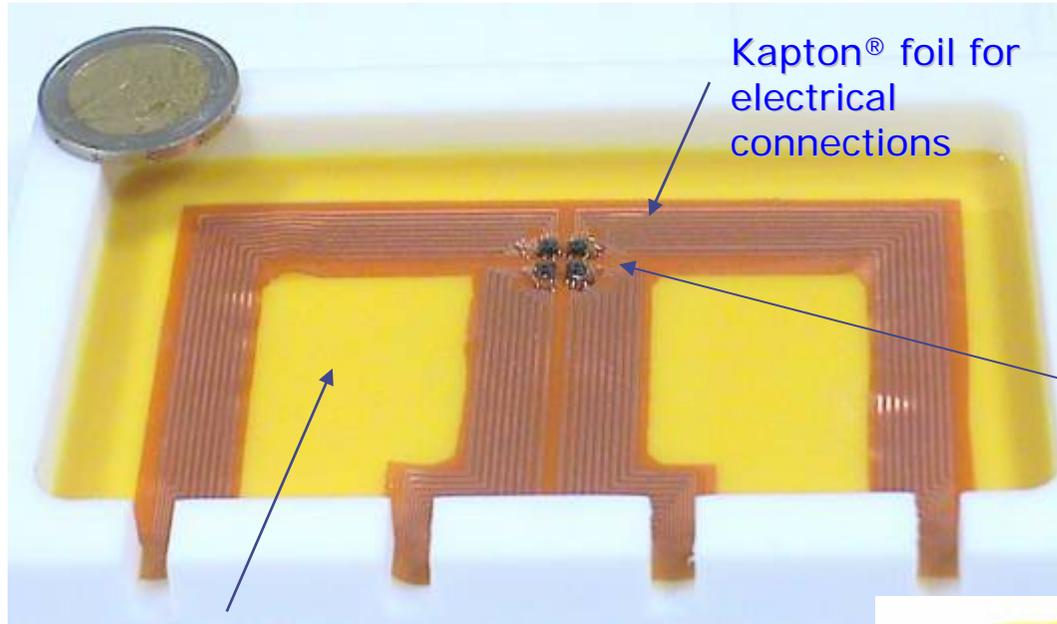
Possibile integrazione su una pelle flessibile



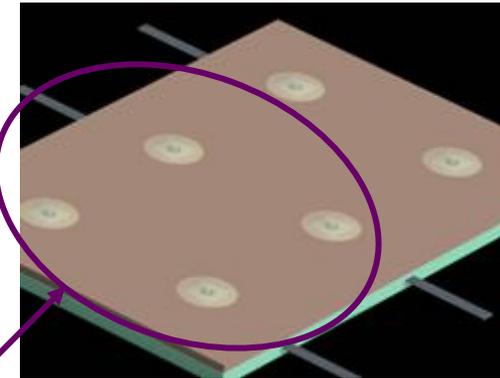
Work in progress for development of a smart skin



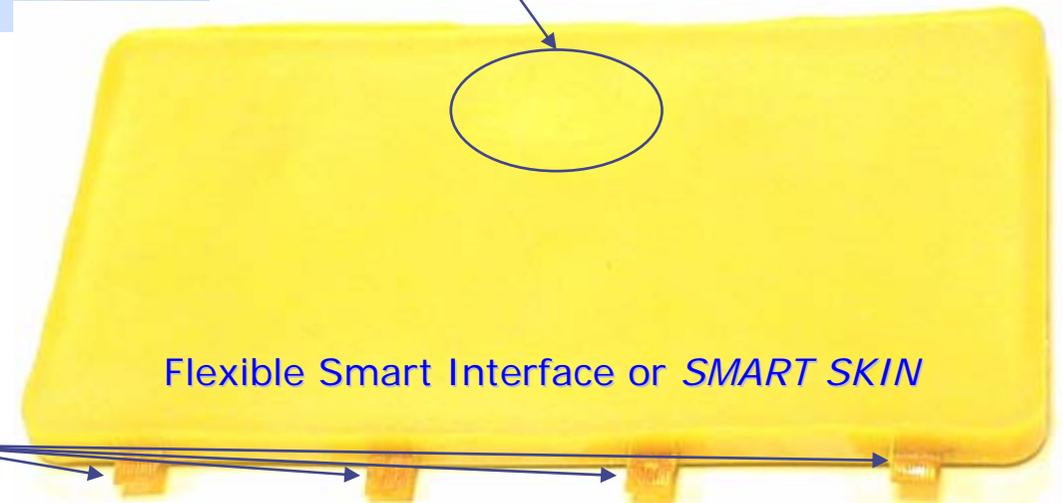
Work in progress for development of a smart skin



Soft polyurethane for circuit embedding



2 x 2 SENSOR ARRAY



Electrical connections to the conditioning electronics



Conclusioni sugli esempi di tecnologie piezoresistive per sensori tattili in biorobotica

Le tecnologie piezoresistive, come utilizzate negli esempi, permettono di misurare:

- a livello di organo sensoriale (polpastrello tattile):
 - la forza applicata sul polpastrello
 - gli eventi di 'controllo tattile'
 - il contatto con l'oggetto
 - il contatto dell'oggetto con altri oggetti
- a livello di sensore:
 - la forza applicata su un'area di 2,3 x 2,3 mm

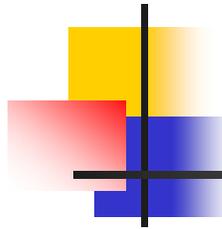


Sommario della lezione

- Principali tecnologie per la realizzazione di sensori tattili artificiali:
 - principi di funzionamento e relazioni matematiche
 - esempi di realizzazione di sensori tattili
- Esempio di progettazione biomeccatronica di un sensore tattile per una mano robotica
- **Esplorazione tattile**

Riferimenti bibliografici:

Russel, "Robot Tactile Sensing", Prentice Hall



Percezione Tattile Attiva

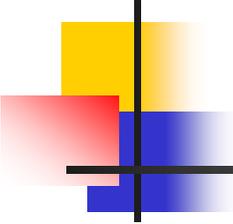
Utilizzo di procedure di esplorazione attiva per il rilevamento dei parametri di interesse

- **PRIMITIVE TATTILI:** proprietà degli oggetti che possono essere dedotte direttamente dai dati sensoriali o mediante semplici procedure di misura
- **CARATTERISTICHE TATTILI:** proprietà degli oggetti che richiedono una ricerca guidata per essere individuate
- **PROCEDURE ESPLORATIVE:** procedure di ricerca guidata per l'individuazione di caratteristiche tattili

Elaborazione tattile

Table 11.1 Tactile properties which can be directly inferred from sensor data

Tactile primitives					
Mechanical behavior	Gross characteristics	Surface shape	Thermal	Electrical behavior	Groupings
Compliance	Size	Corner	Temperature	Electrical conductivity	Examples Parameters to be measured
Resilience	Mass	Edge	Thermal conductivity	Contact potential	
Viscosity		Surface normal	Thermal diffusivity		
✓	✓				Forces and torques transmitted between gripper and object
		✓			Image of area of contact between gripper and object
✓	✓	✓			Configuration of robot gripper
			✓		Thermal
				✓	Electrical

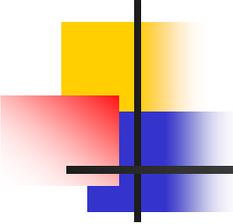


Elaborazione tattile

CEDEVOLEZZA: misura di quanto un materiale resiste all'applicazione di una forza

1. Premi fino ad applicare una forza F
2. Memorizza la posizione corrente come $D1$
3. Premi ancora fino ad applicare una forza $2F$
4. Memorizza la posizione corrente come $D2$

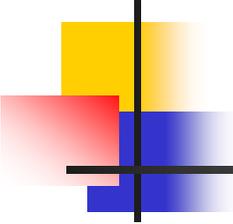
La distanza tra $D1$ e $D2$ è una misura della cedevolezza



Elaborazione tattile

ELASTICITA': indicazione di quanto un materiale ritorna alla forma originaria dopo essere stato deformato dall'applicazione di una forza

1. Premi fino ad applicare una forza F
 2. Memorizza la posizione corrente come $D1$
 3. Premi ancora fino ad applicare una forza $2F$
 4. Memorizza la posizione corrente come $D2$
 5. Riduci la pressione fino ad una forza F
 6. Memorizza la posizione corrente come $D3$
- $(D2 - D3)/(D2 - D1)$ è una misura dell'elasticità



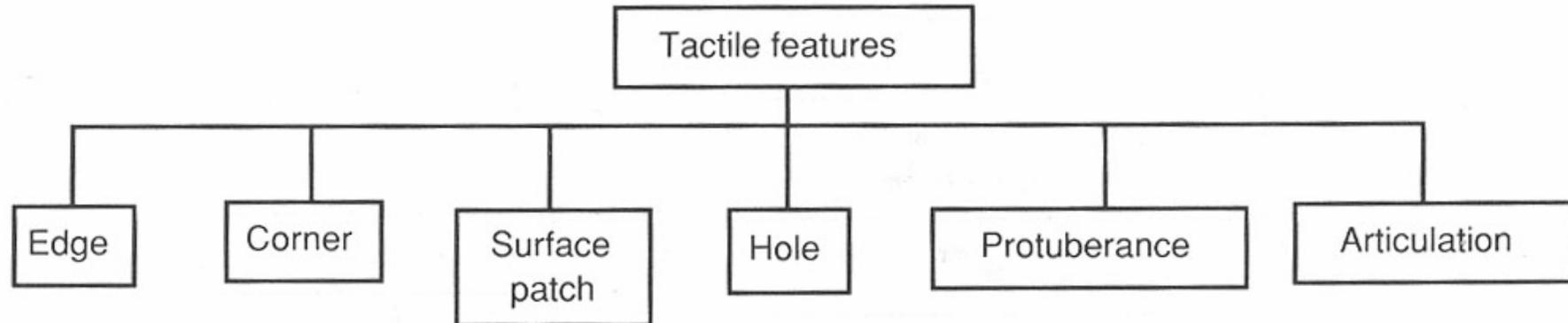
Elaborazione tattile

VISCOSITA': deformazione del materiale nel tempo, risultante dall'applicazione di una forza costante

1. Premi fino ad applicare una forza F
2. Memorizza la posizione corrente come $D1$
3. Attendi per un tempo prefissato
4. Memorizza la posizione corrente come $D2$

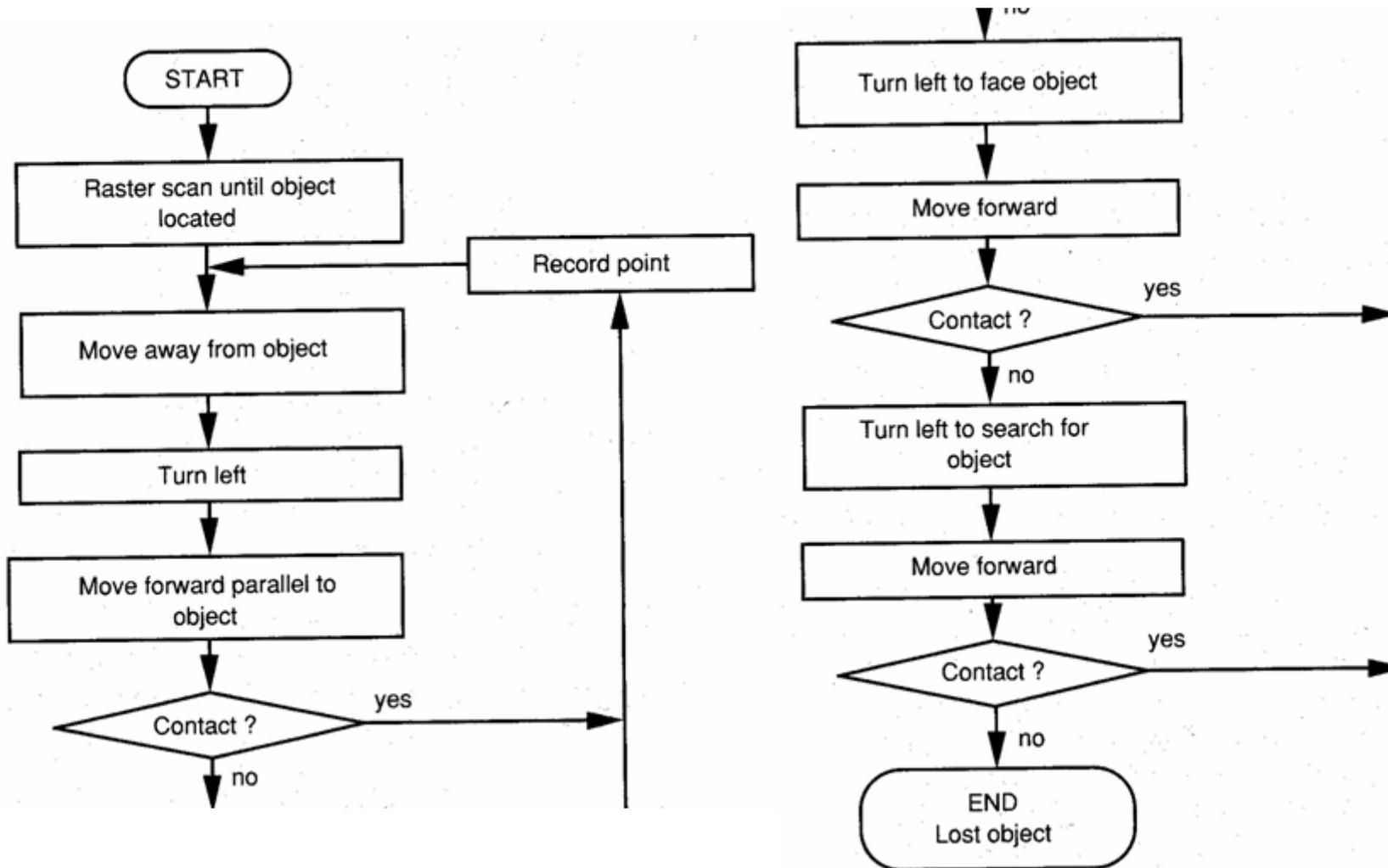
$D2 - D1$ è una misura della viscosità

Caratteristiche tattili

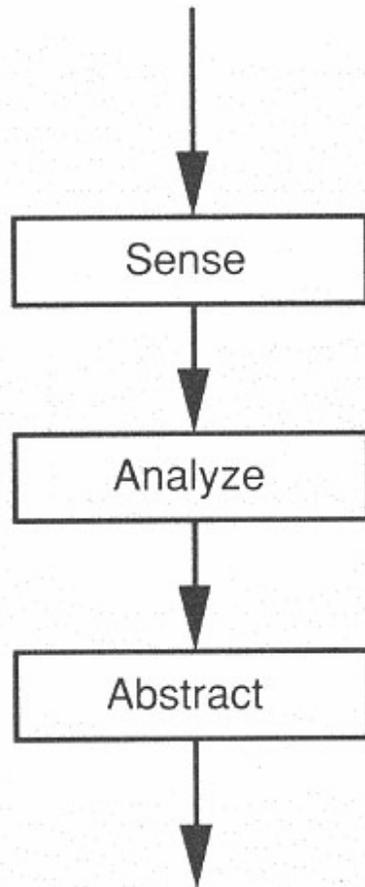


Ulteriori caratteristiche tattili di un oggetto possono essere ottenute mediante una esplorazione attiva condotta tramite opportuni algoritmi che prevedono lo spostamento del sensore (o dei sensori) in un intorno dell'oggetto alla ricerca delle "sensazioni" che permettano una classificazione

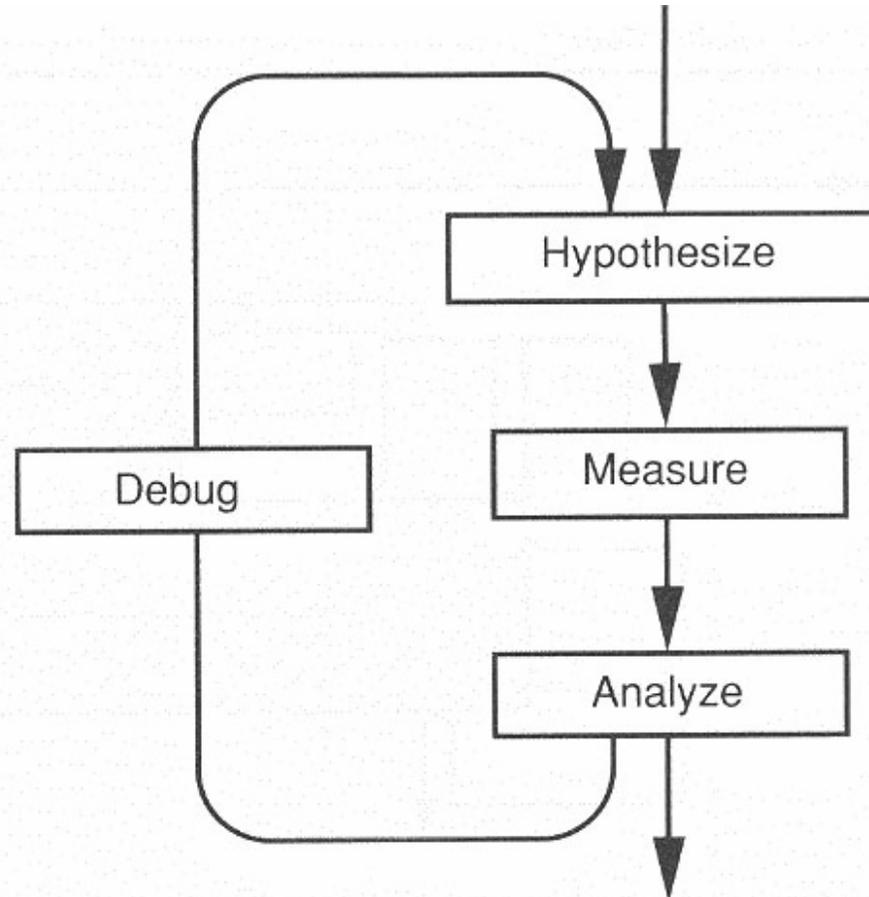
Elaborazione tattile: esempio di algoritmo di esplorazione della forma di un oggetto



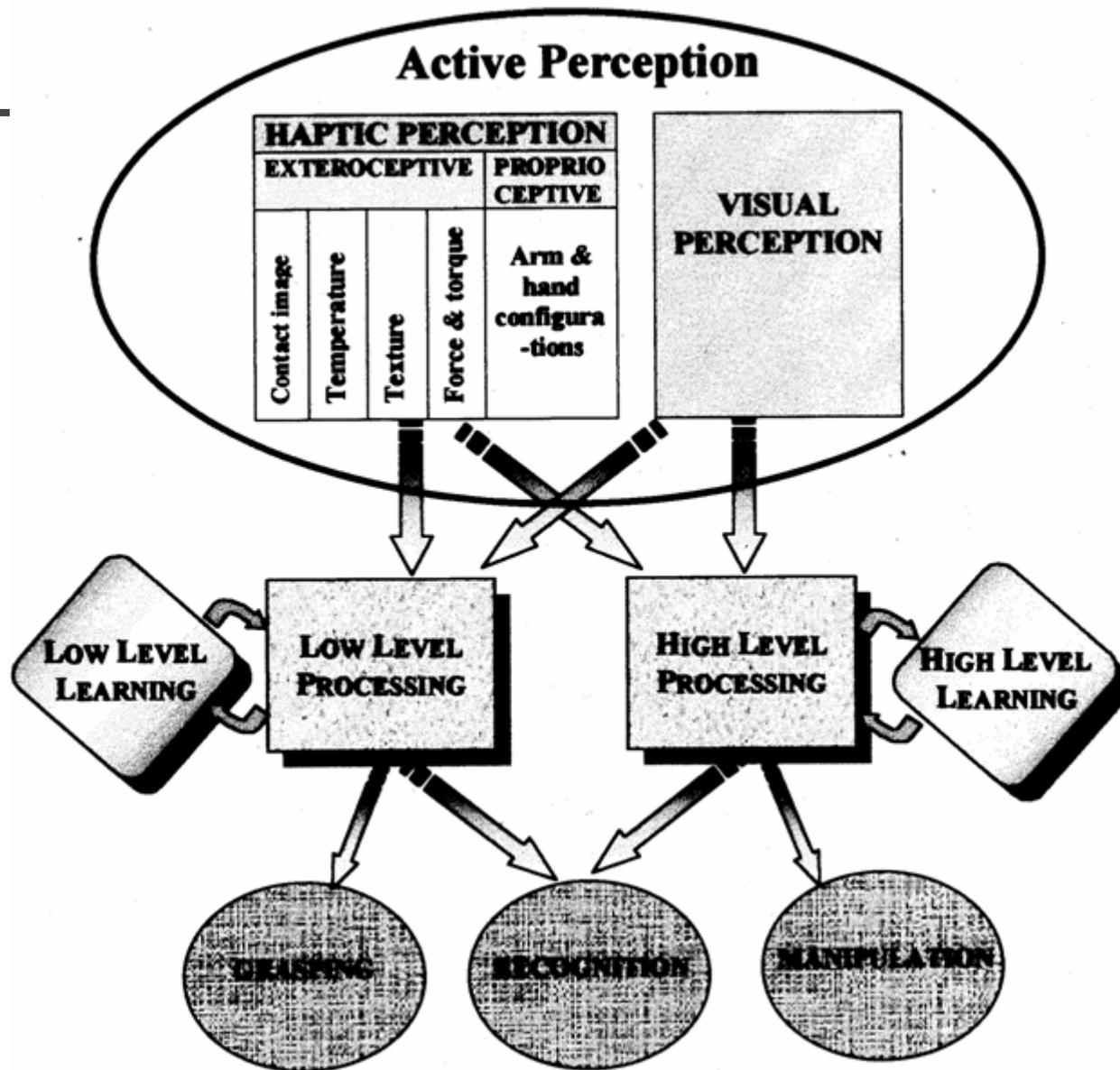
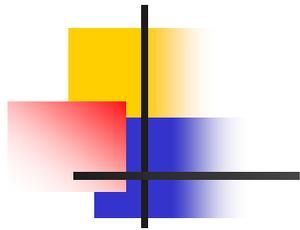
Riconoscimento



(a) Data-driven object recognition



(b) Knowledge-driven object recognition

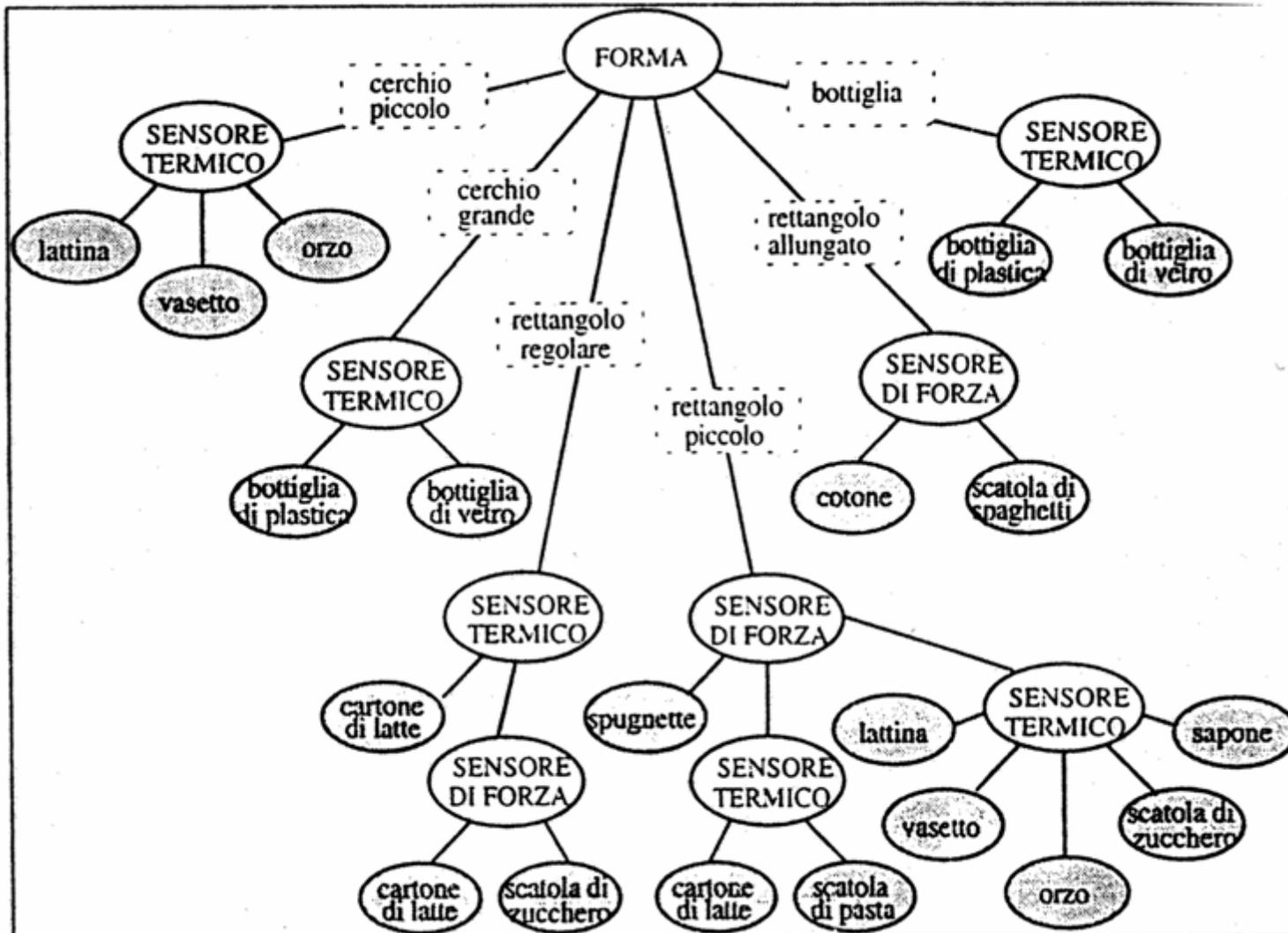


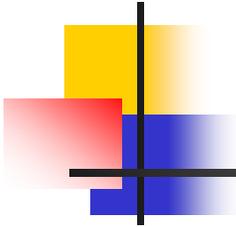
Un esempio di riconoscimento basato su proprietà tattili



Questi oggetti sono stati divisi in classi mediante aggregazione di caratteristiche comuni come forma, materiali, consistenza

Riconoscimento: albero delle ipotesi





Riconoscimento: esempio

